

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7692828号
(P7692828)

(45)発行日 令和7年6月16日(2025.6.16)

(24)登録日 令和7年6月6日(2025.6.6)

(51)国際特許分類		F I		
H 1 0 B	12/00 (2023.01)	H 1 0 B	12/00	8 0 1
H 1 0 B	41/70 (2023.01)	H 1 0 B	12/00	6 2 1
H 1 0 D	86/40 (2025.01)	H 1 0 B	12/00	6 7 1 C
H 1 0 D	86/60 (2025.01)	H 1 0 B	12/00	6 7 1 Z
		H 1 0 B	41/70	
請求項の数 5 (全67頁) 最終頁に続く				
(21)出願番号 特願2021-532540(P2021-532540)		(73)特許権者	000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地	
(86)(22)出願日 令和2年6月29日(2020.6.29)		(72)発明者	青木 健 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会 社半導体エネルギー研究所内	
(86)国際出願番号 PCT/IB2020/056106		(72)発明者	黒川 義元 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会 社半導体エネルギー研究所内	
(87)国際公開番号 WO2021/009586		(72)発明者	上妻 宗広 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会 社半導体エネルギー研究所内	
(87)国際公開日 令和3年1月21日(2021.1.21)		(72)発明者	金村 卓郎 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会 社半導体エネルギー研究所内	
審査請求日 令和5年6月8日(2023.6.8)				
(31)優先権主張番号 特願2019-129927(P2019-129927)				
(32)優先日 令和1年7月12日(2019.7.12)				
(33)優先権主張国・地域又は機関 日本国(JP)				

(54)【発明の名称】 半導体装置、電子部品、及び電子機器

(57)【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の積和演算ユニットを有し、
前記複数の積和演算ユニットのそれぞれは、第 1 回路と、前記第 1 回路上に積層された第 2 回路と、を有し、
前記第 2 回路は、マトリクス状に配置された複数のメモリセルを有し、
前記第 1 回路は、前記複数のメモリセルの各列に対応する複数の回路と、積和演算を行う機能とを有し、
前記複数の回路のそれぞれは、対応する列の前記メモリセルに記憶されたデータを読み出す機能を有し、
前記データを読み出す複数の回路のそれぞれは、半導体基板にチャネル形成領域を有する p チャネル型の第 1 トランジスタ、p チャネル型の第 2 トランジスタ、n チャネル型の第 3 トランジスタ及び n チャネル型の第 4 トランジスタと、第 1 インバータ乃至第 3 インバータと、を有し、
前記複数のメモリセルのそれぞれは、チャネル形成領域に金属酸化物を含む第 5 トランジスタを有し、
前記第 1 トランジスタのソース又はドレインの一方は、第 1 の配線と電氣的に接続され、
前記第 1 トランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第 2 トランジスタのソース又はドレインの一方と電氣的に接続され、
前記第 2 トランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第 1 インバータの出力端子

及び前記第 2 インバータの入力端子と電氣的に接続され、

前記第 3 トランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第 1 インバータの出力端子及び前記第 2 インバータの入力端子と電氣的に接続され、

前記第 3 トランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第 4 トランジスタのソース又はドレインの一方と電氣的に接続され、

前記第 4 トランジスタのソース又はドレインの他方は、第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 インバータの入力端子は、第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記第 2 インバータの出力端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記第 3 インバータの入力端子は、第 4 の配線と電氣的に接続され、

前記第 3 インバータの出力端子は、前記第 1 トランジスタのゲートと電氣的に接続され、

前記第 2 トランジスタのゲート及び前記第 3 トランジスタのゲートは、第 5 の配線を介して前記複数のメモリセルの一と電氣的に接続され、

前記第 4 トランジスタのゲートは、前記第 4 の配線と電氣的に接続され、

前記複数の前記積和演算ユニットは、マトリクス状に配置されている、半導体装置。

【請求項 2】

ワード線ドライバ回路と、

ビット線ドライバ回路と、

積和演算ブロックと、を有し、

前記積和演算ブロックは、複数の積和演算ユニットを有し、

前記複数の積和演算ユニットのそれぞれは、第 1 回路と、前記第 1 回路上に積層された第 2 回路と、を有し、

前記第 2 回路は、マトリクス状に配置された複数のメモリセルを有し、

前記第 1 回路は、前記複数のメモリセルの各列に対応する複数の回路と、積和演算を行う機能とを有し、

前記ワード線ドライバ回路と、前記ビット線ドライバ回路とは、前記複数のメモリセルにデータを書き込む機能を有し、

前記複数の回路のそれぞれは、対応する列の前記メモリセルに記憶された前記データを読み出す機能を有し、

前記データを読み出す複数の回路のそれぞれは、半導体基板にチャネル形成領域を有する p チャネル型の第 1 トランジスタ、p チャネル型の第 2 トランジスタ、n チャネル型の第 3 トランジスタ及び n チャネル型の第 4 トランジスタと、第 1 インバータ乃至第 3 インバータと、を有し、

前記複数のメモリセルのそれぞれは、チャネル形成領域に金属酸化物を含む第 5 トランジスタを有し、

前記第 1 トランジスタのソース又はドレインの一方は、第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 トランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第 2 トランジスタのソース又はドレインの一方と電氣的に接続され、

前記第 2 トランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第 1 インバータの出力端子及び前記第 2 インバータの入力端子と電氣的に接続され、

前記第 3 トランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第 1 インバータの出力端子及び前記第 2 インバータの入力端子と電氣的に接続され、

前記第 3 トランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第 4 トランジスタのソース又はドレインの一方と電氣的に接続され、

前記第 4 トランジスタのソース又はドレインの他方は、第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 インバータの入力端子は、第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記第 2 インバータの出力端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記第 3 インバータの入力端子は、第 4 の配線と電氣的に接続され、

前記第 3 インバータの出力端子は、前記第 1 トランジスタのゲートと電氣的に接続され、

前記第 2 トランジスタのゲート及び前記第 3 トランジスタのゲートは、第 5 の配線を介して前記複数のメモリセルの一と電氣的に接続され、

10

20

30

40

50

前記第４トランジスタのゲートは、前記第４の配線と電氣的に接続され、
前記複数の前記積和演算ユニットは、マトリクス状に配置されている、半導体装置。

【請求項３】

請求項１又は請求項２において、
前記金属酸化物は、 In または Zn の少なくとも一方を含む、半導体装置。

【請求項４】

請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の半導体装置を有する、電子部品。

【請求項５】

請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の半導体装置を有する、電子機器。

【発明の詳細な説明】

10

【技術分野】

【０００１】

本発明の一形態は、積和演算回路と記憶装置を有する半導体装置に関する。

【０００２】

本明細書等において、半導体装置とは、半導体特性を利用した装置のことであり、例えば、半導体素子（トランジスタ、ダイオード、フォトダイオード等）を含む回路、同回路を有する装置等を指す。また、本明細書等において、半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般のことであり、例えば、集積回路、集積回路を備えたチップや、パッケージにチップを収納した電子部品、集積回路を備えた電子機器は、半導体装置の一例である。

20

【０００３】

なお、本発明の一形態は、上記の技術分野に限定されない。本明細書等で開示する発明の技術分野は、物、方法、または、製造方法に関するものである。または、本発明の一形態は、プロセス、マシン、マニファクチャ、または、組成物（コンポジション・オブ・マター）に関するものである。

【背景技術】

【０００４】

積和演算は、例えば、ニューラルネットワークを利用した計算において多く用いられる。ニューラルネットワークは、ニューロンとシナプスで構成される神経回路網を模した回路構成を有している。それぞれのニューロンには複数のデータが入力され、それぞれのデータは結合の強度を表す「重み係数」と掛け合わされ、その結果が足しあわされる。このようにして得られた積和演算の結果が閾値を超えたとき、ニューロンはハイレベルの信号を出力し、この現象は「発火」と呼ばれている。

30

【０００５】

神経回路網をモデルにした情報処理システムであるニューラルネットワークを利用することで、従来のノイマン型コンピュータを利用した情報処理よりも高性能なコンピュータが実現できると期待されており、近年、ニューラルネットワークを構築する種々の研究が進められている。

【０００６】

ニューラルネットワークは、例えば、画像認識に利用される。画像認識では、画像データにフィルタのパラメータを掛けて足し合わせ、またスライドさせて同じ動作を繰り返すことで画像データの特徴を検出する畳み込み演算が行われている。畳み込み演算は複数回行われ、最初の方の畳み込み演算では画像のエッジなどを検出し、後の方の畳み込み演算では画像の形やパターンなど複雑な特徴を検出する。

40

【０００７】

特許文献１には、CPU (Central Processing Unit) やGPU (Graphics Processing Unit) などのプロセッサを用いて、ニューラルネットワークによる機械学習を行い、手書き文字の認識を行う例が開示されている。

【０００８】

また、近年、トランジスタのチャネル形成領域に、酸化物半導体または金属酸化物を有す

50

るトランジスタ（酸化物半導体トランジスタ、OS（Oxide Semiconductor）トランジスタ、ともいう）が注目されている。OSTランジスタは、トランジスタがオフ状態にあるときのドレイン電流（オフ電流、ともいう）が非常に小さい（例えば、非特許文献1、2、参照）ため、OSTランジスタをDRAMのメモリセルに用いることで、容量素子に蓄積した電荷を長時間保持することができる。

【0009】

特許文献2には、駆動回路や制御回路などの周辺回路を形成した半導体基板上に、OSTランジスタを用いた複数のメモリセルを有する半導体装置、および、DRAM（Dynamic Random Access Memory）のメモリセルにOSTランジスタを適用した例が、開示されている。例えば、単結晶シリコン基板に形成されたSiトランジスタを用いて周辺回路を構成し、その上方にOSTランジスタを用いたメモリセルを積層して設けることで、チップ面積を削減することができる。

10

【0010】

酸化物半導体では、単結晶でも非晶質でもない、CAAC（c-axis aligned crystalline）構造およびnc（nanocrystalline）構造が見出されている（非特許文献1および非特許文献3参照）。非特許文献1および非特許文献3では、CAAC構造を有する酸化物半導体を用いてトランジスタを作製する技術が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

20

【0011】

【文献】特開2005-182785号公報

【文献】特開2012-256820号公報

【非特許文献】

【0012】

【文献】S. Yamazaki et al., "Properties of crystalline In-Ga-Zn-oxide semiconductor and its transistor characteristics," Jpn. J. Appl. Phys., vol. 53, 04ED18 (2014).

【文献】K. Kato et al., "Evaluation of Off-State Current Characteristics of Transistor Using Oxide Semiconductor Material, Indium-Gallium-Zinc Oxide," Jpn. J. Appl. Phys., vol. 51, 021201 (2012).

30

【文献】S. Yamazaki et al., "SID Symposium Digest of Technical Papers", 2012, volume 43, issue 1, p. 183 - 186

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0013】

40

画像認識における画像データとフィルタのパラメータは、それぞれ、ニューラルネットワークにおける、ニューロンに入力される複数のデータと重み係数に相当する。また、画像認識における畳み込み演算では、積和演算が行われている。

【0014】

重み係数は、例えば、学習によって生成される。学習が終わった重み係数は、ニューロンに入力される複数のデータに対して、繰り返し用いられる。そのため、重み係数は、記憶装置への書き込みよりも、積和演算回路への読み出しにおいて、スピードおよび効率的な処理が求められている。

【0015】

本発明の一形態は、積和演算回路と記憶装置を有する半導体装置であって、重み係数の読

50

み出しと積和演算とを、効率よく行うことができる半導体装置を提供することを課題の一つとする。または、本発明の一形態は、積和演算回路と記憶装置を有する半導体装置であって、チップ面積を削減した半導体装置を提供することを課題の一つとする。

【0016】

なお、本発明の一形態は、必ずしも上記の課題の全てを解決する必要はなく、少なくとも一つの課題を解決できるものであればよい。また、上記の課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。これら以外の課題は、明細書、特許請求の範囲、図面などの記載から自ずと明らかになるものであり、明細書、特許請求の範囲、図面などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。

【課題を解決するための手段】

10

【0017】

本発明の一形態は、複数の積和演算ユニットを有する半導体装置である。積和演算ユニットは、第一回路とメモリセルとを有する。第一回路は、半導体基板に形成された第一トランジスタを有し、メモリセルは、チャネル形成領域に金属酸化物を含む第二トランジスタを有する。第二トランジスタは、第一トランジスタの上方に積層して形成され、第一回路は、メモリセルに記憶されたデータを読み出す機能と、積和演算を行う機能とを有する。

【0018】

また、本発明の一形態は、ワード線ドライバ回路と、ビット線ドライバ回路と、積和演算ブロックとを有する半導体装置である。積和演算ブロックは、複数の積和演算ユニットを有し、積和演算ユニットは、第一回路とメモリセルとを有する。第一回路は、半導体基板に形成された第一トランジスタを有し、メモリセルは、チャネル形成領域に金属酸化物を含む第二トランジスタを有する。第二トランジスタは、第一トランジスタの上方に積層して形成され、ワード線ドライバ回路とビット線ドライバ回路は、メモリセルにデータを書き込む機能を有し、第一回路は、メモリセルに記憶されたデータを読み出す機能と、積和演算を行う機能とを有する。

20

【0019】

また、本発明の一形態は、ワード線ドライバ回路と、ビット線ドライバ回路と、積和演算ブロックとを有する半導体装置である。積和演算ブロックは、複数の積和演算ユニットを有し、積和演算ユニットは、第一回路とメモリセルとを有する。ワード線ドライバ回路と、ビット線ドライバ回路と、第一回路は、それぞれ半導体基板に形成された第一トランジスタを有し、メモリセルは、チャネル形成領域に金属酸化物を含む第二トランジスタを有する。第二トランジスタは、第一トランジスタの上方に積層して形成され、ワード線ドライバ回路とビット線ドライバ回路は、メモリセルにデータを書き込む機能を有し、第一回路は、メモリセルに記憶されたデータを読み出す機能と、積和演算を行う機能とを有する。

30

【0020】

また、上記形態において、金属酸化物はInまたはZnの少なくとも一方を含む。

【発明の効果】

【0021】

本発明の一形態により、積和演算回路と記憶装置を有する半導体装置であって、重み係数の読み出しと積和演算とを、効率よく行うことができる半導体装置を提供することができる。または、本発明の一形態により、積和演算回路と記憶装置を有する半導体装置であって、チップ面積を削減した半導体装置を提供することができる。

40

【0022】

なお、本発明の一形態は、必ずしも上記の課題の全てを解決する必要はなく、少なくとも一つの課題を解決できるものであればよい。また、上記の課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。これら以外の課題は、明細書、特許請求の範囲、図面などの記載から自ずと明らかになるものであり、明細書、特許請求の範囲、図面などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【0023】

50

図 1 は、半導体装置の構成例を示す斜視概略図である。

図 2 A は、積和演算ブロックの構成例を示す斜視概略図である。図 2 B は、積和演算ユニットの構成例を示す斜視概略図である。

図 3 は、積和演算ユニットの構成例を示す回路図である。

図 4 A は、回路 1 5 の構成例を示す回路図である。図 4 B は、タイミングチャートである。

図 5 A は、データ信号 X とデータ信号 W のイメージを示す図である。図 5 B は、画像データ P のイメージを示す図である。図 5 C は、フィルタ F のイメージを示す図である。

図 6 は、記憶装置の構成例を示す断面図である。

図 7 A 乃至図 7 C は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

図 8 A は、トランジスタの構造例を示す上面図である。図 8 B、図 8 C は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

10

図 9 A は、トランジスタの構造例を示す上面図である。図 9 B、図 9 C は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

図 10 A は、トランジスタの構造例を示す上面図である。図 10 B、図 10 C は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

図 11 A は、トランジスタの構造例を示す上面図である。図 11 B、図 11 C は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

図 12 A は、トランジスタの構造例を示す上面図である。図 12 B、図 12 C は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

図 13 A は、トランジスタの構造例を示す上面図である。図 13 B、図 13 C は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

20

図 14 A、図 14 B は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

図 15 は、記憶装置の構成例を示す断面図である。

図 16 A、図 16 B は、トランジスタの構造例を示す断面図である。

図 17 A は、IGZO の結晶構造の分類を説明する図である。図 17 B は、CAAC - IGZO 膜の XRD スペクトルを説明する図である。図 17 C は、CAAC - IGZO 膜の極微電子線回折パターンを説明する図である。

図 18 A は、半導体ウエハの上面図である。図 18 B は、チップの上面図である。

図 19 A は、電子部品の作製工程例を説明するフローチャートである。図 19 B は、電子部品の斜視模式図である。

30

図 20 A、図 20 B は、電子機器の構成を説明する図である。

図 21 A、図 21 B は、電子機器の構成を説明する図である。

【発明を実施するための形態】

【0024】

以下、実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、実施の形態は多くの異なる形態で実施することが可能であり、趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は、以下の実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

【0025】

また、以下に示される複数の実施の形態は、適宜組み合わせることが可能である。また、1つの実施の形態の中に複数の構成例が示される場合は、互いに構成例を適宜組み合わせることが可能である。

40

【0026】

なお、本明細書に添付した図面では、構成要素を機能ごとに分類し、互いに独立したブロックとしてブロック図を示しているが、実際の構成要素は機能ごとに完全に切り分けることが難しく、一つの構成要素が複数の機能に係わることもあり得る。

【0027】

また、図面等において、大きさ、層の厚さ、領域等は、明瞭化のため誇張されている場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されない。図面は、理想的な例を模式的に示したものであり、図面に示す形状または値などに限定されない。

50

【 0 0 2 8 】

また、図面等において、同一の要素または同様な機能を有する要素、同一の材質の要素、あるいは同時に形成される要素等には同一の符号を付す場合があり、その繰り返しの説明は省略する場合がある。

【 0 0 2 9 】

また、本明細書等において、「膜」という用語と、「層」という用語とは、互いに入れ替えることが可能である。例えば、「導電層」という用語を、「導電膜」という用語に変更することが可能な場合がある。または、例えば、「絶縁膜」という用語を、「絶縁層」という用語に変更することが可能な場合がある。

【 0 0 3 0 】

また、本明細書等において、「上」や「下」などの配置を示す用語は、構成要素の位置関係が、「直上」または「直下」であることを限定するものではない。例えば、「ゲート絶縁層上のゲート電極」の表現であれば、ゲート絶縁層とゲート電極との間に他の構成要素を含むものを除外しない。

【 0 0 3 1 】

また、本明細書等において、「第 1」、「第 2」、「第 3」などの序数詞は、構成要素の混同を避けるために付したものであり、数的に限定するものではない。

【 0 0 3 2 】

また、本明細書等において、複数の要素に同じ符号を用いる場合、特にそれらを区別する必要があるときは、符号に、「__ 1」、「__ 2」、「[n]」、「[m , n]」等、識別用の符号を付して記載する場合がある。例えば、2 番目の配線 G L を、配線 G L [2] と記載する。

【 0 0 3 3 】

また、本明細書等において、「電氣的に接続」とは、「何らかの電氣的作用を有するもの」を介して接続されている場合が含まれる。ここで、「何らかの電氣的作用を有するもの」は、接続対象間での電気信号の授受を可能とするものであれば、特に制限を受けない。例えば、「何らかの電氣的作用を有するもの」には、電極や配線をはじめ、トランジスタなどのスイッチング素子、抵抗素子、インダクタ、容量素子、その他の各種機能を有する素子などが含まれる。また、「電氣的に接続」と表現される場合であっても、実際の回路において、物理的な接続部分がなく、配線が延在しているだけの場合もある。

【 0 0 3 4 】

また、本明細書等において、「電極」や「配線」の用語は、これらの構成要素を機能的に限定するものではない。例えば、「電極」は「配線」の一部として用いられることがあり、その逆も同様である。

【 0 0 3 5 】

また、本明細書等において、電気回路における「端子」とは、電流または電位の入力（または、出力）や、信号の受信（または、送信）が行なわれる部位を言う。よって、配線または電極の一部が端子として機能する場合がある。

【 0 0 3 6 】

一般に、「容量素子」は、2 つの電極が絶縁体（誘電体）を介して向かい合う構成を有する。また、本明細書等において、「容量素子」は、2 つの電極が絶縁体を介して向かい合う構成を有したものの以外に、2 本の配線が絶縁体を介して向かい合う構成を有したものの、または、2 本の配線が絶縁体を介して配置されたものの、である場合が含まれる。また、本明細書等において、「容量素子」を、「コンデンサ」、「キャパシタ」、または、「容量」と呼ぶ場合がある。

【 0 0 3 7 】

また、本明細書等において、「電圧」とは、ある電位と基準の電位（例えば、グラウンド電位）との電位差のことを示す場合が多い。よって、電圧と電位差とは言い換えることができる。

【 0 0 3 8 】

10

20

30

40

50

また、本明細書等において、トランジスタとは、ソースと、ドレインと、ゲートとを含む、少なくとも三つの端子を有する素子である。そして、ソース（ソース端子、ソース領域、または、ソース電極）とドレイン（ドレイン端子、ドレイン領域、または、ドレイン電極）の間にチャンネル形成領域を有しており、チャンネル形成領域を介して、ソースとドレインとの間に電流を流すことができるものである。なお、本明細書等において、チャンネル形成領域とは、電流が主として流れる領域をいう。

【0039】

また、ソースやドレインの機能は、異なる極性のトランジスタを用いる場合や、回路動作において電流の方向が変化する場合などには入れ替わることがある。このため、本明細書等において、ソースやドレインの用語は、入れ替えて用いることができるものとする。

10

【0040】

また、本明細書等において、特に断りがない場合、オフ電流とは、トランジスタがオフ状態（非導通状態、遮断状態、ともいう）にあるときのドレイン電流をいう。オフ状態とは、特に断りがない場合、 n チャンネル型のトランジスタでは、ソースに対するゲートの電圧 V_{gs} がしきい値電圧 V_{th} よりも低い状態、 p チャンネル型のトランジスタでは、ソースに対するゲートの電圧 V_{gs} がしきい値電圧 V_{th} よりも高い状態をいう。つまり、 n チャンネル型のトランジスタのオフ電流とは、ソースに対するゲートの電圧 V_{gs} がしきい値電圧 V_{th} よりも低いときのドレイン電流、という場合がある。

【0041】

上記オフ電流の説明において、ドレインをソースと読み替えてもよい。つまり、オフ電流は、トランジスタがオフ状態にあるときのソース電流をいう場合がある。また、オフ電流と同じ意味で、リーク電流という場合がある。また、本明細書等において、オフ電流とは、トランジスタがオフ状態にあるときに、ソースとドレインとの間に流れる電流を指す場合がある。

20

【0042】

また、本明細書等において、オン電流とは、トランジスタがオン状態（導通状態、ともいう）にあるときに、ソースとドレインとの間に流れる電流を指す場合がある。

【0043】

また、本明細書等において、金属酸化物（metal oxide）とは、広い意味での金属の酸化物である。金属酸化物は、酸化物絶縁体、酸化物導電体（透明酸化物導電体、を含む）、酸化物半導体などに分類される。

30

【0044】

例えば、トランジスタのチャンネル形成領域に金属酸化物を用いた場合、当該金属酸化物を酸化物半導体と呼称する場合がある。つまり、金属酸化物が増幅作用、整流作用、およびスイッチング作用の少なくとも1つを有する場合、当該金属酸化物を、金属酸化物半導体（metal oxide semiconductor）と呼ぶことができる。すなわち、チャンネル形成領域に金属酸化物を有するトランジスタを、「酸化物半導体トランジスタ」、「OSトランジスタ」と呼ぶことができる。同様に、「酸化物半導体を用いたトランジスタ」も、チャンネル形成領域に金属酸化物を有するトランジスタである。

【0045】

40

また、本明細書等において、窒素を有する金属酸化物も金属酸化物（metal oxide）と呼称する場合がある。また、窒素を有する金属酸化物を、金属酸窒化物（metal oxynitride）と呼称してもよい。金属酸化物の詳細については後述する。

【0046】

（実施の形態1）

本実施の形態では、本発明の一形態に係わる半導体装置の構成例および動作例について説明する。本発明の一形態に係わる半導体装置は、積和演算回路と記憶装置を有する。また、本発明の一形態に係わる半導体装置は、半導体基板に形成されたトランジスタを有する層の上方に、OSトランジスタを有する層が積層して設けられた構造を有する。OSトランジスタは、オフ電流が非常に小さいという性質を有する。

50

【 0 0 4 7 】

< 半導体装置の斜視概略図 >

図 1 は、本発明の一形態に係わる半導体装置 1 0 0 の構成例を示す斜視概略図である。図 1 に示す半導体装置 1 0 0 は、層 1 0 1 および層 1 0 2 を有し、層 1 0 1 の上方に層 1 0 2 が積層して設けられた構造を有する。層 1 0 1 および層 1 0 2 には、それぞれ半導体特性を利用することで機能しうる回路が設けられている。なお、本明細書等で説明する図面においては、主な信号の流れを矢印または線で示しており、電源線等は省略する場合がある。

【 0 0 4 8 】

半導体装置 1 0 0 は、ワード線ドライバ回路 1 1 1、ビット線ドライバ回路 1 1 2、および積和演算ブロック 1 1 3 を有する。ワード線ドライバ回路 1 1 1 およびビット線ドライバ回路 1 1 2 は、層 1 0 1 に設けられており、積和演算ブロック 1 1 3 は、層 1 0 1 および層 1 0 2 にまたがって設けられている。

10

【 0 0 4 9 】

ワード線ドライバ回路 1 1 1 およびビット線ドライバ回路 1 1 2 は、半導体基板 S U B に形成されたトランジスタを用いて構成される。半導体基板 S U B は、トランジスタのチャネル領域を形成することが可能であれば、特に限定されない。例えば、単結晶シリコン基板、単結晶ゲルマニウム基板、化合物半導体基板 (S i C 基板、G a N 基板など)、S O I (S i l i c o n o n I n s u l a t o r) 基板などを用いることができる。

【 0 0 5 0 】

S O I 基板としては、例えば、鏡面研磨ウエハに酸素イオンを注入した後、高温加熱することにより、表面から一定の深さに酸化層を形成させるとともに、表面層に生じた欠陥を消滅させて形成された S I M O X (S e p a r a t i o n b y I m p l a n t e d O x y g e n) 基板や、水素イオン注入により形成された微小ボイドの熱処理による成長を利用して半導体基板を劈開するスマートカット法、E L T R A N 法 (登録商標 : E p i t a x i a l L a y e r T r a n s f e r) などを用いて形成された S O I 基板を用いることができる。また、単結晶基板を用いて形成されたトランジスタは、チャネル形成領域に単結晶半導体を有する。

20

【 0 0 5 1 】

積和演算ブロック 1 1 3 は、半導体基板 S U B に形成されたトランジスタ、および O S トランジスタを用いて構成される。O S トランジスタは薄膜法などの手法を用いて形成できるため、半導体基板 S U B 上に積層して設けることができる。すなわち、層 1 0 1 では、半導体基板 S U B に形成されたトランジスタを用いて回路が構成され、層 1 0 2 では、O S トランジスタを用いて回路が構成される。

30

【 0 0 5 2 】

なお、本実施の形態では、半導体基板 S U B に、単結晶シリコン基板を用いた例について説明する。単結晶シリコン基板に形成されたトランジスタを、S i トランジスタと呼ぶ。S i トランジスタを用いて構成された回路は、高速な動作が可能である。

【 0 0 5 3 】

積和演算ブロック 1 1 3 を、S i トランジスタおよび O S トランジスタを用いて構成することで、S i トランジスタのみを用いて構成した場合よりも、半導体装置 1 0 0 のチップ面積を削減 (半導体装置 1 0 0 を小型化) することができる。また、O S トランジスタは、S i トランジスタと同様の製造装置を用いて作製できるため、低コストでの作製が可能である。

40

【 0 0 5 4 】

ここで、酸化物半導体のバンドギャップは 2 . 5 e V 以上、好ましくは 3 . 0 e V 以上であるため、O S トランジスタは熱励起によるリーク電流が小さく、オフ電流が非常に小さい性質を有する。なお、オフ電流とは、トランジスタがオフ状態にあるときに、ソースとドレインとの間に流れる電流をいう。

【 0 0 5 5 】

50

ＯＳトランジスタのチャネル形成領域に用いられる金属酸化物は、インジウム（Ｉｎ）および亜鉛（Ｚｎ）の少なくとも一方を含む酸化物半導体であることが好ましい。このような酸化物半導体としては、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（元素Ｍは、例えばＡｌ、Ｇａ、Ｙ及びＳｎから選ばれる一または複数）が代表的である。電子供与体（ドナー）となる水分、酸素などの不純物を低減し、かつ酸素欠損も低減することで、酸化物半導体をｉ型（真性）、または実質的にｉ型にすることができる。このような酸化物半導体は、高純度化された酸化物半導体と呼ぶことができる。ＯＳトランジスタの詳細については、実施の形態２および実施の形態３で説明する。

【００５６】

また、図１に示すように、層１０１に設けられたワード線ドライバ回路１１１と、積和演算ブロック１１３の層１０２に設けられた部分とは、配線ＷＬによって電氣的に接続される。同様に、層１０１に設けられたビット線ドライバ回路１１２と、積和演算ブロック１１３の層１０２に設けられた部分とは、配線ＢＬによって電氣的に接続される。

【００５７】

なお、本実施の形態では、ワード線ドライバ回路１１１およびビット線ドライバ回路１１２を、Ｓｉトランジスタを用いて構成する例について説明したが、ＯＳトランジスタを用いて構成してもよい。

【００５８】

< 積和演算ブロックの構成例 >

図２Ａは、積和演算ブロック１１３の構成例を示す斜視概略図である。積和演算ブロック１１３は、 $m \times n$ 個の積和演算ユニット１０、配線ＷＬ、および配線ＢＬを有する（ m 、 n は１以上の整数）。

【００５９】

図２Ａに示すように、一列に m 個、一行に n 個の積和演算ユニット１０が行列状（マトリクス状、ともいう）に配置され、図２Ａに示す $[1, 1]$ 、 $[m, 1]$ 、 $[1, n]$ 、 $[m, n]$ は、積和演算ユニット１０のアドレスを示している。各積和演算ユニット１０は、配線ＷＬおよび配線ＢＬと電氣的に接続される。

【００６０】

また、積和演算ユニット１０は、層１０１および層１０２にまたがって設けられ、積和演算ユニット１０の層１０２に設けられた部分を回路ＭＥＭ、積和演算ユニット１０の層１０１に設けられた部分を回路ＭＡＣと呼称する。

【００６１】

図２Ｂは、積和演算ユニット１０の構成例を示す斜視概略図である。積和演算ユニット１０において、回路ＭＥＭと回路ＭＡＣとは、配線ＷＳおよび配線ＷＯによって電氣的に接続されている。

【００６２】

図３は、積和演算ユニット１０の構成例を示す回路図である。積和演算ユニット１０は、回路ＭＥＭ、回路ＭＡＣ、配線ＲＥＦ、配線ＰＣ、配線ＲＤ、配線ＤＸ、配線ＤＡ、配線ＤＢ、配線ＣＸ、 s 本の配線ＷＳ、および t 本の配線ＷＯを有する（ s 、 t は１以上の整数）。

【００６３】

回路ＭＥＭと回路ＭＡＣとは、 s 本の配線ＷＳ、および t 本の配線ＷＯを介して電氣的に接続される。また、図３に示すように、回路ＭＥＭには、積和演算ブロック１１３が有する配線ＷＬおよび配線ＢＬのうち、 s 本の配線ＷＬおよび t 本の配線ＢＬが配置されている。

【００６４】

< 回路ＭＥＭの構成例 >

回路ＭＥＭは、 t 個のプリチャージ回路１２、 $s \times t$ 個のメモリセル１１を有し、一列に s 個、一行に t 個のメモリセル１１が行列状に配置される。図３に示す $[1, 1]$ 、 $[s, 1]$ 、 $[1, t]$ 、 $[s, t]$ は、メモリセル１１のアドレスを示している。

10

20

30

40

50

【 0 0 6 5 】

なお、本明細書等で説明する図面において、プリチャージ回路 1 2、メモリセル 1 1 等の構成要素が複数個存在する場合、その一つに対して回路図等の詳細を図示し、それ以外に対しては詳細を省略する場合がある。例えば、図 3 において、メモリセル 1 1 [1 , 1] については回路図を図示し、メモリセル 1 1 [s , 1]、メモリセル 1 1 [1 , t]、およびメモリセル 1 1 [s , t] については回路図を省略している。

【 0 0 6 6 】

メモリセル 1 1 は、配線 W S および配線 W O と電氣的に接続され、k を 1 以上 s 以下の整数、l を 1 以上 t 以下の整数とした場合、メモリセル 1 1 [k , l] は、配線 W S [k] および配線 W O [l] と電氣的に接続される (k , l は図示せず)。また、メモリセル 1 1 [k , l] は、配線 W L [k] および配線 B L [l] と電氣的に接続される。

10

【 0 0 6 7 】

同様に、プリチャージ回路 1 2 は、配線 W O と電氣的に接続され、プリチャージ回路 1 2 [1] は、配線 W O [1] と電氣的に接続される。また、プリチャージ回路 1 2 は、配線 R E F および配線 P C と電氣的に接続される。

【 0 0 6 8 】

プリチャージ回路 1 2 は、トランジスタ 2 5 を有し、配線 W O をプリチャージする機能を有する。トランジスタ 2 5 のソースまたはドレインの一方は、配線 R E F と電氣的に接続され、トランジスタ 2 5 のソースまたはドレインの他方は、配線 W O と電氣的に接続され、トランジスタ 2 5 のゲートは配線 P C と電氣的に接続される。すなわち、配線 P C にハイレベルの電位が印加された場合、トランジスタ 2 5 はオン状態となり、プリチャージ回路 1 2 は、配線 W O を、配線 R E F に供給される電位でプリチャージする機能を有する。

20

【 0 0 6 9 】

メモリセル 1 1 は、トランジスタ 2 1 乃至トランジスタ 2 3、および容量 2 4 を有する。トランジスタ 2 1 のソースまたはドレインの一方は、配線 B L と電氣的に接続され、トランジスタ 2 1 のソースまたはドレインの他方は、トランジスタ 2 2 のゲート、および容量 2 4 の一方の電極と電氣的に接続され、トランジスタ 2 1 のゲートは配線 W L と電氣的に接続される。トランジスタ 2 2 のソースまたはドレインの一方は、トランジスタ 2 3 のソースまたはドレインの一方と電氣的に接続され、トランジスタ 2 3 のソースまたはドレインの他方は、配線 W O と電氣的に接続される。

30

【 0 0 7 0 】

また、トランジスタ 2 2 のソースまたはドレインの他方は、基準の電位と電氣的に接続され、容量 2 4 の他方の電極は、例えば、基準の電位と電氣的に接続される。なお、トランジスタ 2 1 のソースまたはドレインの他方と、トランジスタ 2 2 のゲート、および容量 2 4 の一方の電極との接続部を、ノード N 1 と呼称する。

【 0 0 7 1 】

メモリセル 1 1 は、電荷を蓄積し保持することでデータを記憶する機能を有する。メモリセル 1 1 は、例えば、2 値 (ハイレベルまたはローレベル) のデータを記憶する機能を有する。なお、本実施の形態において、ローレベルは、前述した基準の電位を用いて表される。また、ハイレベルを表す電位を、配線 R E F に供給することができる。

40

【 0 0 7 2 】

メモリセル 1 1 において、データの書き込みは、配線 B L および配線 W L を用いて行われる。メモリセル 1 1 にデータを書き込む場合、配線 B L はビット線として機能し、配線 W L はワード線として機能し、トランジスタ 2 1 は、容量 2 4 の一方の電極と配線 B L とを導通または非導通とするスイッチとして機能する。データの書き込みは、配線 W L にハイレベルの電位を印加し、容量 2 4 の一方の電極と配線 B L とを導通状態とし、配線 B L の電位をノード N 1 に書き込むことによって行われる。

【 0 0 7 3 】

メモリセル 1 1 において、データの読み出しは、配線 W O、配線 W S、およびプリチャージ回路 1 2 を用いて行われる。メモリセル 1 1 からデータを読み出す場合、トランジスタ

50

22は、ノードN1の電位によって導通または非導通の状態となり、トランジスタ23は、トランジスタ22のソースまたはドレインの一方と配線W0とを導通または非導通とするスイッチとして機能する。

【0074】

データの読み出しは、プリチャージ回路12を用いて配線W0にハイレベルの電位（配線REFに供給される電位）を印加した後、配線W0をフローティング状態（電氣的に浮遊な状態）とし、配線WSにハイレベルの電位を印加して、トランジスタ22のソースまたはドレインの一方と配線W0とを導通状態とすることによって行われる。すなわち、ノードN1の電位がハイレベルの場合、トランジスタ22は導通状態であり、配線W0はローレベル（基準の電位）となる。ノードN1の電位がローレベルの場合、トランジスタ22は非導通状態であり、配線W0はハイレベルのままである。

10

【0075】

ここで、トランジスタ21乃至トランジスタ23、およびトランジスタ25は、チャネル形成領域に金属酸化物を有するトランジスタ（OSTランジスタ）である。例えば、トランジスタ21のチャネル形成領域に、インジウム、元素M（元素Mは、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、銅、バナジウム、ベリリウム、ホウ素、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、またはマグネシウムなどから選ばれた一種、または複数種）、亜鉛のいずれか一つを有する金属酸化物を用いることができる。特に、インジウム、ガリウム、亜鉛からなる金属酸化物であることが好ましい。

20

【0076】

OSTランジスタはオフ電流が非常に小さいため、トランジスタ21にOSTランジスタを用いることで、メモリセル11は、容量24に蓄積した電荷を長時間保持することができる。または、トランジスタ21にOSTランジスタを用いることで、メモリセル11が有する容量24の容量値を小さくしても、容量24に蓄積した電荷を保持することができる。また、OSTランジスタは高温環境下でもオフ電流が増加しにくく、メモリセル11を信頼性の高いメモリセルとすることができる。

【0077】

また、トランジスタ21乃至トランジスタ23、およびトランジスタ25は、バックゲートを有していてもよい。例えば、トランジスタ21がバックゲートを有する場合、トランジスタ21のバックゲートに所定の電位を印加することで、トランジスタ21のしきい値電圧を増減することができる。または、トランジスタ21のバックゲートを、トランジスタ21のゲートと電氣的に接続することで、トランジスタ21のオン電流を大きくすることができる。

30

【0078】

また、容量24は、電極となる導電体の間に絶縁体を挟んだ構成である。電極を構成する導電体としては、金属の他、導電性を付与した半導体などを用いることができる。

【0079】

<回路MACの構成例>

回路MACは、デコーダ回路13、レジスタ回路14、t個の回路15、乗算回路16、加算回路17、レジスタ回路18、およびt本の配線WTを有する。なお、乗算回路16および加算回路17は、積和演算回路を構成する。

40

【0080】

回路MACは、例えば、Siトランジスタを用いたCMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）回路で構成することができる。CMOS回路は、例えば、単結晶シリコン基板に形成されたnチャネル型トランジスタとpチャネル型トランジスタを用いて構成され、ハイレベルまたはローレベル（HighまたはLow、HまたはL、1または0、等と表される場合がある）で表されるデジタル信号を扱う回路（デジタル回路、論理回路、ともいう）として、広く用いられている。

【0081】

50

なお、配線 D X、配線 D A、配線 C X には、複数ビットの情報量を有する信号が入力されてもよい。例えば、配線 D X に入力される信号を、8 ビット、16 ビット、32 ビット、または 64 ビットの情報量を有する信号とすることができる。

【0082】

デコーダ回路 13 は、配線 C X、および s 本の配線 W S と電氣的に接続され、配線 C X に入力される信号をデコードし、s 本の配線 W S を駆動する機能を有する。より具体的には、デコーダ回路 13 は、配線 C X に入力される信号に従って、配線 W S [1] 乃至配線 W S [s] から 1 本を選択し、選択した配線 W S にハイレベルの電位を印加する。

【0083】

レジスタ回路 14 は、配線 D X と電氣的に接続され、配線 D X に入力される信号を一時的に保持する機能を有する。レジスタ回路 14 は、配線 D X に入力された信号を保持し、乗算回路 16 に出力する。

【0084】

回路 15 の構成例について、図 4 A に回路図を示す。回路 15 は、インバータ 41 乃至インバータ 43、トランジスタ 44 乃至トランジスタ 47、配線 V D、および配線 V S を有する。

【0085】

トランジスタ 44 のソースまたはドレインの一方は、配線 V D と電氣的に接続され、トランジスタ 44 のソースまたはドレインの他方は、トランジスタ 45 のソースまたはドレインの一方と電氣的に接続され、トランジスタ 45 のソースまたはドレインの他方は、トランジスタ 46 のソースまたはドレインの一方、インバータ 42 の入力端子、およびインバータ 41 の出力端子と電氣的に接続され、トランジスタ 46 のソースまたはドレインの他方は、トランジスタ 47 のソースまたはドレインの一方と電氣的に接続され、トランジスタ 47 のソースまたはドレインの他方は、配線 V S と電氣的に接続される。

【0086】

トランジスタ 44 のゲートは、インバータ 43 の出力端子と電氣的に接続され、トランジスタ 45 のゲートは、トランジスタ 46 のゲート、および配線 W O と電氣的に接続され、トランジスタ 47 のゲートは、インバータ 43 の入力端子、および配線 R D と電氣的に接続される。また、インバータ 42 の出力端子は、インバータ 41 の入力端子、および配線 W T と電氣的に接続される。

【0087】

配線 V D には高電源電位 V D D が供給され、配線 V S には低電源電位 V S S が供給される。なお、低電源電位 V S S は、半導体装置 100 において、基準の電位として用いてもよい。

【0088】

回路 15 において、配線 R D にハイレベルの電位が印加された場合、インバータ 43 はローレベルの電位を出力するため、トランジスタ 44 およびトランジスタ 47 はオン状態となり、トランジスタ 45 およびトランジスタ 46 はインバータとして機能する。また、インバータ 41 およびインバータ 42 はインバータループを形成し、メモリとしての機能を有するため、回路 15 は、配線 R D にハイレベルの電位が印加された時の配線 W O の電位状態（ハイレベルまたはローレベル）を取得し、インバータ 41 およびインバータ 42 によって保持し、配線 W T に出力する機能を有する。

【0089】

配線 W T に出力された信号は、乗算回路 16 にて、レジスタ回路 14 から出力された信号と掛け合わされ、加算回路 17 へ出力される。加算回路 17 は、乗算回路 16 から出力された信号と、配線 D A に入力された信号とを足し合わせ、レジスタ回路 18 へ出力する。レジスタ回路 18 は、加算回路 17 から出力された信号を一時的に保持し、配線 D B を介して積和演算ユニット 10 の外部へ出力する。

【0090】

なお、デコーダ回路、レジスタ回路、乗算回路、加算回路については、それぞれ、C M O

10

20

30

40

50

S 回路で構成されたデコーダ回路、レジスタ回路、乗算回路、加算回路が知られているため、説明を省略する。

【 0 0 9 1 】

< 積和演算ユニット >

ここで、配線 D X に入力される信号を、データ信号 X とし、配線 D A に入力される信号を、データ信号 A とし、配線 D B に出力される信号を、データ信号 B とする。また、t 本の配線 W T (配線 W T [1] 乃至配線 W T [t]) に出力される信号を、データ信号 W とする。すると、積和演算ユニット 1 0 はデータ信号 B を出力する機能を有し、データ信号 B は、データ信号 X にデータ信号 W を掛け合わせ、データ信号 A を足した結果である、と言い換えることができる。

10

【 0 0 9 2 】

また、回路 M E M は $s \times t$ 個のメモリセル 1 1 を有するため、回路 M E M は、メモリセル 1 1 に、データ信号 W [1] 乃至データ信号 W [s] を記憶する機能を有する。データ信号 W [1] 乃至データ信号 W [s] は、配線 W S [1] 乃至配線 W S [s] を駆動することで、時間を区切って読み出すことができる。

【 0 0 9 3 】

例えば、データ信号 W [1] 乃至データ信号 W [s] のうち、データ信号 W [1] 乃至データ信号 W [3] を配線 W T に読み出す場合について、図 4 B にタイミングチャートを示す。図 4 B は、時刻 T 1 乃至時刻 T 9 における、配線 P C、配線 W S [1] 乃至配線 W S [3]、配線 R D、配線 W O、および配線 W T の電位状態 (ハイレベルまたはローレベル) を示すタイミングチャートである。

20

【 0 0 9 4 】

図 4 B に示すように、時刻 T 1 において配線 P C がハイレベルとなり、配線 W O はハイレベルの電位でプリチャージされる。時刻 T 2 において配線 W S [1] がハイレベルになると、配線 W O は、メモリセル 1 1 [1 , 1] 乃至メモリセル 1 1 [1 , t] が記憶していたデータに応じた電位状態となる (図 4 B では、W [1] と表記)。時刻 T 3 において配線 R D がハイレベルになると、配線 W O の電位状態が配線 W T に出力される。

【 0 0 9 5 】

また、時刻 T 4 において配線 P C がハイレベルとなり、配線 W O はハイレベルの電位でプリチャージされる。時刻 T 5 において配線 W S [2] がハイレベルになると、配線 W O は、メモリセル 1 1 [2 , 1] 乃至メモリセル 1 1 [2 , t] が記憶していたデータに応じた電位状態となる (図 4 B では、W [2] と表記)。時刻 T 6 において配線 R D がハイレベルになると、配線 W O の電位状態が配線 W T に出力される。時刻 T 7 乃至時刻 T 9 においても同様のため、説明を省略する。

30

【 0 0 9 6 】

データ信号 X とデータ信号 A についても、複数のデータ信号 X および複数のデータ信号 A を用意し、時間を区切って積和演算ユニット 1 0 に入力することで、複数の積和演算を行うことができる。

【 0 0 9 7 】

例えば、s 個のデータ信号 X (データ信号 X [1] 乃至データ信号 X [s])、および s 個のデータ信号 A (データ信号 A [1] 乃至データ信号 A [s]) を用意し、データ信号 X [1] 乃至データ信号 X [s] のそれぞれと、メモリセル 1 1 から読み出したデータ信号 W [1] 乃至データ信号 W [s] を掛け合わせ、データ信号 A [1] 乃至データ信号 A [s] を足すことで、s 個のデータ信号 B (データ信号 B [1] 乃至データ信号 B [s]) を得ることができる。すなわち、k を 1 以上 s 以下の整数とした場合、データ信号 B [k] = データ信号 X [k] × データ信号 W [k] + データ信号 A [k] である。

40

【 0 0 9 8 】

さらに、データ信号 B [k] をデータ信号 A [k + 1] に入力し、データ信号 A [1] を 0 とすることで、データ信号 B = データ信号 X [1] × データ信号 W [1] + データ信号 X [2] × データ信号 W [2] + (途中省略) + データ信号 X [s - 1] × データ信号 W

50

$[s - 1] + \text{データ信号} X[s] \times \text{データ信号} W[s]$ を得ることができる。

【0099】

例えば、 $s = 9$ の場合、データ信号 X を 3 行 \times 3 列のデータ信号、データ信号 W を 3 行 \times 3 列のデータ信号とすることができる。 $s = 9$ の場合における、データ信号 X とデータ信号 W のイメージ図を、図 5 A に示す。この場合、データ信号 $B = \text{データ信号} X[1] \times \text{データ信号} W[1] + \text{データ信号} X[2] \times \text{データ信号} W[2] + (\text{途中省略}) + \text{データ信号} X[8] \times \text{データ信号} W[8] + \text{データ信号} X[9] \times \text{データ信号} W[9]$ は、例えば、画像データに対する畳み込み演算に用いることができる。

【0100】

< 畳み込み演算 >

次に、画像データに対する畳み込み演算の例を示す。 p 行 q 列の画像データを画像データ $P(1, 1)$ 乃至 $P(p, q)$ で表し (p, q は 2 以上の整数)、 u 行 v 列のフィルタをフィルタ $F(1, 1)$ 乃至 $F(u, v)$ で表す (u, v は 1 以上の整数であり、 $u < p$ 、 $v < q$)。画像データ $P(1, 1)$ 乃至 $P(p, q)$ は、それぞれ 1 画素分に相当する画像データであり、フィルタ $F(1, 1)$ 乃至 $F(u, v)$ は、それぞれフィルタを構成するパラメータである。図 5 B に、画像データ P のイメージ図を示し、図 5 C に、フィルタ F のイメージ図を示す。

【0101】

例えば、 $p = q = 3$ 、 $u = v = 2$ の時、下記に示す $Y(1, 1)$ 乃至 $Y(2, 2)$ を計算する。

$$Y(1, 1) = P(1, 1) \times F(1, 1) + P(1, 2) \times F(1, 2) + P(2, 1) \times F(2, 1) + P(2, 2) \times F(2, 2) \quad (a1)$$

$$Y(1, 2) = P(1, 2) \times F(1, 1) + P(1, 3) \times F(1, 2) + P(2, 2) \times F(2, 1) + P(2, 3) \times F(2, 2) \quad (a2)$$

$$Y(2, 1) = P(2, 1) \times F(1, 1) + P(2, 2) \times F(1, 2) + P(3, 1) \times F(2, 1) + P(3, 2) \times F(2, 2) \quad (a3)$$

$$Y(2, 2) = P(2, 2) \times F(1, 1) + P(2, 3) \times F(1, 2) + P(3, 2) \times F(2, 1) + P(3, 3) \times F(2, 2) \quad (a4)$$

【0102】

式 $a1$ 乃至 $a4$ を一般式で表すと、

$$Y(x, y) = a(bP(a + x - 1, b + y - 1) \times F(a, b)) \quad (a5)$$

である。なお、 a は 1 乃至 u の整数、 b は 1 乃至 v の整数であり、 x は 1 乃至 $p - u + 1$ の整数、 y は 1 乃至 $q - v + 1$ の整数である。例えば、 $Y(1, 1)$ を計算する場合、図 5 B に示す、領域 50 の画像データ P に対して積和演算を行う。

【0103】

画像データに対する畳み込み演算は、前記積和演算を用いて $Y(1, 1)$ 乃至 $Y(u, v)$ を計算することで行われる。画像データに対する畳み込み演算を行うことで、例えば、画像のエッジなどを検出することができる。また、畳み込み演算を複数回行うことで、画像の形やパターンなど、画像データの特徴を検出することができ、このような畳み込み演算は、画像認識において利用されている。

【0104】

積和演算ユニット 10 のメモリセル 11 にフィルタ F のパラメータを記憶し、データ信号 X に画像データ P を入力することで、積和演算ユニット 10 は前記畳み込み演算を行うことができる。畳み込み演算に用いられるフィルタ F のパラメータは、例えば学習によって生成され、学習が終わったフィルタ F のパラメータは繰り返し用いられる。積和演算ユニット 10 では、個々の積和演算ユニット 10 が有する配線 WS および配線 WO を用いて、フィルタ F のパラメータをデータ信号 W として取り出すため、フィルタ F のパラメータを繰り返し用いる点において、積和演算ユニット 10 は効率的である。

【0105】

なお、複数の積和演算ユニット 10 を使って畳み込み演算を行ってもよい。画像データ P

10

20

30

40

50

およびフィルタFは2次元のデータであるため、例えば、u行v列のフィルタF(1, 1)乃至F(u, v)に対して、フィルタF(1, 1)乃至F(1, v)を積和演算ユニット10[1, 1]に、フィルタF(2, 1)乃至F(2, v)を積和演算ユニット10[2, 1]に、(途中省略)、フィルタF(u, 1)乃至F(u, v)を積和演算ユニット10[u, 1]に記憶することができる(m ≥ uとする)。この場合、画像データP(1, 1)乃至P(1, v)に対する積和演算を積和演算ユニット10[1, 1]で、画像データP(2, 1)乃至P(2, v)に対する積和演算を積和演算ユニット10[2, 1]で、(途中省略)、画像データP(u, 1)乃至P(u, v)に対する積和演算を積和演算ユニット10[u, 1]で行うことができ、それらの結果を足し合わせることで、Y(1, 1)を計算することができる。

10

【0106】

また、本実施の形態では、積和演算ユニット10を画像データに対する畳み込み演算に用いる例を示したが、積和演算は、ニューロンとシナプスで構成される神経回路網を模したニューラルネットワークで多用されており、積和演算ユニット10をニューラルネットワークに用いることもできる。積和演算ユニット10をニューラルネットワークに用いる場合、フィルタFのパラメータは重み係数に相当し、積和演算ユニット10は、メモリセル11に重み係数を記憶することで、前記重み係数を効率よく用いることができる。

【0107】

本発明の一形態に係わる半導体装置100は、半導体基板に形成されたトランジスタを有する層の上方に、OSトランジスタを有する層が積層して設けられ、OSトランジスタを用いてメモリセルが構成される。OSトランジスタはオフ電流が非常に小さいため、OSトランジスタを用いて構成されたメモリセルは、記憶したデータを長時間保持することができる。

20

【0108】

また、半導体基板に形成されたトランジスタを用いて積和演算回路が構成され、積和演算回路は、上方に積層して設けられたメモリセルと、配線WSおよび配線WOを介して電氣的に接続される。半導体装置100は、積和演算回路とメモリセルとを組み合わせた積和演算ユニット10を複数有し、積和演算ユニット10のそれぞれにおいて、メモリセルに記憶したフィルタFのパラメータ(または、重み係数)を読み出すことで、畳み込み演算(または、ニューラルネットワークを用いた計算)を効率よく行うことができる。半導体装置100は、フィルタFのパラメータが繰り返し用いられる畳み込み演算(または、重み係数が繰り返し用いられるニューラルネットワークの計算)に好適に用いることができる。

30

【0109】

半導体装置100は、積和演算回路の上方にメモリセルが積層して設けられるため、半導体装置100は小型である。OSトランジスタは高温環境下でもオフ電流が増加しにくいいため、積和演算回路の発熱に対しても信頼性の高いメモリセルとすることができる。また、OSトランジスタは、Siトランジスタと同様の製造装置を用いて作製できるため、半導体装置100は低コストでの作製が可能である。

【0110】

なお、本実施の形態は、本明細書に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。

40

【0111】

(実施の形態2)

本実施の形態では、上記実施の形態で説明した半導体装置100を構成する、トランジスタの構成例について説明する。本実施の形態では、単結晶シリコン基板に形成されたSiトランジスタを有する層の上方に、OSトランジスタを有する層が積層して設けられた構造を有する、半導体装置の構成例について説明する。

【0112】

<半導体装置の構成例>

50

図 6 に示す半導体装置は、トランジスタ 3 0 0 と、トランジスタ 5 0 0、および容量素子 6 0 0 を有する。図 7 A はトランジスタ 5 0 0 のチャネル長方向の断面図であり、図 7 B はトランジスタ 5 0 0 のチャネル幅方向の断面図であり、図 7 C はトランジスタ 3 0 0 のチャネル幅方向の断面図である。

【 0 1 1 3 】

例えば、トランジスタ 5 0 0 は上記実施の形態に示したトランジスタ 2 1 に相当し、トランジスタ 5 0 0 は第 1 のゲート（トップゲート、または単に、ゲート、ともいう）に加えて、第 2 のゲート（ボトムゲート、バックゲート、ともいう）を有する。また、トランジスタ 3 0 0 は、例えば、半導体装置 1 0 0 が有するトランジスタ 4 7 に相当し、容量素子 6 0 0 は容量 2 4 に相当する。

10

【 0 1 1 4 】

トランジスタ 5 0 0 は、チャネル形成領域に金属酸化物を有するトランジスタ（O S トランジスタ）である。トランジスタ 5 0 0 は、オフ電流が非常に小さい、高温環境下でもオフ電流が増加しにくいという特徴を有するため、上記実施の形態では、これを半導体装置 1 0 0 に用いることにより、当該半導体装置を信頼性の高い半導体装置とすることができる。

【 0 1 1 5 】

図 6 に示すように、本実施の形態で説明する半導体装置において、トランジスタ 5 0 0 はトランジスタ 3 0 0 の上方に設けられ、容量素子 6 0 0 は、トランジスタ 3 0 0 およびトランジスタ 5 0 0 の上方に設けられている。

20

【 0 1 1 6 】

トランジスタ 3 0 0 は、基板 3 1 1 上に設けられ、導電体 3 1 6、絶縁体 3 1 5、基板 3 1 1 の一部からなる半導体領域 3 1 3、およびソース領域またはドレイン領域として機能する低抵抗領域 3 1 4 a、および低抵抗領域 3 1 4 b を有する。

【 0 1 1 7 】

トランジスタ 3 0 0 は、図 7 C に示すように、半導体領域 3 1 3 の上面およびチャネル幅方向の側面が絶縁体 3 1 5 を介して導電体 3 1 6 に覆われている。このように、トランジスタ 3 0 0 を F i n 型とすることにより、実効上のチャネル幅が増大することによりトランジスタ 3 0 0 のオン特性を向上させることができる。また、ゲート電極の電界の寄与を高くすることができるため、トランジスタ 3 0 0 のオフ特性を向上させることができる。

30

【 0 1 1 8 】

なお、トランジスタ 3 0 0 は、p チャネル型、あるいは n チャネル型のいずれでもよい。

【 0 1 1 9 】

半導体領域 3 1 3 のチャネルが形成される領域、その近傍の領域、ソース領域、またはドレイン領域となる低抵抗領域 3 1 4 a、および低抵抗領域 3 1 4 b などにおいて、シリコン系半導体などの半導体を含むことが好ましく、単結晶シリコンを含むことが好ましい。または、G e（ゲルマニウム）、S i G e（シリコンゲルマニウム）、G a A s（ガリウムヒ素）、G a A l A s（ガリウムアルミニウムヒ素）などを有する材料で形成してもよい。結晶格子に応力を与え、格子間隔を変化させることで有効質量を制御したシリコンを用いた構成としてもよい。または G a A s と G a A l A s 等を用いることで、トランジスタ 3 0 0 を H E M T（H i g h E l e c t r o n M o b i l i t y T r a n s i s t o r）としてもよい。

40

【 0 1 2 0 】

低抵抗領域 3 1 4 a、および低抵抗領域 3 1 4 b は、半導体領域 3 1 3 に適用される半導体材料に加え、ヒ素、リンなどの n 型の導電性を付与する元素、またはホウ素などの p 型の導電性を付与する元素を含む。

【 0 1 2 1 】

ゲート電極として機能する導電体 3 1 6 は、ヒ素、リンなどの n 型の導電性を付与する元素、もしくはホウ素などの p 型の導電性を付与する元素を含むシリコンなどの半導体材料、金属材料、合金材料、または金属酸化物材料などの導電性材料を用いることができる。

50

【 0 1 2 2 】

なお、導電体の材料により、仕事関数が定まるため、導電体の材料を変更することで、トランジスタの V_{th} を調整することができる。具体的には、導電体に窒化チタンや窒化タantalなどの材料を用いることが好ましい。さらに導電性と埋め込み性を両立するために導電体にタングステンやアルミニウムなどの金属材料を積層して用いることが好ましく、特にタングステンを用いることが耐熱性の点で好ましい。

【 0 1 2 3 】

なお、図 6 に示すトランジスタ 3 0 0 は一例であり、その構造に限定されず、回路構成や駆動方法に応じて適切なトランジスタを用いればよい。

【 0 1 2 4 】

トランジスタ 3 0 0 を覆って、絶縁体 3 2 0、絶縁体 3 2 2、絶縁体 3 2 4、および絶縁体 3 2 6 が順に積層して設けられている。

【 0 1 2 5 】

絶縁体 3 2 0、絶縁体 3 2 2、絶縁体 3 2 4、および絶縁体 3 2 6 として、例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、窒化アルミニウムなどを用いればよい。

【 0 1 2 6 】

絶縁体 3 2 2 は、その下方に設けられるトランジスタ 3 0 0 などによって生じる段差を平坦化する平坦化膜としての機能を有していてもよい。例えば、絶縁体 3 2 2 の上面は、平坦性を高めるために化学機械研磨 (CMP) 法等を用いた平坦化処理により平坦化されていてもよい。

【 0 1 2 7 】

また、絶縁体 3 2 4 には、基板 3 1 1、またはトランジスタ 3 0 0 などから、トランジスタ 5 0 0 が設けられる領域に、水素や不純物が拡散しないようなバリア性を有する膜を用いることが好ましい。

【 0 1 2 8 】

水素に対するバリア性を有する膜の一例として、例えば、CVD法で形成した窒化シリコンを用いることができる。ここで、トランジスタ 5 0 0 等の酸化物半導体を有する半導体素子に、水素が拡散することで、当該半導体素子の特性が低下する場合がある。したがって、トランジスタ 5 0 0 と、トランジスタ 3 0 0 との間に、水素の拡散を抑制する膜を用いることが好ましい。水素の拡散を抑制する膜とは、具体的には、水素の脱離量が少ない膜とする。

【 0 1 2 9 】

水素の脱離量は、例えば、昇温脱離ガス分析 (TDS 分析) 法などを用いて分析することができる。例えば、絶縁体 3 2 4 の水素の脱離量は、TDS 分析において、膜の表面温度が 5 0 から 5 0 0 の範囲において、水素原子に換算した脱離量が、絶縁体 3 2 4 の面積当たりに換算して、 $1.0 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^2$ 以下、好ましくは $5 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^2$ 以下であればよい。

【 0 1 3 0 】

なお、絶縁体 3 2 6 は、絶縁体 3 2 4 よりも比誘電率が低いことが好ましい。例えば、絶縁体 3 2 6 の比誘電率は 4 未満が好ましく、3 未満がより好ましい。また例えば、絶縁体 3 2 6 の比誘電率は、絶縁体 3 2 4 の比誘電率の 0.7 倍以下が好ましく、0.6 倍以下がより好ましい。比誘電率が低い材料を層間膜とすることで、配線間に生じる寄生容量を低減することができる。

【 0 1 3 1 】

また、絶縁体 3 2 0、絶縁体 3 2 2、絶縁体 3 2 4、および絶縁体 3 2 6 には容量素子 6 0 0、またはトランジスタ 5 0 0 と接続する導電体 3 2 8、および導電体 3 3 0 等が埋め込まれている。なお、導電体 3 2 8、および導電体 3 3 0 は、プラグまたは配線としての機能を有する。また、プラグまたは配線としての機能を有する導電体は、複数の構造をまとめて同一の符号を付与する場合がある。また、本明細書等において、配線と、配線と接

10

20

30

40

50

続するプラグとが一体物であってもよい。すなわち、導電体の一部が配線として機能する場合、および導電体の一部がプラグとして機能する場合もある。

【0132】

各プラグ、および配線（導電体328、および導電体330等）の材料としては、金属材料、合金材料、金属窒化物材料、または金属酸化物材料などの導電性材料を、単層または積層して用いることができる。耐熱性と導電性を両立するタングステンやモリブデンなどの高融点材料を用いることが好ましく、タングステンをを用いることが好ましい。または、アルミニウムや銅などの低抵抗導電性材料で形成することが好ましい。低抵抗導電性材料を用いることで配線抵抗を低くすることができる。

【0133】

絶縁体326、および導電体330上に、配線層を設けてもよい。例えば、図6において、絶縁体350、絶縁体352、および絶縁体354が順に積層して設けられている。また、絶縁体350、絶縁体352、および絶縁体354には、導電体356が形成されている。導電体356は、トランジスタ300と接続するプラグ、または配線としての機能を有する。なお導電体356は、導電体328、および導電体330と同様の材料を用いて設けることができる。

【0134】

なお、例えば、絶縁体350は、絶縁体324と同様に、水素に対するバリア性を有する絶縁体を用いることが好ましい。また、導電体356は、水素に対するバリア性を有する導電体を含むことが好ましい。特に、水素に対するバリア性を有する絶縁体350が有する開口部に、水素に対するバリア性を有する導電体が形成される。当該構成により、トランジスタ300とトランジスタ500とは、バリア層により分離することができ、トランジスタ300からトランジスタ500への水素の拡散を抑制することができる。

【0135】

なお、水素に対するバリア性を有する導電体としては、例えば、窒化タンタル等を用いるとよい。また、窒化タンタルと導電性が高いタングステンを積層することで、配線としての導電性を保持したまま、トランジスタ300からの水素の拡散を抑制することができる。この場合、水素に対するバリア性を有する窒化タンタル層が、水素に対するバリア性を有する絶縁体350と接する構造であることが好ましい。

【0136】

絶縁体354、および導電体356上に、配線層を設けてもよい。例えば、図6において、絶縁体360、絶縁体362、および絶縁体364が順に積層して設けられている。また、絶縁体360、絶縁体362、および絶縁体364には、導電体366が形成されている。導電体366は、プラグまたは配線としての機能を有する。なお導電体366は、導電体328、および導電体330と同様の材料を用いて設けることができる。

【0137】

なお、例えば、絶縁体360は、絶縁体324と同様に、水素に対するバリア性を有する絶縁体を用いることが好ましい。また、導電体366は、水素に対するバリア性を有する導電体を含むことが好ましい。特に、水素に対するバリア性を有する絶縁体360が有する開口部に、水素に対するバリア性を有する導電体が形成される。当該構成により、トランジスタ300とトランジスタ500とは、バリア層により分離することができ、トランジスタ300からトランジスタ500への水素の拡散を抑制することができる。

【0138】

絶縁体364、および導電体366上に、配線層を設けてもよい。例えば、図6において、絶縁体370、絶縁体372、および絶縁体374が順に積層して設けられている。また、絶縁体370、絶縁体372、および絶縁体374には、導電体376が形成されている。導電体376は、プラグまたは配線としての機能を有する。なお導電体376は、導電体328、および導電体330と同様の材料を用いて設けることができる。

【0139】

なお、例えば、絶縁体370は、絶縁体324と同様に、水素に対するバリア性を有する

10

20

30

40

50

絶縁体を用いることが好ましい。また、導電体 376 は、水素に対するバリア性を有する導電体を含むことが好ましい。特に、水素に対するバリア性を有する絶縁体 370 が有する開口部に、水素に対するバリア性を有する導電体が形成される。当該構成により、トランジスタ 300 とトランジスタ 500 とは、バリア層により分離することができ、トランジスタ 300 からトランジスタ 500 への水素の拡散を抑制することができる。

【0140】

絶縁体 374、および導電体 376 上に、配線層を設けてもよい。例えば、図 6 において、絶縁体 380、絶縁体 382、および絶縁体 384 が順に積層して設けられている。また、絶縁体 380、絶縁体 382、および絶縁体 384 には、導電体 386 が形成されている。導電体 386 は、プラグまたは配線としての機能を有する。なお導電体 386 は、導電体 328、および導電体 330 と同様の材料を用いて設けることができる。

10

【0141】

なお、例えば、絶縁体 380 は、絶縁体 324 と同様に、水素に対するバリア性を有する絶縁体を用いることが好ましい。また、導電体 386 は、水素に対するバリア性を有する導電体を含むことが好ましい。特に、水素に対するバリア性を有する絶縁体 380 が有する開口部に、水素に対するバリア性を有する導電体が形成される。当該構成により、トランジスタ 300 とトランジスタ 500 とは、バリア層により分離することができ、トランジスタ 300 からトランジスタ 500 への水素の拡散を抑制することができる。

【0142】

上記において、導電体 356 を含む配線層、導電体 366 を含む配線層、導電体 376 を含む配線層、および導電体 386 を含む配線層、について説明したが、本実施の形態に係る半導体装置はこれに限られるものではない。導電体 356 を含む配線層と同様の配線層を 3 層以下にしてもよいし、導電体 356 を含む配線層と同様の配線層を 5 層以上にしてもよい。

20

【0143】

絶縁体 384 上には絶縁体 510、絶縁体 512、絶縁体 514、および絶縁体 516 が、順に積層して設けられている。絶縁体 510、絶縁体 512、絶縁体 514、および絶縁体 516 のいずれかは、酸素や水素に対してバリア性のある物質を用いることが好ましい。

【0144】

例えば、絶縁体 510、および絶縁体 514 には、例えば、基板 311、またはトランジスタ 300 を設ける領域などから、トランジスタ 500 を設ける領域に、水素や不純物が拡散しないようなバリア性を有する膜を用いることが好ましい。したがって、絶縁体 324 と同様の材料を用いることができる。

30

【0145】

水素に対するバリア性を有する膜の一例として、CVD 法で形成した窒化シリコンを用いることができる。ここで、トランジスタ 500 等の酸化物半導体を有する半導体素子に、水素が拡散することで、当該半導体素子の特性が低下する場合がある。したがって、トランジスタ 500 と、トランジスタ 300 との間に、水素の拡散を抑制する膜を用いることが好ましい。水素の拡散を抑制する膜とは、具体的には、水素の脱離量が少ない膜とする。

40

【0146】

また、水素に対するバリア性を有する膜として、例えば、絶縁体 510、および絶縁体 514 には、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタルなどの金属酸化物を用いることが好ましい。

【0147】

特に、酸化アルミニウムは、酸素、およびトランジスタの電気特性の変動要因となる水素、水分などの不純物、の両方に対して膜を透過させない遮断効果が高い。したがって、酸化アルミニウムは、トランジスタの作製工程中および作製後において、水素、水分などの不純物のトランジスタ 500 への混入を防止することができる。また、トランジスタ 500 を構成する酸化物からの酸素の放出を抑制することができる。そのため、トランジスタ

50

５００に対する保護膜として用いることに適している。

【０１４８】

また、例えば、絶縁体５１２、および絶縁体５１６には、絶縁体３２０と同様の材料を用いることができる。また、比較的誘電率が低い材料を層間膜とすることで、配線間に生じる寄生容量を低減することができる。例えば、絶縁体５１２、および絶縁体５１６として、酸化シリコン膜や酸化窒化シリコン膜などを用いることができる。

【０１４９】

また、絶縁体５１０、絶縁体５１２、絶縁体５１４、および絶縁体５１６には、導電体５１８、およびトランジスタ５００を構成する導電体（導電体５０３）等が埋め込まれている。なお、導電体５１８は、容量素子６００、またはトランジスタ３００と接続するプラグ、または配線としての機能を有する。導電体５１８は、導電体３２８、および導電体３３０と同様の材料を用いて設けることができる。

10

【０１５０】

特に、絶縁体５１０、および絶縁体５１４と接する領域の導電体５１８は、酸素、水素、および水に対するバリア性を有する導電体であることが好ましい。当該構成により、トランジスタ３００とトランジスタ５００とは、酸素、水素、および水に対するバリア性を有する層で、分離することができ、トランジスタ３００からトランジスタ５００への水素の拡散を抑制することができる。

【０１５１】

絶縁体５１６の上方には、トランジスタ５００が設けられている。

20

【０１５２】

図７Ａ、図７Ｂに示すように、トランジスタ５００は、絶縁体５１４および絶縁体５１６に埋め込まれるように配置された導電体５０３と、絶縁体５１６と導電体５０３の上に配置された絶縁体５２０と、絶縁体５２０の上に配置された絶縁体５２２と、絶縁体５２２の上に配置された絶縁体５２４と、絶縁体５２４の上に配置された酸化物５３０ａと、酸化物５３０ａの上に配置された酸化物５３０ｂと、酸化物５３０ｂ上に、互いに離して配置された導電体５４２ａ、および導電体５４２ｂと、導電体５４２ａおよび導電体５４２ｂ上に配置され、導電体５４２ａと導電体５４２ｂの間に重畳して開口が形成された絶縁体５８０と、開口の中に配置された導電体５６０と、酸化物５３０ｂ、導電体５４２ａ、導電体５４２ｂ、および絶縁体５８０と、導電体５６０と、の間に配置された絶縁体５５０と、酸化物５３０ｂ、導電体５４２ａ、導電体５４２ｂ、および絶縁体５８０と、絶縁体５５０と、の間に配置された酸化物５３０ｃと、を有する。

30

【０１５３】

また、図７Ａ、図７Ｂに示すように、酸化物５３０ａ、酸化物５３０ｂ、導電体５４２ａ、および導電体５４２ｂと、絶縁体５８０の間に絶縁体５４４が配置されることが好ましい。また、図７Ａ、図７Ｂに示すように、導電体５６０は、絶縁体５５０の内側に設けられた導電体５６０ａと、導電体５６０ａの内側に埋め込まれるように設けられた導電体５６０ｂと、を有することが好ましい。また、図７Ａ、図７Ｂに示すように、絶縁体５８０、導電体５６０、および絶縁体５５０の上に絶縁体５７４が配置されることが好ましい。

【０１５４】

なお、以下において、酸化物５３０ａ、酸化物５３０ｂ、および酸化物５３０ｃをまとめて酸化物５３０という場合がある。また、導電体５４２ａおよび導電体５４２ｂをまとめて導電体５４２という場合がある。

40

【０１５５】

なお、トランジスタ５００では、チャネルが形成される領域と、その近傍において、酸化物５３０ａ、酸化物５３０ｂ、および酸化物５３０ｃの３層を積層する構成について示しているが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、酸化物５３０ｂの単層、酸化物５３０ｂと酸化物５３０ａの２層構造、酸化物５３０ｂと酸化物５３０ｃの２層構造、または４層以上の積層構造を設ける構成にしてもよい。また、トランジスタ５００では、導電体５６０を２層の積層構造として示しているが、本発明はこれに限られるものではな

50

い。例えば、導電体 5 6 0 が、単層構造であってもよいし、3 層以上の積層構造であってもよい。また、図 6、図 7 A、図 7 B に示すトランジスタ 5 0 0 は一例であり、その構造に限定されず、回路構成や駆動方法に応じて適切なトランジスタを用いればよい。

【0156】

ここで、導電体 5 6 0 は、トランジスタのゲート電極として機能し、導電体 5 4 2 a および導電体 5 4 2 b は、それぞれソース電極またはドレイン電極として機能する。上記のように、導電体 5 6 0 は、絶縁体 5 8 0 の開口、および導電体 5 4 2 a と導電体 5 4 2 b に挟まれた領域に埋め込まれるように形成される。導電体 5 6 0、導電体 5 4 2 a および導電体 5 4 2 b の配置は、絶縁体 5 8 0 の開口に対して、自己整合的に選択される。つまり、トランジスタ 5 0 0 において、ゲート電極を、ソース電極とドレイン電極の間に、自己整合的に配置させることができる。よって、導電体 5 6 0 を位置合わせのマージンを設けることなく形成することができるので、トランジスタ 5 0 0 の占有面積の縮小を図ることができる。これにより、半導体装置の微細化、高集積化を図ることができる。

10

【0157】

さらに、導電体 5 6 0 が、導電体 5 4 2 a と導電体 5 4 2 b の間の領域に自己整合的に形成されるので、導電体 5 6 0 は、導電体 5 4 2 a または導電体 5 4 2 b と重畳する領域を有さない。これにより、導電体 5 6 0 と導電体 5 4 2 a および導電体 5 4 2 b との間に形成される寄生容量を低減することができる。よって、トランジスタ 5 0 0 のスイッチング速度を向上させ、高い周波数特性を有せしめることができる。

20

【0158】

導電体 5 6 0 は、第 1 のゲート電極として機能する場合がある。また、導電体 5 0 3 は、第 2 のゲート電極として機能する場合がある。その場合、導電体 5 0 3 に印加する電位を、導電体 5 6 0 に印加する電位と連動させず、独立して変化させることで、トランジスタ 5 0 0 の V_{th} を制御することができる。特に、導電体 5 0 3 に負の電位を印加することにより、トランジスタ 5 0 0 の V_{th} を 0 V より大きくし、オフ電流を低減することが可能となる。したがって、導電体 5 0 3 に負の電位を印加したほうが、印加しない場合よりも、導電体 5 6 0 に印加する電位が 0 V のときのドレイン電流を小さくすることができる。

【0159】

導電体 5 0 3 は、酸化物 5 3 0、および導電体 5 6 0 と、重なるように配置する。これにより、導電体 5 6 0、および導電体 5 0 3 に電位を印加した場合、導電体 5 6 0 から生じる電界と、導電体 5 0 3 から生じる電界と、がつながり、酸化物 5 3 0 に形成されるチャネル形成領域を覆うことができる。本明細書等において、第 1 のゲート電極、および第 2 のゲート電極の電界によって、チャネル形成領域を電氣的に取り囲むトランジスタの構造を、`surrounded channel (S-channel)` 構造とよぶ。

30

【0160】

また、本明細書等において、`S-channel` 構造は、ソース電極およびドレイン電極として機能する導電体 5 4 2 a および導電体 5 4 2 b に接する酸化物 5 3 0 の側面及び周辺が、チャネル形成領域と同じく I 型であるといった特徴を有する。また、導電体 5 4 2 a および導電体 5 4 2 b に接する酸化物 5 3 0 の側面及び周辺は、絶縁体 5 4 4 と接しているため、チャネル形成領域と同様に I 型となりうる。なお、本明細書等において、I 型とは後述する、高純度真性と同様として扱うことができる。また、本明細書等で開示する `S-channel` 構造は、`Fin` 型構造及びプレーナ型構造とは異なる。`S-channel` 構造を採用することで、短チャネル効果に対する耐性を高める、別言すると短チャネル効果が発生し難いトランジスタとすることができる。

40

【0161】

また、導電体 5 0 3 は、導電体 5 1 8 と同様の構成であり、絶縁体 5 1 4 および絶縁体 5 1 6 の開口の内壁に接して導電体 5 0 3 a が形成され、さらに内側に導電体 5 0 3 b が形成されている。

【0162】

絶縁体 5 2 0、絶縁体 5 2 2、絶縁体 5 2 4、および絶縁体 5 5 0 は、ゲート絶縁膜とし

50

ての機能を有する。

【0163】

ここで、酸化物530と接する絶縁体524は、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む絶縁体を用いることが好ましい。つまり、絶縁体524には、過剰酸素領域が形成されていることが好ましい。このような過剰酸素を含む絶縁体を酸化物530に接して設けることにより、酸化物530中の酸素欠損を低減し、トランジスタ500の信頼性を向上させることができる。

【0164】

過剰酸素領域を有する絶縁体として、具体的には、加熱により一部の酸素が脱離する酸化物材料を用いることが好ましい。加熱により酸素を脱離する酸化物とは、TDS (Thermal Desorption Spectroscopy) 分析にて、酸素原子に換算しての酸素の脱離量が $1.0 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以上、好ましくは $1.0 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 以上、さらに好ましくは $2.0 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 以上、または $3.0 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ 以上である酸化物膜である。なお、上記TDS分析時における膜の表面温度としては100 以上700 以下、または100 以上400 以下の範囲が好ましい。

10

【0165】

また、絶縁体524が、過剰酸素領域を有する場合、絶縁体522は、酸素（例えば、酸素原子、酸素分子など）の拡散を抑制する機能を有する（上記酸素が透過しにくい）ことが好ましい。

20

【0166】

絶縁体522が、酸素や不純物の拡散を抑制する機能を有することで、酸化物530が有する酸素は、絶縁体520側へ拡散することがなく、好ましい。また、導電体503が、絶縁体524や、酸化物530が有する酸素と反応することを抑制することができる。

【0167】

絶縁体522は、例えば、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT)、チタン酸ストロンチウム (SrTiO_3) または (Ba, Sr) TiO_3 (BST) などのいわゆる high-k 材料を含む絶縁体を単層または積層で用いることが好ましい。トランジスタの微細化、および高集積化が進むと、ゲート絶縁膜の薄膜化により、リーク電流などの問題が生じる場合がある。ゲート絶縁膜として機能する絶縁体に high-k 材料を用いることで、物理膜厚を保ちながら、トランジスタ動作時のゲート電位の低減が可能となる。

30

【0168】

特に、不純物、および酸素などの拡散を抑制する機能を有する（上記酸素が透過しにくい）絶縁性材料であるアルミニウムおよびハフニウム的一方または双方の酸化物を含む絶縁体を用いるとよい。アルミニウムおよびハフニウム的一方または双方の酸化物を含む絶縁体として、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、アルミニウムおよびハフニウムを含む酸化物（ハフニウムアルミネート）などを用いることが好ましい。このような材料を用いて絶縁体522を形成した場合、絶縁体522は、酸化物530からの酸素の放出や、トランジスタ500の周辺部から酸化物530への水素等の不純物の混入を抑制する層として機能する。

40

【0169】

または、これらの絶縁体に、例えば、酸化アルミニウム、酸化ビスマス、酸化ゲルマニウム、酸化ニオブ、酸化シリコン、酸化チタン、酸化タングステン、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムを添加してもよい。またはこれらの絶縁体を窒化処理してもよい。上記の絶縁体に酸化シリコン、酸化窒化シリコンまたは窒化シリコンを積層して用いてもよい。

【0170】

また、絶縁体520は、熱的に安定していることが好ましい。例えば、酸化シリコンおよび酸化窒化シリコンは、熱的に安定であるため、好適である。また、high-k 材料の絶縁体を酸化シリコン、または酸化窒化シリコンと組み合わせることで、熱的に安定かつ

50

比誘電率の高い積層構造の絶縁体 520 を得ることができる。

【0171】

なお、絶縁体 520、絶縁体 522、および絶縁体 524 が、2 層以上の積層構造を有していてもよい。その場合、同じ材料からなる積層構造に限定されず、異なる材料からなる積層構造でもよい。

【0172】

トランジスタ 500 は、チャンネル形成領域を含む酸化物 530 に、酸化物半導体として機能する金属酸化物を用いることが好ましい。例えば、酸化物 530 として、In - M - Zn 酸化物（元素 M は、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、銅、バナジウム、ペリリウム、ホウ素、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、またはマグネシウムなどから選ばれた一種、または複数種）等の金属酸化物を用いるとよい。また、酸化物 530 として、In - Ga 酸化物、In - Zn 酸化物を用いてもよい。

10

【0173】

なお、酸化物半導体として機能する金属酸化物の形成は、スパッタリング法で行なってもよいし、ALD (Atomic Layer Deposition) 法で行なってもよい。酸化物半導体として機能する金属酸化物については、他の実施の形態で説明する。

【0174】

また、トランジスタ 500 には、キャリア密度の低い金属酸化物を用いることが好ましい。金属酸化物のキャリア密度を低くする場合においては、金属酸化物中の不純物濃度を低くし、欠陥準位密度を低くすればよい。本明細書等において、不純物濃度が低く、欠陥準位密度の低いことを高純度真性または実質的に高純度真性という。なお、金属酸化物中の不純物としては、例えば、水素、窒素、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄、ニッケル、シリコン等がある。

20

【0175】

特に、金属酸化物に含まれる水素は、金属原子と結合する酸素と反応して水になるため、金属酸化物中に酸素欠損を形成する場合がある。金属酸化物中のチャンネル形成領域に酸素欠損が含まれていると、トランジスタはノーマリーオン特性となる場合がある。さらに、酸素欠損に水素が入った欠陥はドナーとして機能し、キャリアである電子が生成されることがある。また、水素の一部が金属原子と結合する酸素と結合して、キャリアである電子を生成する場合がある。従って、水素が多く含まれている金属酸化物を用いたトランジスタは、ノーマリーオン特性となりやすい。

30

【0176】

酸素欠損に水素が入った欠陥は、金属酸化物のドナーとして機能しうる。しかしながら、当該欠陥を定量的に評価することは困難である。そこで、金属酸化物においては、ドナー濃度ではなく、キャリア密度で評価される場合がある。よって、本明細書等では、金属酸化物のパラメータとして、ドナー濃度ではなく、電界が印加されない状態を想定したキャリア密度を用いる場合がある。つまり、本明細書等に記載の「キャリア密度」は、「ドナー濃度」と言い換えることができる場合がある。

【0177】

よって、金属酸化物を酸化物 530 に用いる場合、金属酸化物中の水素はできる限り低減されていることが好ましい。具体的には、金属酸化物において、二次イオン質量分析法 (SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry) により得られる水素濃度を、 $1 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ 未満、好ましくは $1 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 未満、より好ましくは $5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 未満、さらに好ましくは $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 未満とする。水素などの不純物が十分に低減された金属酸化物をトランジスタのチャンネル形成領域に用いることで、安定した電気特性を付与することができる。

40

【0178】

また、酸化物 530 に金属酸化物を用いる場合、チャンネル形成領域の金属酸化物のキャリ

50

ア密度は、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 以下であることが好ましく、 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 未満であることがより好ましく、 $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 未満であることがさらに好ましく、 $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ 未満であることがさらに好ましく、 $1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 未満であることがさらに好ましい。なお、チャネル形成領域の金属酸化物のキャリア密度の下限值については、特に限定は無いが、例えば、 $1 \times 10^{-9} \text{ cm}^{-3}$ とすることができる。

【0179】

また、酸化物530に金属酸化物を用いる場合、導電体542（導電体542a、および導電体542b）と酸化物530とが接することで、酸化物530中の酸素が導電体542へ拡散し、導電体542が酸化する場合がある。導電体542が酸化することで、導電体542の導電率が低下する蓋然性が高い。なお、酸化物530中の酸素が導電体542へ拡散することを、導電体542が酸化物530中の酸素を吸収する、と言い換えることができる。

10

【0180】

また、酸化物530中の酸素が導電体542（導電体542a、および導電体542b）へ拡散することで、導電体542aと酸化物530bとの間、および、導電体542bと酸化物530bとの間に異層が形成される場合がある。当該異層は、導電体542よりも酸素を多く含むため、当該異層は絶縁性を有すると推定される。このとき、導電体542と、当該異層と、酸化物530bとの3層構造は、金属-絶縁体-半導体からなる3層構造とみなすことができ、MIS（Metal - Insulator - Semiconductor）構造、またはMIS構造を主としたダイオード接合構造と呼ぶ場合がある。

20

【0181】

なお、上記異層は、導電体542と酸化物530bとの間に形成されることに限られず、例えば、異層が、導電体542と酸化物530cとの間に形成される場合や、導電体542と酸化物530bとの間、および導電体542と酸化物530cとの間に形成される場合がある。

【0182】

また、酸化物530においてチャネル形成領域として機能する金属酸化物は、バンドギャップが2 eV以上、好ましくは2.5 eV以上のものを用いることが好ましい。このように、バンドギャップの大きい金属酸化物を用いることで、トランジスタのオフ電流を低減することができる。

30

【0183】

その他、酸化物530に用いることができる半導体材料は、上述の金属酸化物に限られない。酸化物530として、バンドギャップを有する半導体材料（ゼロギャップ半導体ではない半導体材料）を用いてもよい。例えば、シリコンなどの単体元素の半導体、ヒ化ガリウムなどの化合物半導体、半導体として機能する層状物質（原子層物質、2次元材料などともいう）などを半導体材料に用いることが好ましい。特に、半導体として機能する層状物質を半導体材料に用いると好適である。

【0184】

ここで、本明細書等において、層状物質とは、層状の結晶構造を有する材料群の総称である。層状の結晶構造は、共有結合やイオン結合によって形成される層が、ファンデルワールス力のような、共有結合やイオン結合よりも弱い結合を介して積層している構造である。層状物質は、単位層内における電気伝導性が高く、つまり、2次元電気伝導性が高い。半導体として機能し、かつ、2次元電気伝導性の高い材料をチャネル形成領域に用いることで、オン電流の大きいトランジスタを提供することができる。

40

【0185】

層状物質として、グラフェン、シリセン、カルコゲン化物などがある。カルコゲン化物は、カルコゲンを含む化合物である。また、カルコゲンは、第16族に属する元素の総称であり、酸素、硫黄、セレン、テルル、ポロニウム、リバモリウムが含まれる。また、カルコゲン化物として、遷移金属カルコゲナイド、13族カルコゲナイドなどが挙げられる。

【0186】

50

酸化物 530 として、例えば、半導体として機能する遷移金属カルコゲナイドを用いることが好ましい。酸化物 530 として適用可能な遷移金属カルコゲナイドとして、具体的には、硫化モリブデン（代表的には MoS_2 ）、セレン化モリブデン（代表的には MoSe_2 ）、モリブデンテルル（代表的には MoTe_2 ）、硫化タングステン（代表的には WS_2 ）、セレン化タングステン（代表的には WSe_2 ）、タングステンテルル（代表的には WTe_2 ）、硫化ハフニウム（代表的には HfS_2 ）、セレン化ハフニウム（代表的には HfSe_2 ）、硫化ジルコニウム（代表的には ZrS_2 ）、セレン化ジルコニウム（代表的には ZrSe_2 ）などが挙げられる。

【0187】

酸化物 530 は、酸化物 530 b 下に酸化物 530 a を有することで、酸化物 530 a よりも下方に形成された構造物から、酸化物 530 b への不純物の拡散を抑制することができる。また、酸化物 530 b 上に酸化物 530 c を有することで、酸化物 530 c よりも上方に形成された構造物から、酸化物 530 b への不純物の拡散を抑制することができる。

【0188】

なお、酸化物 530 は、各金属原子の原子数比が異なる複数の酸化物層の積層構造を有することが好ましい。具体的には、酸化物 530 a に用いる金属酸化物において、構成元素中の元素 M の原子数比が、酸化物 530 b に用いる金属酸化物における、構成元素中の元素 M の原子数比より、大きいことが好ましい。また、酸化物 530 a に用いる金属酸化物において、In に対する元素 M の原子数比が、酸化物 530 b に用いる金属酸化物における、In に対する元素 M の原子数比より大きいことが好ましい。また、酸化物 530 b に用いる金属酸化物において、元素 M に対する In の原子数比が、酸化物 530 a に用いる金属酸化物における、元素 M に対する In の原子数比より大きいことが好ましい。また、酸化物 530 c は、酸化物 530 a または酸化物 530 b に用いることができる金属酸化物を、用いることができる。

【0189】

また、酸化物 530 a および酸化物 530 c の伝導帯下端のエネルギーが、酸化物 530 b の伝導帯下端のエネルギーより高くなることが好ましい。また、言い換えると、酸化物 530 a および酸化物 530 c の電子親和力が、酸化物 530 b の電子親和力より小さいことが好ましい。

【0190】

ここで、酸化物 530 a、酸化物 530 b、および酸化物 530 c の接合部において、伝導帯下端のエネルギー準位はなだらかに変化する。換言すると、酸化物 530 a、酸化物 530 b、および酸化物 530 c の接合部における伝導帯下端のエネルギー準位は、連続的に変化または連続接合するともいうことができる。このようにするためには、酸化物 530 a と酸化物 530 b との界面、および酸化物 530 b と酸化物 530 c との界面において形成される混合層の欠陥準位密度を低くするとよい。

【0191】

具体的には、酸化物 530 a と酸化物 530 b、酸化物 530 b と酸化物 530 c が、酸素以外に共通の元素を有する（主成分とする）ことで、欠陥準位密度が低い混合層を形成することができる。例えば、酸化物 530 b が In - Ga - Zn 酸化物の場合、酸化物 530 a および酸化物 530 c として、In - Ga - Zn 酸化物、Ga - Zn 酸化物、酸化ガリウムなどを用いるとよい。

【0192】

このとき、キャリアの主たる経路は酸化物 530 b となる。酸化物 530 a、酸化物 530 c を上述の構成とすることで、酸化物 530 a と酸化物 530 b との界面、および酸化物 530 b と酸化物 530 c との界面における欠陥準位密度を低くすることができる。そのため、界面散乱によるキャリア伝導への影響が小さくなり、トランジスタ 500 は高いオン電流を得られる。

【0193】

酸化物 530 b 上には、ソース電極、およびドレイン電極として機能する導電体 542（

導電体 5 4 2 a、および導電体 5 4 2 b) が設けられる。導電体 5 4 2 としては、アルミニウム、クロム、銅、銀、金、白金、タンタル、ニッケル、チタン、モリブデン、タングステン、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、マンガン、マグネシウム、ジルコニウム、ベリリウム、インジウム、ルテニウム、イリジウム、ストロンチウム、ランタンから選ばれた金属元素、または上述した金属元素を成分とする合金か、上述した金属元素を組み合わせた合金等を用いることが好ましい。例えば、窒化タンタル、窒化チタン、タングステン、チタンとアルミニウムを含む窒化物、タンタルとアルミニウムを含む窒化物、酸化ルテニウム、窒化ルテニウム、ストロンチウムとルテニウムを含む酸化物、ランタンとニッケルを含む酸化物などを用いることが好ましい。また、窒化タンタル、窒化チタン、チタンとアルミニウムを含む窒化物、タンタルとアルミニウムを含む窒化物、酸化ルテニウム、窒化ルテニウム、ストロンチウムとルテニウムを含む酸化物、ランタンとニッケルを含む酸化物は、酸化しにくい導電性材料、または、酸素を吸収しても導電性を維持する材料であるため、好ましい。

10

【0194】

また、図 7 A に示すように、酸化物 5 3 0 の、導電体 5 4 2 との界面とその近傍には、低抵抗領域として、領域 5 4 3 (領域 5 4 3 a、および領域 5 4 3 b) が形成される場合がある。このとき、領域 5 4 3 a はソース領域またはドレイン領域の一方として機能し、領域 5 4 3 b はソース領域またはドレイン領域の他方として機能する。また、領域 5 4 3 a と領域 5 4 3 b に挟まれる領域にチャネル形成領域が形成される。

【0195】

酸化物 5 3 0 と接するように上記導電体 5 4 2 を設けることで、領域 5 4 3 の酸素濃度が低減する場合がある。また、領域 5 4 3 に導電体 5 4 2 に含まれる金属と、酸化物 5 3 0 の成分とを含む金属化合物層が形成される場合がある。このような場合、領域 5 4 3 のキャリア密度が増加し、領域 5 4 3 は、低抵抗領域となる。

20

【0196】

絶縁体 5 4 4 は、導電体 5 4 2 を覆うように設けられ、導電体 5 4 2 の酸化を抑制する。このとき、絶縁体 5 4 4 は、酸化物 5 3 0 の側面を覆い、絶縁体 5 2 4 と接するように設けられてもよい。

【0197】

絶縁体 5 4 4 として、ハフニウム、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、ジルコニウム、タングステン、チタン、タンタル、ニッケル、ゲルマニウム、または、マグネシウムなどから選ばれた一種、または二種以上が含まれた金属酸化物を用いることができる。

30

【0198】

特に、絶縁体 5 4 4 として、アルミニウム、またはハフニウムの一方または双方の酸化物を含む絶縁体である、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、アルミニウムおよびハフニウムを含む酸化物(ハフニウムアルミネート)などを用いることが好ましい。特に、ハフニウムアルミネートは、酸化ハフニウム膜よりも、耐熱性が高い。そのため、後の工程での熱処理において、結晶化しにくいため好ましい。なお、導電体 5 4 2 が耐酸化性を有する材料、または、酸素を吸収しても著しく導電性が低下しない場合、絶縁体 5 4 4 は、必須の構成ではない。求めるトランジスタ特性により、適宜設計すればよい。

40

【0199】

絶縁体 5 5 0 は、ゲート絶縁膜として機能する。絶縁体 5 5 0 は、酸化物 5 3 0 c の内側(上面および側面)に接して配置することが好ましい。絶縁体 5 5 0 は、加熱により酸素が放出される絶縁体を用いて形成することが好ましい。例えば、TDS 分析にて、酸素原子に換算しての酸素の脱離量が $1.0 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以上、好ましくは $1.0 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 以上、さらに好ましくは $2.0 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 以上、または $3.0 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ 以上である酸化物膜である。なお、上記 TDS 分析時における膜の表面温度としては 100 以上 700 以下の範囲が好ましい。

【0200】

50

具体的には、過剰酸素を有する酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、フッ素を添加した酸化シリコン、炭素を添加した酸化シリコン、炭素および窒素を添加した酸化シリコン、空孔を有する酸化シリコンを用いることができる。特に、酸化シリコン、および酸化窒化シリコンは熱に対し安定であるため好ましい。

【0201】

加熱により酸素が放出される絶縁体を、絶縁体550として、酸化物530cの上面に接して設けることにより、絶縁体550から、酸化物530cを通じて、酸化物530bのチャネル形成領域に効果的に酸素を供給することができる。また、絶縁体524と同様に、絶縁体550中の水または水素などの不純物濃度が低減されていることが好ましい。絶縁体550の膜厚は、1nm以上20nm以下とするのが好ましい。

10

【0202】

また、絶縁体550が有する過剰酸素を、効率的に酸化物530へ供給するために、絶縁体550と導電体560との間に金属酸化物を設けてもよい。当該金属酸化物は、絶縁体550から導電体560への酸素拡散を抑制することが好ましい。酸素の拡散を抑制する金属酸化物を設けることで、絶縁体550から導電体560への過剰酸素の拡散が抑制される。つまり、酸化物530へ供給する過剰酸素量の減少を抑制することができる。また、過剰酸素による導電体560の酸化を抑制することができる。当該金属酸化物としては、絶縁体544に用いることができる材料を用いればよい。

【0203】

第1のゲート電極として機能する導電体560は、図7A、図7Bでは2層構造として示しているが、単層構造でもよいし、3層以上の積層構造であってもよい。

20

【0204】

導電体560aは、水素原子、水素分子、水分子、窒素原子、窒素分子、酸化窒素分子(N_2O 、 NO 、 NO_2 など)、銅原子などの不純物の拡散を抑制する機能を有する導電性材料を用いることが好ましい。または、酸素(例えば、酸素原子、酸素分子などの少なくとも一つ)の拡散を抑制する機能を有する導電性材料を用いることが好ましい。導電体560aが酸素の拡散を抑制する機能を持つことにより、絶縁体550に含まれる酸素により、導電体560bが酸化して導電率が低下することを抑制することができる。酸素の拡散を抑制する機能を有する導電性材料としては、例えば、タンタル、窒化タンタル、ルテニウム、または酸化ルテニウムなどを用いることが好ましい。

30

【0205】

また、導電体560bは、タングステン、銅、またはアルミニウムを主成分とする導電性材料を用いることが好ましい。また、導電体560bは、配線としても機能するため、導電性が高い導電体を用いることが好ましい。例えば、タングステン、銅、またはアルミニウムを主成分とする導電性材料を用いることができる。また、導電体560bは積層構造としてもよく、例えば、チタン又は窒化チタンと上記導電性材料との積層構造としてもよい。

【0206】

絶縁体580は、絶縁体544を介して、導電体542上に設けられる。絶縁体580は、過剰酸素領域を有することが好ましい。例えば、絶縁体580として、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、フッ素を添加した酸化シリコン、炭素を添加した酸化シリコン、炭素および窒素を添加した酸化シリコン、空孔を有する酸化シリコン、または樹脂などを有することが好ましい。特に、酸化シリコンおよび酸化窒化シリコンは、熱的に安定であるため好ましい。特に、酸化シリコン、空孔を有する酸化シリコンは、後の工程で、容易に過剰酸素領域を形成することができるため好ましい。

40

【0207】

また、加熱により酸素が放出される絶縁体580を、酸化物530cと接して設けることで、絶縁体580中の酸素を、酸化物530cを通じて、酸化物530へと効率良く供給することができる。なお、絶縁体580中の水または水素などの不純物濃度が低減されていることが好ましい。

50

【0208】

絶縁体580の開口は、導電体542aと導電体542bの間の領域に重畳して形成される。これにより、導電体560は、絶縁体580の開口、および導電体542aと導電体542bに挟まれた領域に、埋め込まれるように形成される。

【0209】

半導体装置を微細化するに当たり、ゲート長を短くすることが求められるが、導電体560の導電性が下がらないようにする必要がある。そのために導電体560の膜厚を大きくすると、導電体560はアスペクト比が高い形状となりうる。本実施の形態では、導電体560を絶縁体580の開口に埋め込むように設けるため、導電体560をアスペクト比の高い形状にしても、工程中に導電体560を倒壊させることなく、形成することができる。

10

【0210】

絶縁体574は、絶縁体580の上面、導電体560の上面、および絶縁体550の上面に接して設けられることが好ましい。絶縁体574をスパッタリング法で成膜することで、絶縁体550および絶縁体580へ過剰酸素領域を設けることができる。これにより、当該過剰酸素領域から、酸化物530中に酸素を供給することができる。

【0211】

例えば、絶縁体574として、ハフニウム、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、ジルコニウム、タングステン、チタン、タンタル、ニッケル、ゲルマニウム、またはマグネシウムなどから選ばれた一種、または二種以上が含まれた金属酸化物を用いることができる。

20

【0212】

特に、酸化アルミニウムはバリア性が高く、0.5nm以上3.0nm以下の薄膜であっても、水素、および窒素の拡散を抑制することができる。したがって、スパッタリング法で成膜した酸化アルミニウムは、酸素供給源であるとともに、水素などの不純物のバリア膜としての機能も有することができる。

【0213】

また、絶縁体574の上に、層間膜として機能する絶縁体581を設けることが好ましい。絶縁体581は、絶縁体524などと同様に、膜中の水または水素などの不純物濃度が低減されていることが好ましい。

30

【0214】

また、絶縁体581、絶縁体574、絶縁体580、および絶縁体544に形成された開口に、導電体540aおよび導電体540bを配置する。導電体540aおよび導電体540bは、導電体560を挟んで対向して設ける。導電体540aおよび導電体540bは、後述する導電体546および導電体548と同様の構成である。

【0215】

絶縁体581上には、絶縁体582が設けられている。絶縁体582は、酸素や水素に対してバリア性のある物質を用いることが好ましい。したがって、絶縁体582には、絶縁体514と同様の材料を用いることができる。例えば、絶縁体582には、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタルなどの金属酸化物を用いることが好ましい。

40

【0216】

特に、酸化アルミニウムは、酸素、およびトランジスタの電気特性の変動要因となる水素、水分などの不純物、の両方に対して膜を透過させない遮断効果が高い。したがって、酸化アルミニウムは、トランジスタの作製工程中および作製後において、水素、水分などの不純物のトランジスタ500への混入を防止することができる。また、トランジスタ500を構成する酸化物からの酸素の放出を抑制することができる。そのため、トランジスタ500に対する保護膜として用いることに適している。

【0217】

また、絶縁体582上には、絶縁体586が設けられている。絶縁体586は、絶縁体320と同様の材料を用いることができる。また、比較的誘電率が低い材料を層間膜とする

50

ことで、配線間に生じる寄生容量を低減することができる。例えば、絶縁体 5 8 6 として、酸化シリコン膜や酸化窒化シリコン膜などを用いることができる。

【 0 2 1 8 】

また、絶縁体 5 2 0、絶縁体 5 2 2、絶縁体 5 2 4、絶縁体 5 4 4、絶縁体 5 8 0、絶縁体 5 7 4、絶縁体 5 8 1、絶縁体 5 8 2、および絶縁体 5 8 6 には、導電体 5 4 6、および導電体 5 4 8 等が埋め込まれている。

【 0 2 1 9 】

導電体 5 4 6、および導電体 5 4 8 は、容量素子 6 0 0、トランジスタ 5 0 0、またはトランジスタ 3 0 0 と接続するプラグ、または配線としての機能を有する。導電体 5 4 6、および導電体 5 4 8 は、導電体 3 2 8、および導電体 3 3 0 と同様の材料を用いて設けることができる。

10

【 0 2 2 0 】

続いて、トランジスタ 5 0 0 の上方には、容量素子 6 0 0 が設けられている。容量素子 6 0 0 は、導電体 6 1 0 と、導電体 6 2 0、絶縁体 6 3 0 とを有する。

【 0 2 2 1 】

また、導電体 5 4 6、および導電体 5 4 8 上に、導電体 6 1 2 を設けてもよい。導電体 6 1 2 は、トランジスタ 5 0 0 と接続するプラグ、または配線としての機能を有する。導電体 6 1 0 は、容量素子 6 0 0 の電極としての機能を有する。なお、導電体 6 1 2、および導電体 6 1 0 は、同時に形成することができる。

【 0 2 2 2 】

導電体 6 1 2、および導電体 6 1 0 には、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン、アルミニウム、銅、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素を含む金属膜、または上述した元素を成分とする金属窒化物膜（窒化タンタル膜、窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タングステン膜）等を用いることができる。または、インジウム錫酸化物、酸化タングステンを含むインジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの導電性材料を適用することもできる。

20

【 0 2 2 3 】

図 6 では、導電体 6 1 2、および導電体 6 1 0 は単層構造として示しているが、当該構成に限定されず、2 層以上の積層構造でもよい。例えば、バリア性を有する導電体と導電性が高い導電体との間に、バリア性を有する導電体、および導電性が高い導電体に対して密着性が高い導電体を形成してもよい。

30

【 0 2 2 4 】

絶縁体 6 3 0 を介して、導電体 6 1 0 と重畳するように、導電体 6 2 0 を設ける。なお、導電体 6 2 0 は、金属材料、合金材料、または金属酸化物材料などの導電性材料を用いることができる。耐熱性と導電性を両立するタングステンやモリブデンなどの高融点材料を用いることが好ましく、特にタングステンを用いることが好ましい。また、導電体などの他の構造と同時に形成する場合は、低抵抗金属材料である Cu（銅）や Al（アルミニウム）等を用いればよい。

40

【 0 2 2 5 】

導電体 6 2 0、および絶縁体 6 3 0 上には、絶縁体 6 5 0 が設けられている。絶縁体 6 5 0 は、絶縁体 3 2 0 と同様の材料を用いて設けることができる。また、絶縁体 6 5 0 は、その下方の凹凸形状を被覆する平坦化膜として機能してもよい。

【 0 2 2 6 】

本構造を用いることで、酸化物半導体を有するトランジスタを用いた半導体装置において、電気特性の変動を抑制するとともに、信頼性を向上させることができる。または、オン電流が大きい酸化物半導体を有するトランジスタを提供することができる。または、オフ電流が小さい酸化物半導体を有するトランジスタを提供することができる。または、消費電力が低減された半導体装置を提供することができる。または、酸化物半導体を有するト

50

ランジスタを用いた半導体装置において、微細化または高集積化を図ることができる。

【0227】

<トランジスタの構造例>

なお、本実施の形態に示す半導体装置のトランジスタ500は、上記の構造に限られるものではない。以下、トランジスタ500に用いることができる構造例について説明する。

【0228】

<トランジスタの構造例1>

図8A、図8Bおよび図8Cを用いてトランジスタ510Aの構造例を説明する。図8Aはトランジスタ510Aの上面図である。図8Bは、図8Aに一点鎖線L1-L2で示す部位の断面図である。図8Cは、図8Aに一点鎖線W1-W2で示す部位の断面図である。なお、図8Aの上面図では、図の明瞭化のために一部の要素を省いている。

10

【0229】

図8A、図8Bおよび図8Cでは、トランジスタ510Aと、層間膜として機能する絶縁体511、絶縁体512、絶縁体514、絶縁体516、絶縁体580、絶縁体582、および絶縁体584を示している。また、トランジスタ510Aと電氣的に接続し、コンタクトプラグとして機能する導電体546（導電体546a、および導電体546b）と、配線として機能する導電体503と、を示している。

【0230】

トランジスタ510Aは、第1のゲート電極として機能する導電体560（導電体560a、および導電体560b）と、第2のゲート電極として機能する導電体505（導電体505a、および導電体505b）と、第1のゲート絶縁膜として機能する絶縁体550と、第2のゲート絶縁膜として機能する絶縁体521、絶縁体522、および絶縁体524と、チャンネルが形成される領域を有する酸化物530（酸化物530a、酸化物530b、および酸化物530c）と、ソースまたはドレインの一方として機能する導電体542aと、ソースまたはドレインの他方として機能する導電体542bと、絶縁体574とを有する。

20

【0231】

また、図8に示すトランジスタ510Aでは、酸化物530c、絶縁体550、および導電体560が、絶縁体580に設けられた開口部内に、絶縁体574を介して配置される。また、酸化物530c、絶縁体550、および導電体560は、導電体542a、および導電体542bとの間に配置される。

30

【0232】

絶縁体511、および絶縁体512は、層間膜として機能する。

【0233】

層間膜としては、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、チタン酸ジルコン酸鉛（PZT）、チタン酸ストロンチウム（SrTiO₃）または（Ba, Sr）TiO₃（BST）などの絶縁体を単層または積層で用いることができる。またはこれらの絶縁体に、例えば、酸化アルミニウム、酸化ビスマス、酸化ゲルマニウム、酸化ニオブ、酸化シリコン、酸化チタン、酸化タングステン、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムを添加してもよい。またはこれらの絶縁体を窒化処理してもよい。上記の絶縁体に酸化シリコン、酸化窒化シリコンまたは窒化シリコンを積層して用いてもよい。

40

【0234】

例えば、絶縁体511は、水または水素などの不純物が、基板側からトランジスタ510Aに混入するのを抑制するバリア膜として機能することが好ましい。したがって、絶縁体511は、水素原子、水素分子、水分子、銅原子などの不純物の拡散を抑制する機能を有する（上記不純物が透過しにくい）絶縁性材料を用いることが好ましい。または、酸素（例えば、酸素原子、酸素分子などの少なくとも一つ）の拡散を抑制する機能を有する（上記酸素が透過しにくい）絶縁性材料を用いることが好ましい。また、例えば、絶縁体511として酸化アルミニウムや窒化シリコンなどを用いてもよい。当該構成により、水素、

50

水などの不純物が絶縁体 5 1 1 よりも基板側からトランジスタ 5 1 0 A 側に拡散するのを抑制することができる。

【 0 2 3 5 】

例えば、絶縁体 5 1 2 は、絶縁体 5 1 1 よりも誘電率が低いことが好ましい。誘電率が低い材料を層間膜とすることで、配線間に生じる寄生容量を低減することができる。

【 0 2 3 6 】

導電体 5 0 3 は、絶縁体 5 1 2 に埋め込まれるように形成される。ここで、導電体 5 0 3 の上面の高さと、絶縁体 5 1 2 の上面の高さは同程度にできる。なお導電体 5 0 3 は、単層とする構成について示しているが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、導電体 5 0 3 を 2 層以上の多層膜構造としてもよい。なお、導電体 5 0 3 は、タンゲステン、銅、またはアルミニウムを主成分とする導電性が高い導電性材料を用いることが好ましい。

10

【 0 2 3 7 】

トランジスタ 5 1 0 A において、導電体 5 6 0 は、第 1 のゲート電極として機能する場合がある。また、導電体 5 0 5 は、第 2 のゲート電極として機能する場合がある。その場合、導電体 5 0 5 に印加する電位を、導電体 5 6 0 に印加する電位と連動させず、独立して変化させることで、トランジスタ 5 1 0 A のしきい値電圧を制御することができる。特に、導電体 5 0 5 に負の電位を印加することにより、トランジスタ 5 1 0 A のしきい値電圧を 0 V より大きくし、オフ電流を低減することが可能となる。したがって、導電体 5 0 5 に負の電位を印加したほうが、印加しない場合よりも、導電体 5 6 0 に印加する電位が 0 V のときのドレイン電流を小さくすることができる。

20

【 0 2 3 8 】

また、例えば、導電体 5 0 5 と、導電体 5 6 0 とを重畳して設けることで、導電体 5 6 0 、および導電体 5 0 5 に電位を印加した場合、導電体 5 6 0 から生じる電界と、導電体 5 0 5 から生じる電界と、がつながり、酸化物 5 3 0 に形成されるチャネル形成領域を覆うことができる。

【 0 2 3 9 】

つまり、第 1 のゲート電極としての機能を有する導電体 5 6 0 の電界と、第 2 のゲート電極としての機能を有する導電体 5 0 5 の電界によって、チャネル形成領域を電気的に取り囲むことができる。すなわち、先に記載のトランジスタ 5 0 0 と同様に、surrounded channel (S - channel) 構造である。

30

【 0 2 4 0 】

絶縁体 5 1 4 、および絶縁体 5 1 6 は、絶縁体 5 1 1 または絶縁体 5 1 2 と同様に、層間膜として機能する。例えば、絶縁体 5 1 4 は、水または水素などの不純物が、基板側からトランジスタ 5 1 0 A に混入するのを抑制するバリア膜として機能することが好ましい。当該構成により、水素、水などの不純物が絶縁体 5 1 4 よりも基板側からトランジスタ 5 1 0 A 側に拡散するのを抑制することができる。また、例えば、絶縁体 5 1 6 は、絶縁体 5 1 4 よりも誘電率が低いことが好ましい。誘電率が低い材料を層間膜とすることで、配線間に生じる寄生容量を低減することができる。

【 0 2 4 1 】

40

第 2 のゲートとして機能する導電体 5 0 5 は、絶縁体 5 1 4 および絶縁体 5 1 6 の開口の内壁に接して導電体 5 0 5 a が形成され、さらに内側に導電体 5 0 5 b が形成されている。ここで、導電体 5 0 5 a および導電体 5 0 5 b の上面の高さと、絶縁体 5 1 6 の上面の高さは同程度にできる。なお、トランジスタ 5 1 0 A では、導電体 5 0 5 a および導電体 5 0 5 b を積層する構成について示しているが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、導電体 5 0 5 は、単層、または 3 層以上の積層構造として設ける構成にしてもよい。

【 0 2 4 2 】

ここで、導電体 5 0 5 a は、水素原子、水素分子、水分子、銅原子などの不純物の拡散を抑制する機能を有する（上記不純物が透過しにくい）導電性材料を用いることが好ましい

50

。または、酸素（例えば、酸素原子、酸素分子などの少なくとも一つ）の拡散を抑制する機能を有する（上記酸素が透過しにくい）導電性材料を用いることが好ましい。なお、本明細書等において、不純物、または酸素の拡散を抑制する機能とは、上記不純物、または上記酸素のいずれか一つ、または、すべての拡散を抑制する機能とする。

【0243】

例えば、導電体505aが酸素の拡散を抑制する機能を持つことにより、導電体505bが酸化して導電率が低下することを抑制することができる。

【0244】

また、導電体505が配線の機能を兼ねる場合、導電体505bは、タングステン、銅、またはアルミニウムを主成分とする、導電性が高い導電性材料を用いることが好ましい。その場合、導電体503は、必ずしも設けなくともよい。なお、導電体505bを単層で図示したが、積層構造としてもよく、例えば、チタン又は窒化チタンと上記導電性材料との積層としてもよい。

【0245】

絶縁体521、絶縁体522、および絶縁体524は、第2のゲート絶縁膜としての機能を有する。

【0246】

また、絶縁体522は、バリア性を有することが好ましい。絶縁体522がバリア性を有することで、トランジスタ510Aの周辺部からトランジスタ510Aへの水素等の不純物の混入を抑制する層として機能する。

【0247】

絶縁体522は、例えば、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、アルミニウムおよびハフニウムを含む酸化物（ハフニウムアルミネート）、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、チタン酸ジルコン酸鉛（PZT）、チタン酸ストロンチウム（ SrTiO_3 ）または（ Ba, SrTiO_3 （BST））などのいわゆるhigh-k材料を含む絶縁体を単層または積層で用いることが好ましい。トランジスタの微細化、および高集積化が進むと、ゲート絶縁膜の薄膜化により、リーク電流などの問題が生じる場合がある。ゲート絶縁膜として機能する絶縁体にhigh-k材料を用いることで、物理膜厚を保ちながら、トランジスタ動作時のゲート電位の低減が可能となる。

【0248】

また、絶縁体521は、熱的に安定していることが好ましい。例えば、酸化シリコンおよび酸化窒化シリコンは、熱的に安定であるため、好適である。また、high-k材料の絶縁体を酸化シリコン、または酸化窒化シリコンと組み合わせることで、熱的に安定かつ比誘電率の高い積層構造の絶縁体521を得ることができる。

【0249】

なお、図8には、第2のゲート絶縁膜として、3層の積層構造を示したが、2層以下、または4層以上の積層構造としてもよい。その場合、同じ材料からなる積層構造に限定されず、異なる材料からなる積層構造でもよい。

【0250】

チャンネル形成領域として機能する領域を有する酸化物530は、酸化物530aと、酸化物530a上の酸化物530bと、酸化物530b上の酸化物530cと、を有する。酸化物530b下に酸化物530aを有することで、酸化物530aよりも下方に形成された構造物から、酸化物530bへの不純物の拡散を抑制することができる。また、酸化物530b上に酸化物530cを有することで、酸化物530cよりも上方に形成された構造物から、酸化物530bへの不純物の拡散を抑制することができる。酸化物530として、上述した金属酸化物の一種である酸化物半導体を用いることができる。

【0251】

なお、酸化物530cは、絶縁体580に設けられた開口部内に、絶縁体574を介して設けられることが好ましい。絶縁体574がバリア性を有する場合、絶縁体580からの不純物が酸化物530へと拡散することを抑制することができる。

【 0 2 5 2 】

導電体 5 4 2 は、一方がソース電極として機能し、他方がドレイン電極として機能する。

【 0 2 5 3 】

導電体 5 4 2 a と、導電体 5 4 2 b とは、アルミニウム、チタン、クロム、ニッケル、銅、イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、銀、タンタル、またはタングステンなどの金属、またはこれを主成分とする合金を用いることができる。特に、窒化タンタルなどの金属窒化物膜は、水素または酸素に対するバリア性があり、また、耐酸化性が高いため、好ましい。

【 0 2 5 4 】

また、図 8 では単層構造を示したが、2 層以上の積層構造としてもよい。例えば、窒化タンタル膜とタングステン膜を積層するとよい。また、チタン膜とアルミニウム膜を積層してもよい。また、タングステン膜上にアルミニウム膜を積層する二層構造、銅 - マグネシウム - アルミニウム合金膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜上に銅膜を積層する二層構造、タングステン膜上に銅膜を積層する二層構造としてもよい。

10

【 0 2 5 5 】

また、チタン膜または窒化チタン膜と、そのチタン膜または窒化チタン膜上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にチタン膜または窒化チタン膜を形成する三層構造、モリブデン膜または窒化モリブデン膜と、そのモリブデン膜または窒化モリブデン膜上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にモリブデン膜または窒化モリブデン膜を形成する三層構造等がある。なお、酸化インジウム、酸化錫または酸化亜鉛を含む透明導電材料を用いてもよい。

20

【 0 2 5 6 】

また、導電体 5 4 2 上に、バリア層を設けてもよい。バリア層は、酸素、または水素に対してバリア性を有する物質を用いることが好ましい。当該構成により、絶縁体 5 7 4 を成膜する際に、導電体 5 4 2 が酸化することを抑制することができる。

【 0 2 5 7 】

バリア層には、例えば、金属酸化物を用いることができる。特に、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウムなどの、酸素や水素に対してバリア性のある絶縁膜を用いることが好ましい。また、CVD法で形成した窒化シリコンを用いてもよい。

【 0 2 5 8 】

バリア層を有することで、導電体 5 4 2 の材料選択の幅を広げることができる。例えば、導電体 5 4 2 に、タングステンや、アルミニウムなどの耐酸化性が低い一方で導電性が高い材料を用いることができる。また、例えば、成膜、または加工がしやすい導電体を用いることができる。

30

【 0 2 5 9 】

絶縁体 5 5 0 は、第 1 のゲート絶縁膜として機能する。絶縁体 5 5 0 は、絶縁体 5 8 0 に設けられた開口部内に、酸化物 5 3 0 c、および絶縁体 5 7 4 を介して設けられることが好ましい。

【 0 2 6 0 】

トランジスタの微細化、および高集積化が進むと、ゲート絶縁膜の薄膜化により、リーク電流などの問題が生じる場合がある。その場合、絶縁体 5 5 0 は、第 2 のゲート絶縁膜と同様に、積層構造としてもよい。ゲート絶縁膜として機能する絶縁体を、high-k材料と、熱的に安定している材料との積層構造とすることで、物理膜厚を保ちながら、トランジスタ動作時のゲート電位の低減が可能となる。また、熱的に安定かつ比誘電率の高い積層構造とすることができる。

40

【 0 2 6 1 】

第 1 のゲート電極として機能する導電体 5 6 0 は、導電体 5 6 0 a、および導電体 5 6 0 a 上の導電体 5 6 0 b を有する。導電体 5 6 0 a は、導電体 5 0 5 a と同様に、水素原子、水素分子、水分子、銅原子などの不純物の拡散を抑制する機能を有する導電性材料を用いることが好ましい。または、酸素（例えば、酸素原子、酸素分子などの少なくとも一つ

50

)の拡散を抑制する機能を有する導電性材料を用いることが好ましい。

【0262】

導電体560aが酸素の拡散を抑制する機能を持つことにより、導電体560bの材料選択性を向上することができる。つまり、導電体560aを有することで、導電体560bの酸化が抑制され、導電率が低下することを防止することができる。

【0263】

酸素の拡散を抑制する機能を有する導電性材料としては、例えば、タンタル、窒化タンタル、ルテニウムまたは酸化ルテニウムなどを用いることが好ましい。また、導電体560aとして、酸化物530として用いることができる酸化物半導体を用いることができる。その場合、導電体560bをスパッタリング法で成膜することで、導電体560aの電気抵抗値を低下させて導電体とすることができる。これをOC(Oxide Conductor)電極と呼ぶことができる。

10

【0264】

導電体560bは、タングステン、銅、またはアルミニウムを主成分とする導電性材料を用いることが好ましい。また、導電体560は、配線として機能するため、導電体560bに導電性が高い導電体を用いることが好ましい。例えば、タングステン、銅、またはアルミニウムを主成分とする導電性材料を用いることができる。また、導電体560bは積層構造としてもよく、例えば、チタン又は窒化チタンと上記導電性材料との積層としてもよい。

【0265】

20

絶縁体580と、トランジスタ510Aとの間に絶縁体574を配置する。絶縁体574は、水または水素などの不純物、および酸素の拡散を抑制する機能を有する絶縁性材料を用いるとよい。例えば、酸化アルミニウムまたは酸化ハフニウムなどを用いることが好ましい。また、他にも、例えば、酸化マグネシウム、酸化ガリウム、酸化ゲルマニウム、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジムまたは酸化タンタルなどの金属酸化物、窒化酸化シリコンまたは窒化シリコンなどを用いることができる。

【0266】

絶縁体574を有することで、絶縁体580が有する水、および水素などの不純物が酸化物530c、絶縁体550を介して、酸化物530bに拡散することを抑制することができる。また、絶縁体580が有する過剰酸素により、導電体560が酸化するのを抑制することができる。

30

【0267】

絶縁体580、絶縁体582、および絶縁体584は、層間膜として機能する。

【0268】

絶縁体582は、絶縁体514と同様に、水または水素などの不純物が、外部からトランジスタ510Aに混入するのを抑制するバリア絶縁膜として機能することが好ましい。

【0269】

また、絶縁体580、および絶縁体584は、絶縁体516と同様に、絶縁体582よりも誘電率が低いことが好ましい。誘電率が低い材料を層間膜とすることで、配線間に生じる寄生容量を低減することができる。

40

【0270】

また、トランジスタ510Aは、絶縁体580、絶縁体582、および絶縁体584に埋め込まれた導電体546などのプラグや配線を介して、他の構造と電氣的に接続してもよい。

【0271】

また、導電体546の材料としては、導電体505と同様に、金属材料、合金材料、金属窒化物材料、または金属酸化物材料などの導電性材料を、単層または積層して用いることができる。例えば、耐熱性と導電性を両立するタングステンやモリブデンなどの高融点材料を用いることが好ましい。または、アルミニウムや銅などの低抵抗導電性材料で形成することが好ましい。低抵抗導電性材料を用いることで配線抵抗を低くすることができる。

50

【0272】

例えば、導電体546として、水素、および酸素に対してバリア性を有する導電体である窒化タンタル等と、導電性が高いタングステンとの積層構造を用いることで、配線としての導電性を保持したまま、外部からの不純物の拡散を抑制することができる。

【0273】

上記構造を有することで、オン電流が大きい酸化物半導体を有するトランジスタを提供することができる。または、オフ電流が小さい酸化物半導体を有するトランジスタを提供することができる。または、酸化物半導体を有するトランジスタを用いた半導体装置において、電気特性の変動を抑制するとともに、信頼性を向上させることができる。

【0274】

<トランジスタの構造例2>

図9A、図9Bおよび図9Cを用いてトランジスタ510Bの構造例を説明する。図9Aはトランジスタ510Bの上面図である。図9Bは、図9Aに一点鎖線L1-L2で示す部位の断面図である。図9Cは、図9Aに一点鎖線W1-W2で示す部位の断面図である。なお、図9Aの上面図では、図の明瞭化のために一部の要素を省いている。

【0275】

トランジスタ510Bはトランジスタ510Aの変形例である。よって、説明の繰り返しを防ぐため、主にトランジスタ510Aと異なる点について説明する。

【0276】

トランジスタ510Bは、導電体542（導電体542a、および導電体542b）と、酸化物530c、絶縁体550、および導電体560と、が重畳する領域を有する。当該構造とすることで、オン電流が高いトランジスタを提供することができる。また、制御性が高いトランジスタを提供することができる。

【0277】

第1のゲート電極として機能する導電体560は、導電体560a、および導電体560a上の導電体560bを有する。導電体560aは、導電体505aと同様に、水素原子、水素分子、水分子、銅原子などの不純物の拡散を抑制する機能を有する導電性材料を用いることが好ましい。または、酸素（例えば、酸素原子、酸素分子などの少なくとも一つ）の拡散を抑制する機能を有する導電性材料を用いることが好ましい。

【0278】

導電体560aが酸素の拡散を抑制する機能を持つことにより、導電体560bの材料選択性を向上することができる。つまり、導電体560aを有することで、導電体560bの酸化が抑制され、導電率が低下することを防止することができる。

【0279】

また、導電体560の上面および側面、絶縁体550の側面、および酸化物530cの側面を覆うように、絶縁体574を設けることが好ましい。なお、絶縁体574は、水または水素などの不純物、および酸素の拡散を抑制する機能を有する絶縁性材料を用いるとよい。例えば、酸化アルミニウムまたは酸化ハフニウムなどを用いることが好ましい。また、他にも、例えば、酸化マグネシウム、酸化ガリウム、酸化ゲルマニウム、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジムまたは酸化タンタルなどの金属酸化物、窒化酸化シリコンまたは窒化シリコンなどを用いることができる。

【0280】

絶縁体574を設けることで、導電体560の酸化を抑制することができる。また、絶縁体574を有することで、絶縁体580が有する水、および水素などの不純物がトランジスタ510Bへ拡散することを抑制することができる。

【0281】

また、導電体546と、絶縁体580との間に、バリア性を有する絶縁体576（絶縁体576a、および絶縁体576b）を配置してもよい。絶縁体576を設けることで、絶縁体580の酸素が導電体546と反応し、導電体546が酸化することを抑制することができる。

10

20

30

40

50

【 0 2 8 2 】

また、バリア性を有する絶縁体 5 7 6 を設けることで、プラグや配線に用いられる導電体の材料選択の幅を広げることができる。例えば、導電体 5 4 6 に、酸素を吸収する性質を持つ一方で、導電性が高い金属材料を用いることで、低消費電力の半導体装置を提供することができる。具体的には、タングステンや、アルミニウムなどの耐酸化性が低い一方で導電性が高い材料を用いることができる。また、例えば、成膜、または加工がしやすい導電体を用いることができる。

【 0 2 8 3 】

< トランジスタの構造例 3 >

図 1 0 A、図 1 0 B および図 1 0 C を用いてトランジスタ 5 1 0 C の構造例を説明する。図 1 0 A はトランジスタ 5 1 0 C の上面図である。図 1 0 B は、図 1 0 A に一点鎖線 L 1 - L 2 で示す部位の断面図である。図 1 0 C は、図 1 0 A に一点鎖線 W 1 - W 2 で示す部位の断面図である。なお、図 1 0 A の上面図では、図の明瞭化のために一部の要素を省いている。

10

【 0 2 8 4 】

トランジスタ 5 1 0 C はトランジスタ 5 1 0 A の変形例である。よって、説明の繰り返しを防ぐため、主にトランジスタ 5 1 0 A と異なる点について説明する。

【 0 2 8 5 】

図 1 0 に示すトランジスタ 5 1 0 C は、導電体 5 4 2 a と酸化物 5 3 0 b の間に導電体 5 4 7 a が配置され、導電体 5 4 2 b と酸化物 5 3 0 b の間に導電体 5 4 7 b が配置されている。ここで、導電体 5 4 2 a (導電体 5 4 2 b) は、導電体 5 4 7 a (導電体 5 4 7 b) の上面および導電体 5 6 0 側の側面を越えて延在し、酸化物 5 3 0 b の上面に接する領域を有する。ここで、導電体 5 4 7 は、導電体 5 4 2 に用いることができる導電体を用いればよい。さらに、導電体 5 4 7 の膜厚は、少なくとも導電体 5 4 2 より厚いことが好ましい。

20

【 0 2 8 6 】

図 1 0 に示すトランジスタ 5 1 0 C は、上記のような構成を有することにより、トランジスタ 5 1 0 A よりも、導電体 5 4 2 を導電体 5 6 0 に近づけることができる。または、導電体 5 4 2 a の端部および導電体 5 4 2 b の端部と、導電体 5 6 0 を重ねることができる。これにより、トランジスタ 5 1 0 C の実質的なチャネル長を短くし、オン電流および周波数特性の向上を図ることができる。

30

【 0 2 8 7 】

また、導電体 5 4 7 a (導電体 5 4 7 b) は、導電体 5 4 2 a (導電体 5 4 2 b) と重畳して設けられることが好ましい。このような構成にすることで、導電体 5 4 6 a (導電体 5 4 6 b) を埋め込む開口を形成するエッチングにおいて、導電体 5 4 7 a (導電体 5 4 7 b) がストoppaとして機能し、酸化物 5 3 0 b がオーバーエッチングされるのを防ぐことができる。

【 0 2 8 8 】

また、図 1 0 に示すトランジスタ 5 1 0 C は、絶縁体 5 4 4 の上に接して絶縁体 5 4 5 を配置する構成にしてもよい。絶縁体 5 4 4 としては、水または水素などの不純物や、過剰な酸素が、絶縁体 5 8 0 側からトランジスタ 5 1 0 C に混入するのを抑制するバリア絶縁膜として機能することが好ましい。絶縁体 5 4 5 としては、絶縁体 5 4 4 に用いることができる絶縁体を用いることができる。また、絶縁体 5 4 4 としては、例えば、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムチタン、窒化チタン、窒化シリコンまたは窒化酸化シリコンなどの、窒化物絶縁体を用いてもよい。

40

【 0 2 8 9 】

また、図 1 0 に示すトランジスタ 5 1 0 C は、図 8 に示すトランジスタ 5 1 0 A と異なり、導電体 5 0 5 を単層構造で設けてもよい。この場合、パターン形成された導電体 5 0 5 の上に絶縁体 5 1 6 となる絶縁膜を成膜し、当該絶縁膜の上部を、導電体 5 0 5 の上面が露出するまで C M P 法などを用いて除去すればよい。ここで、導電体 5 0 5 の上面の平坦

50

性を良好にすることが好ましい。例えば、導電体 5 0 5 上面の平均面粗さ (R a) を 1 n m 以下、好ましくは 0 . 5 n m 以下、より好ましくは 0 . 3 n m 以下にすればよい。これにより、導電体 5 0 5 の上に形成される、絶縁層の平坦性を良好にし、酸化物 5 3 0 b および酸化物 5 3 0 c の結晶性の向上を図ることができる。

【 0 2 9 0 】

< トランジスタの構造例 4 >

図 1 1 A、図 1 1 B および図 1 1 C を用いてトランジスタ 5 1 0 D の構造例を説明する。図 1 1 A はトランジスタ 5 1 0 D の上面図である。図 1 1 B は、図 1 1 A に一点鎖線 L 1 - L 2 で示す部位の断面図である。図 1 1 C は、図 1 1 A に一点鎖線 W 1 - W 2 で示す部位の断面図である。なお、図 1 1 A の上面図では、図の明瞭化のために一部の要素を省いている。

10

【 0 2 9 1 】

トランジスタ 5 1 0 D は上記トランジスタの変形例である。よって、説明の繰り返しを防ぐため、主に上記トランジスタと異なる点について説明する。

【 0 2 9 2 】

図 1 1 A 乃至図 1 1 C では、導電体 5 0 3 を設けずに、第 2 のゲートとしての機能を有する導電体 5 0 5 を配線としても機能させている。また、酸化物 5 3 0 c 上に絶縁体 5 5 0 を有し、絶縁体 5 5 0 上に金属酸化物 5 5 2 を有する。また、金属酸化物 5 5 2 上に導電体 5 6 0 を有し、導電体 5 6 0 上に絶縁体 5 7 0 を有する。また、絶縁体 5 7 0 上に絶縁体 5 7 1 を有する。

20

【 0 2 9 3 】

金属酸化物 5 5 2 は、酸素拡散を抑制する機能を有することが好ましい。絶縁体 5 5 0 と、導電体 5 6 0 との間に、酸素の拡散を抑制する金属酸化物 5 5 2 を設けることで、導電体 5 6 0 への酸素の拡散が抑制される。つまり、酸化物 5 3 0 へ供給する酸素量の減少を抑制することができる。また、酸素による導電体 5 6 0 の酸化を抑制することができる。

【 0 2 9 4 】

なお、金属酸化物 5 5 2 は、第 1 のゲートの一部としての機能を有してもよい。例えば、酸化物 5 3 0 として用いることができる酸化物半導体を、金属酸化物 5 5 2 として用いることができる。その場合、導電体 5 6 0 をスパッタリング法で成膜することで、金属酸化物 5 5 2 の電気抵抗値を低下させて導電層とすることができる。これを O C (O x i d e C o n d u c t o r) 電極と呼ぶことができる。

30

【 0 2 9 5 】

また、金属酸化物 5 5 2 は、ゲート絶縁膜の一部としての機能を有する場合がある。したがって、絶縁体 5 5 0 に酸化シリコンや酸化窒化シリコンなどを用いる場合、金属酸化物 5 5 2 は、比誘電率が高い h i g h - k 材料である金属酸化物を用いることが好ましい。当該積層構造とすることで、熱に対して安定、かつ比誘電率の高い積層構造とすることができる。したがって、物理膜厚を保持したまま、トランジスタ動作時に印加するゲート電位の低減が可能となる。また、ゲート絶縁膜として機能する絶縁層の等価酸化膜厚 (E O T) の薄膜化が可能となる。

【 0 2 9 6 】

トランジスタ 5 1 0 D において、金属酸化物 5 5 2 を単層で示したが、2 層以上の積層構造としてもよい。例えば、ゲート電極の一部として機能する金属酸化物と、ゲート絶縁膜の一部として機能する金属酸化物とを積層して設けてもよい。

40

【 0 2 9 7 】

金属酸化物 5 5 2 を有することで、ゲート電極として機能する場合は、導電体 5 6 0 からの電界の影響を弱めることなく、トランジスタ 5 1 0 D のオン電流の向上を図ることができる。または、ゲート絶縁膜として機能する場合は、絶縁体 5 5 0 と、金属酸化物 5 5 2 との物理的な厚みにより、導電体 5 6 0 と、酸化物 5 3 0 との間の距離を保つことで、導電体 5 6 0 と酸化物 5 3 0 との間のリーク電流を抑制することができる。従って、絶縁体 5 5 0、および金属酸化物 5 5 2 との積層構造を設けることで、導電体 5 6 0 と酸化物 5

50

３０との間の物理的な距離、および導電体５６０から酸化物５３０へかかる電界強度を、容易に適宜調整することができる。

【０２９８】

具体的には、金属酸化物５５２として、酸化物５３０に用いることができる酸化物半導体を低抵抗化することで、金属酸化物５５２として用いることができる。または、ハフニウム、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、ジルコニウム、タングステン、チタン、タンタル、ニッケル、ゲルマニウム、または、マグネシウムなどから選ばれた一種、または二種以上が含まれた金属酸化物を用いることができる。

【０２９９】

特に、アルミニウム、またはハフニウムの一方または双方の酸化物を含む絶縁層である、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、アルミニウムおよびハフニウムを含む酸化物（ハフニウムアルミネート）などを用いることが好ましい。特に、ハフニウムアルミネートは、酸化ハフニウム膜よりも、耐熱性が高い。そのため、後の工程での熱処理において、結晶化しにくいことが好ましい。なお、金属酸化物５５２は、必須の構成ではない。求めるトランジスタ特性により、適宜設計すればよい。

10

【０３００】

絶縁体５７０は、水または水素などの不純物、および酸素の透過を抑制する機能を有する絶縁性材料を用いるとよい。例えば、酸化アルミニウムまたは酸化ハフニウムなどを用いることが好ましい。これにより、絶縁体５７０よりも上方からの酸素で導電体５６０が酸化するのを抑制することができる。また、絶縁体５７０よりも上方からの水または水素などの不純物が、導電体５６０および絶縁体５５０を介して、酸化物５３０に混入することを抑制することができる。

20

【０３０１】

絶縁体５７１はハードマスクとして機能する。絶縁体５７１を設けることで、導電体５６０の加工の際、導電体５６０の側面が概略垂直、具体的には、導電体５６０の側面と基板表面のなす角を、７５度以上１００度以下、好ましくは８０度以上９５度以下とすることができる。

【０３０２】

なお、絶縁体５７１に、水または水素などの不純物、および酸素の透過を抑制する機能を有する絶縁性材料を用いることで、バリア層としての機能を兼ねさせてもよい。その場合、絶縁体５７０は設けなくともよい。

30

【０３０３】

絶縁体５７１をハードマスクとして用いて、絶縁体５７０、導電体５６０、金属酸化物５５２、絶縁体５５０、および酸化物５３０ｃの一部を選択的に除去することで、これらの側面を略一致させて、かつ、酸化物５３０ｂ表面の一部を露出させることができる。

【０３０４】

また、トランジスタ５１０Ｄは、露出した酸化物５３０ｂ表面の一部に領域５３１ａおよび領域５３１ｂを有する。領域５３１ａまたは領域５３１ｂの一方はソース領域として機能し、他方はドレイン領域として機能する。

【０３０５】

領域５３１ａおよび領域５３１ｂの形成は、例えば、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイメージョンイオン注入法、またはプラズマ処理などを用いて、露出した酸化物５３０ｂ表面にリンまたはボロンなどの不純物元素を導入することで実現できる。なお、本実施の形態などにおいて「不純物元素」とは、主成分元素以外の元素のことをいう。

40

【０３０６】

また、酸化物５３０ｂ表面の一部を露出させた後に金属膜を成膜し、その後加熱処理することにより、該金属膜に含まれる元素を酸化物５３０ｂに拡散させて領域５３１ａおよび領域５３１ｂを形成することもできる。

【０３０７】

酸化物５３０ｂの不純物元素が導入された領域は、電気抵抗率が低下する。このため、領

50

域 5 3 1 a および領域 5 3 1 b を「不純物領域」または「低抵抗領域」という場合がある。

【 0 3 0 8 】

絶縁体 5 7 1 および / または導電体 5 6 0 をマスクとして用いることで、領域 5 3 1 a および領域 5 3 1 b を自己整合（セルフアライメント）的に形成することができる。よって、領域 5 3 1 a および / または領域 5 3 1 b と、導電体 5 6 0 が重ならず、寄生容量を低減することができる。また、チャネル形成領域とソースドレイン領域（領域 5 3 1 a または領域 5 3 1 b ）の間にオフセット領域が形成されない。領域 5 3 1 a および領域 5 3 1 b を自己整合（セルフアライメント）的に形成することにより、オン電流の増加、しきい値電圧の低減、動作周波数の向上などを実現できる。

【 0 3 0 9 】

なお、オフ電流を更に低減するため、チャネル形成領域とソースドレイン領域の間にオフセット領域を設けてもよい。オフセット領域とは、電気抵抗率が高い領域であり、前述した不純物元素の導入が行なわれない領域である。オフセット領域の形成は、絶縁体 5 7 5 の形成後に前述した不純物元素の導入を行なうことで実現できる。この場合、絶縁体 5 7 5 も絶縁体 5 7 1 などと同様にマスクとして機能する。よって、酸化物 5 3 0 b の絶縁体 5 7 5 と重なる領域に不純物元素が導入されず、該領域の電気抵抗率を高いままとすることができる。

【 0 3 1 0 】

また、トランジスタ 5 1 0 D は、絶縁体 5 7 0、導電体 5 6 0、金属酸化物 5 5 2、絶縁体 5 5 0、および酸化物 5 3 0 c の側面に絶縁体 5 7 5 を有する。絶縁体 5 7 5 は、比誘電率の低い絶縁体であることが好ましい。例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、フッ素を添加した酸化シリコン、炭素を添加した酸化シリコン、炭素および窒素を添加した酸化シリコン、空孔を有する酸化シリコン、または樹脂などであることが好ましい。特に、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、空孔を有する酸化シリコンを絶縁体 5 7 5 に用いると、後の工程で絶縁体 5 7 5 中に過剰酸素領域を容易に形成できるため好ましい。また、酸化シリコンおよび酸化窒化シリコンは、熱的に安定であるため好ましい。また、絶縁体 5 7 5 は、酸素を拡散する機能を有することが好ましい。

【 0 3 1 1 】

また、トランジスタ 5 1 0 D は、絶縁体 5 7 5、酸化物 5 3 0 上に絶縁体 5 7 4 を有する。絶縁体 5 7 4 は、スパッタリング法を用いて成膜することが好ましい。スパッタリング法を用いることにより、水または水素などの不純物の少ない絶縁体を成膜することができる。例えば、絶縁体 5 7 4 として、酸化アルミニウムを用いるとよい。

【 0 3 1 2 】

なお、スパッタリング法を用いた酸化膜は、被成膜構造体から水素を引き抜く場合がある。従って、絶縁体 5 7 4 が酸化物 5 3 0 および絶縁体 5 7 5 から水素および水を吸収することで、酸化物 5 3 0 および絶縁体 5 7 5 の水素濃度を低減することができる。

【 0 3 1 3 】

< トランジスタの構造例 5 >

図 1 2 A 乃至図 1 2 C を用いてトランジスタ 5 1 0 E の構造例を説明する。図 1 2 A はトランジスタ 5 1 0 E の上面図である。図 1 2 B は、図 1 2 A に一点鎖線 L 1 - L 2 で示す部位の断面図である。図 1 2 C は、図 1 2 A に一点鎖線 W 1 - W 2 で示す部位の断面図である。なお、図 1 2 A の上面図では、図の明瞭化のために一部の要素を省いている。

【 0 3 1 4 】

トランジスタ 5 1 0 E は上記トランジスタの変形例である。よって、説明の繰り返しを防ぐため、主に上記トランジスタと異なる点について説明する。

【 0 3 1 5 】

図 1 2 A 乃至図 1 2 C では、導電体 5 4 2 を設けずに、露出した酸化物 5 3 0 b 表面の一部に領域 5 3 1 a および領域 5 3 1 b を有する。領域 5 3 1 a または領域 5 3 1 b の一方はソース領域として機能し、他方はドレイン領域として機能する。また、酸化物 5 3 0 b

10

20

30

40

50

と、絶縁体 5 7 4 の間に、絶縁体 5 7 3 を有する。

【 0 3 1 6 】

図 1 2 に示す、領域 5 3 1 (領域 5 3 1 a、および領域 5 3 1 b) は、酸化物 5 3 0 b に下記の元素が添加された領域である。領域 5 3 1 は、例えば、ダミーゲートを用いることで形成することができる。

【 0 3 1 7 】

具体的には、酸化物 5 3 0 b 上にダミーゲートを設け、当該ダミーゲートをマスクとして用い、上記酸化物 5 3 0 b を低抵抗化する元素を添加するとよい。つまり、酸化物 5 3 0 が、ダミーゲートと重畳していない領域に、当該元素が添加され、領域 5 3 1 が形成される。なお、当該元素の添加方法としては、イオン化された原料ガスを質量分離して添加するイオン注入法、イオン化された原料ガスを質量分離せずに添加するイオンドーピング法、プラズマイメージョンイオンインプランテーション法などを用いることができる。

10

【 0 3 1 8 】

なお、酸化物 5 3 0 を低抵抗化する元素としては、代表的には、ホウ素、またはリンが挙げられる。また、水素、炭素、窒素、フッ素、硫黄、塩素、チタン、希ガス等を用いてもよい。希ガスの代表例としては、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、及びキセノン等がある。当該元素の濃度は、二次イオン質量分析法 (S I M S : S e c o n d a r y I o n M a s s S p e c t r o m e t r y) などを用いて測定すればよい。

【 0 3 1 9 】

特に、ホウ素、及びリンは、低温ポリシリコン等の製造ラインの装置を使用することができるため、好ましい。既存の設備を転用することができ、設備投資を抑制することができる。

20

【 0 3 2 0 】

続いて、酸化物 5 3 0 b、およびダミーゲート上に、絶縁体 5 7 3 となる絶縁膜、および絶縁体 5 7 4 となる絶縁膜を成膜してもよい。絶縁体 5 7 3 となる絶縁膜、および絶縁体 5 7 4 となる絶縁膜を積層して設けることで、領域 5 3 1 と、酸化物 5 3 0 c および絶縁体 5 5 0 とが重畳する領域を設けることができる。

【 0 3 2 1 】

具体的には、絶縁体 5 7 4 となる絶縁膜上に絶縁体 5 8 0 となる絶縁膜を設けた後、絶縁体 5 8 0 となる絶縁膜に C M P (C h e m i c a l M e c h a n i c a l P o l i s h i n g) 処理を行うことで、絶縁体 5 8 0 となる絶縁膜の一部を除去し、ダミーゲートを露出する。続いて、ダミーゲートを除去する際に、ダミーゲートと接する絶縁体 5 7 3 の一部も除去するとよい。従って、絶縁体 5 8 0 に設けられた開口部の側面には、絶縁体 5 7 4、および絶縁体 5 7 3 が露出し、当該開口部の底面には、酸化物 5 3 0 b に設けられた領域 5 3 1 の一部が露出する。次に、当該開口部に酸化物 5 3 0 c となる酸化膜、絶縁体 5 5 0 となる絶縁膜、および導電体 5 6 0 となる導電膜を順に成膜した後、絶縁体 5 8 0 が露出するまで C M P 処理などにより、酸化物 5 3 0 c となる酸化膜、絶縁体 5 5 0 となる絶縁膜、および導電体 5 6 0 となる導電膜の一部を除去することで、図 1 2 に示すトランジスタを形成することができる。

30

【 0 3 2 2 】

なお、絶縁体 5 7 3、および絶縁体 5 7 4 は必須の構成ではない。求めるトランジスタ特性により、適宜設計すればよい。

40

【 0 3 2 3 】

図 1 2 に示すトランジスタは、既存の装置を転用することができ、さらに、導電体 5 4 2 を設けないため、コストの低減を図ることができる。

【 0 3 2 4 】

< トランジスタの構造例 6 >

図 1 3 A 乃至図 1 3 C を用いてトランジスタ 5 1 0 F の構造例を説明する。図 1 3 A はトランジスタ 5 1 0 F の上面図である。図 1 3 B は、図 1 3 A に一点鎖線 L 1 - L 2 で示す部位の断面図である。図 1 3 C は、図 1 3 A に一点鎖線 W 1 - W 2 で示す部位の断面図で

50

ある。なお、図 1 3 A の上面図では、図の明瞭化のために一部の要素を省いている。

【 0 3 2 5 】

トランジスタ 5 1 0 F はトランジスタ 5 1 0 A の変形例である。よって、説明の繰り返しを防ぐため、主に上記トランジスタと異なる点について説明する。

【 0 3 2 6 】

トランジスタ 5 1 0 A では、絶縁体 5 7 4 の一部が絶縁体 5 8 0 に設けられた開口部内に設けられ、導電体 5 6 0 の側面を覆うように設けられている。一方で、トランジスタ 5 1 0 F では絶縁体 5 8 0 と絶縁体 5 7 4 の一部を除去して開口が形成されている。

【 0 3 2 7 】

また、導電体 5 4 6 と、絶縁体 5 8 0 との間に、バリア性を有する絶縁体 5 7 6 (絶縁体 5 7 6 a、および絶縁体 5 7 6 b) を配置してもよい。絶縁体 5 7 6 を設けることで、絶縁体 5 8 0 の酸素が導電体 5 4 6 と反応し、導電体 5 4 6 が酸化することを抑制することができる。

10

【 0 3 2 8 】

なお、酸化物 5 3 0 として酸化物半導体を用いる場合は、各金属原子の原子数比が異なる複数の酸化物層の積層構造を有することが好ましい。具体的には、酸化物 5 3 0 a に用いる金属酸化物において、構成元素中の元素 M の原子数比が、酸化物 5 3 0 b に用いる金属酸化物における、構成元素中の元素 M の原子数比より大きいことが好ましい。また、酸化物 5 3 0 a に用いる金属酸化物において、I n に対する元素 M の原子数比が、酸化物 5 3 0 b に用いる金属酸化物における、I n に対する元素 M の原子数比より大きいことが好ましい。また、酸化物 5 3 0 b に用いる金属酸化物において、元素 M に対する I n の原子数比が、酸化物 5 3 0 a に用いる金属酸化物における、元素 M に対する I n の原子数比より大きいことが好ましい。また、酸化物 5 3 0 c は、酸化物 5 3 0 a または酸化物 5 3 0 b に用いることができる金属酸化物を用いることができる。

20

【 0 3 2 9 】

酸化物 5 3 0 a、酸化物 5 3 0 b、および酸化物 5 3 0 c は、結晶性を有することが好ましく、特に、C A A C - O S を用いることが好ましい。C A A C - O S 等の結晶性を有する酸化物は、不純物や欠陥 (酸素欠損等) が少なく、結晶性の高い、緻密な構造を有している。よって、ソース電極またはドレイン電極による、酸化物 5 3 0 b からの酸素の引き抜きを抑制することができる。これにより、熱処理を行っても、酸化物 5 3 0 b から酸素が引き抜かれることを低減できるので、トランジスタ 5 1 0 F は、製造工程における高い温度 (所謂サーマルバジェット) に対して安定である。

30

【 0 3 3 0 】

なお、酸化物 5 3 0 a および酸化物 5 3 0 c の一方または双方を省略してもよい。酸化物 5 3 0 を酸化物 5 3 0 b の単層としてもよい。酸化物 5 3 0 を、酸化物 5 3 0 a、酸化物 5 3 0 b、および酸化物 5 3 0 c の積層とする場合は、酸化物 5 3 0 a および酸化物 5 3 0 c の伝導帯下端のエネルギーが、酸化物 5 3 0 b の伝導帯下端のエネルギーより高くなることが好ましい。また、言い換えると、酸化物 5 3 0 a および酸化物 5 3 0 c の電子親和力が、酸化物 5 3 0 b の電子親和力より小さいことが好ましい。この場合、酸化物 5 3 0 c は、酸化物 5 3 0 a に用いることができる金属酸化物を用いることが好ましい。具体的には、酸化物 5 3 0 c に用いる金属酸化物において、構成元素中の元素 M の原子数比が、酸化物 5 3 0 b に用いる金属酸化物における、構成元素中の元素 M の原子数比より大きいことが好ましい。また、酸化物 5 3 0 c に用いる金属酸化物において、I n に対する元素 M の原子数比が、酸化物 5 3 0 b に用いる金属酸化物における、I n に対する元素 M の原子数比より大きいことが好ましい。また、酸化物 5 3 0 b に用いる金属酸化物において、元素 M に対する I n の原子数比が、酸化物 5 3 0 c に用いる金属酸化物における、元素 M に対する I n の原子数比より大きいことが好ましい。

40

【 0 3 3 1 】

ここで、酸化物 5 3 0 a、酸化物 5 3 0 b、および酸化物 5 3 0 c の接合部において、伝導帯下端のエネルギー準位はなだらかに変化する。換言すると、酸化物 5 3 0 a、酸化物

50

530b、および酸化物530cの接合部における伝導帯下位のエネルギー準位は、連続的に変化または連続接合するともいうことができる。このようにするためには、酸化物530aと酸化物530bとの界面、および酸化物530bと酸化物530cとの界面において形成される混合層の欠陥準位密度を低くするとよい。

【0332】

具体的には、酸化物530aと酸化物530b、酸化物530bと酸化物530cが、酸素以外に共通の元素を有する（主成分とする）ことで、欠陥準位密度が低い混合層を形成することができる。例えば、酸化物530bがIn-Ga-Zn酸化物の場合、酸化物530aおよび酸化物530cとして、In-Ga-Zn酸化物、Ga-Zn酸化物、酸化ガリウム等を用いてもよい。また、酸化物530cを積層構造としてもよい。例えば、In-Ga-Zn酸化物と、当該In-Ga-Zn酸化物上のGa-Zn酸化物との積層構造、またはIn-Ga-Zn酸化物と、当該In-Ga-Zn酸化物上の酸化ガリウムとの積層構造を用いることができる。別言すると、In-Ga-Zn酸化物と、Inを含まない酸化物との積層構造を、酸化物530cとして用いてもよい。

10

【0333】

具体的には、酸化物530aとして、In:Ga:Zn=1:3:4[原子数比]、または1:1:0.5[原子数比]の金属酸化物を用いればよい。また、酸化物530bとして、In:Ga:Zn=4:2:3[原子数比]、または3:1:2[原子数比]の金属酸化物を用いればよい。また、酸化物530cとして、In:Ga:Zn=1:3:4[原子数比]、In:Ga:Zn=4:2:3[原子数比]、Ga:Zn=2:1[原子数比]、またはGa:Zn=2:5[原子数比]の金属酸化物を用いればよい。また、酸化物530cを積層構造とする場合の具体例としては、In:Ga:Zn=4:2:3[原子数比]と、Ga:Zn=2:1[原子数比]との積層構造、In:Ga:Zn=4:2:3[原子数比]と、Ga:Zn=2:5[原子数比]との積層構造、In:Ga:Zn=4:2:3[原子数比]と、酸化ガリウムとの積層構造等が挙げられる。

20

【0334】

このとき、キャリアの主たる経路は酸化物530bとなる。酸化物530a、酸化物530cを上述の構成とすることで、酸化物530aと酸化物530bとの界面、および酸化物530bと酸化物530cとの界面における欠陥準位密度を低くすることができる。そのため、界面散乱によるキャリア伝導への影響が小さくなり、トランジスタ510Fは高いオン電流、および高い周波数特性を得ることができる。なお、酸化物530cを積層構造とした場合、上述の酸化物530bと、酸化物530cとの界面における欠陥準位密度を低くする効果に加え、酸化物530cが有する構成元素が、絶縁体550側に拡散するのを抑制することが期待される。より具体的には、酸化物530cを積層構造とし、積層構造の上方にInを含まない酸化物を位置させるため、絶縁体550側に拡散しうるInを抑制することができる。絶縁体550は、ゲート絶縁体として機能するため、Inが拡散した場合、トランジスタの特性不良となる。したがって、酸化物530cを積層構造とすることで、信頼性の高い半導体装置を提供することが可能となる。

30

【0335】

酸化物530は、酸化物半導体として機能する金属酸化物を用いることが好ましい。例えば、酸化物530のチャネル形成領域となる金属酸化物としては、バンドギャップが2eV以上、好ましくは2.5eV以上のものを用いることが好ましい。このように、バンドギャップの大きい金属酸化物を用いることで、トランジスタのオフ電流を低減することができる。このようなトランジスタを用いることで、低消費電力の半導体装置を提供できる。

40

【0336】

<トランジスタの構造例7>

図14A、図14Bを用いてトランジスタ510Gの構造例を説明する。トランジスタ510Gはトランジスタ500の変形例である。よって、説明の繰り返しを防ぐため、主に上記トランジスタと異なる点について説明する。なお、図14A、図14Bに示す構成は、トランジスタ300等、本発明の一形態の半導体装置が有する他のトランジスタにも適

50

用することができる。

【0337】

図14Aは、トランジスタ510Gのチャネル長方向の断面図であり、図14Bは、トランジスタ510Gのチャネル幅方向の断面図である。図14A、図14Bに示すトランジスタ510Gは、絶縁体402及び絶縁体404を有する点が、図7A、図7Bに示すトランジスタ500と異なる。また、導電体540aの側面に接して絶縁体551が設けられ、導電体540bの側面に接して絶縁体551が設けられる点が、図7A、図7Bに示すトランジスタ500と異なる。さらに、絶縁体520を有さない点が、図7A、図7Bに示すトランジスタ500と異なる。

【0338】

図14A、図14Bに示すトランジスタ510Gは、絶縁体512上に絶縁体402が設けられる。また、絶縁体574上、及び絶縁体402上に絶縁体404が設けられる。

【0339】

図14A、図14Bに示すトランジスタ510Gでは、絶縁体514、絶縁体516、絶縁体522、絶縁体524、絶縁体544、絶縁体580、及び絶縁体574がパターンニングされており、絶縁体404がこれらを覆う構造になっている。つまり、絶縁体404は、絶縁体574の上面、絶縁体574の側面、絶縁体580の側面、絶縁体544の側面、絶縁体524の側面、絶縁体522の側面、絶縁体516の側面、絶縁体514の側面、絶縁体402の上面とそれぞれ接する。これにより、酸化物530等は、絶縁体404と絶縁体402によって外部から隔離される。

【0340】

絶縁体402及び絶縁体404は、水素（例えば、水素原子、水素分子などの少なくとも一つ）又は水分子の拡散を抑制する機能が高いことが好ましい。例えば、絶縁体402及び絶縁体404として、水素バリア性が高い材料である、窒化シリコン又は窒化酸化シリコンを用いることが好ましい。これにより、酸化物530に水素等が拡散することを抑制することができるので、トランジスタ510Gの特性が低下することを抑制することができる。よって、本発明の一形態の半導体装置の信頼性を高めることができる。

【0341】

絶縁体551は、絶縁体581、絶縁体404、絶縁体574、絶縁体580、及び絶縁体544に接して設けられる。絶縁体551は、水素又は水分子の拡散を抑制する機能を有することが好ましい。たとえば、絶縁体551として、水素バリア性が高い材料である、窒化シリコン、酸化アルミニウム、又は窒化酸化シリコン等の絶縁体を用いることが好ましい。特に、窒化シリコンは水素バリア性が高い材料であるので、絶縁体551として用いると好適である。絶縁体551として水素バリア性が高い材料を用いることにより、水又は水素等の不純物が、絶縁体580等から導電体540a及び導電体540bを通じて酸化物530に拡散することを抑制することができる。また、絶縁体580に含まれる酸素が導電体540a及び導電体540bに吸収されることを抑制することができる。以上により、本発明の一形態の半導体装置の信頼性を高めることができる。

【0342】

図15は、トランジスタ500及びトランジスタ300を、図14A、図14Bに示す構成とした場合における、半導体装置の構成例を示す断面図である。導電体546の側面に、絶縁体551が設けられている。

【0343】

図16A、図16Bは、図14A、図14Bに示すトランジスタの変形例である。図16Aはトランジスタのチャネル長方向の断面図であり、図16Bはトランジスタのチャネル幅方向の断面図である。図16A、図16Bに示すトランジスタは、酸化物530cが酸化物530c1及び酸化物530c2の2層構造である点が、図14A、図14Bに示すトランジスタと異なる。

【0344】

酸化物530c1は、絶縁体524の上面、酸化物530aの側面、酸化物530bの上

10

20

30

40

50

面及び側面、導電体 5 4 2 a 及び導電体 5 4 2 b の側面、絶縁体 5 4 4 の側面、及び絶縁体 5 8 0 の側面と接する。酸化物 5 3 0 c 2 は、絶縁体 5 5 0 と接する。

【0345】

酸化物 5 3 0 c 1 として、例えば、In - Zn 酸化物を用いることができる。また、酸化物 5 3 0 c 2 として、酸化物 5 3 0 c が 1 層構造である場合に酸化物 5 3 0 c に用いることができる材料と同様の材料を用いることができる。例えば、酸化物 5 3 0 c 2 として、 $\text{In} : \text{Ga} : \text{Zn} = 1 : 3 : 4$ [原子数比]、 $\text{Ga} : \text{Zn} = 2 : 1$ [原子数比]、または $\text{Ga} : \text{Zn} = 2 : 5$ [原子数比] の金属酸化物を用いることができる。

【0346】

酸化物 5 3 0 c を酸化物 5 3 0 c 1 及び酸化物 5 3 0 c 2 の 2 層構造とすることにより、酸化物 5 3 0 c を 1 層構造とする場合より、トランジスタのオン電流を高めることができる。よって、トランジスタを、例えば、パワー MOS トランジスタとすることができる。なお、図 7 A、図 7 B に示すトランジスタが有する酸化物 5 3 0 c も、酸化物 5 3 0 c 1 と酸化物 5 3 0 c 2 の 2 層構造とすることができる。

10

【0347】

図 1 6 A、図 1 6 B に示すトランジスタは、例えば、トランジスタ 5 0 0、トランジスタ 3 0 0、または、その双方に適用することができる。

【0348】

なお、本実施の形態は、本明細書に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。

20

【0349】

(実施の形態 3)

本実施の形態では、金属酸化物の一種である酸化物半導体について説明する。

【0350】

金属酸化物は、少なくともインジウムまたは亜鉛を含むことが好ましい。特にインジウムおよび亜鉛を含むことが好ましい。また、それらに加えて、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、スズなどから選ばれた一種、または複数種が含まれていることが好ましい。また、ホウ素、シリコン、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、マグネシウム、コバルトなどから選ばれた一種、または複数種が含まれていてもよい。

30

【0351】

<結晶構造の分類>

まず、酸化物半導体における、結晶構造の分類について、図 1 7 A を用いて説明を行う。図 1 7 A は、酸化物半導体、代表的には I G Z O (In と、Ga と、Zn と、を含む金属酸化物) の結晶構造の分類を説明する図である。

【0352】

図 1 7 A に示すように、酸化物半導体は、大きく分けて「Amorphous (無定形)」と、「Crystalline (結晶性)」と、「Crystal (結晶)」と、に分類される。また、「Amorphous」の中には、completely amorphous が含まれる。また、「Crystalline」の中には、CAAC (c-axis-aligned crystalline)、nc (nanocrystalline)、及び CAC (cloud-aligned composite) が含まれる。なお、「Crystalline」の分類には、single crystal、poly crystal、及び completely amorphous は除かれる。また、「Crystal」の中には、single crystal、及び poly crystal が含まれる。

40

【0353】

なお、図 1 7 A に示す太枠内の構造は、「Amorphous (無定形)」と、「Crystal (結晶)」との間の中間状態であり、新しい境界領域 (New crystalline phase) に属する構造である。すなわち、当該構造は、エネルギー的に不

50

安定な「Amorphous（無定形）」や、「Crystal（結晶）」とは全く異なる構造と言い換えることができる。

【0354】

なお、膜または基板の結晶構造は、X線回折（XRD：X-Ray Diffraction）スペクトルを用いて評価することができる。ここで、「Crystalline」に分類されるCAAC-IGZO膜のGIXD（Grazing-Incidence XRD）測定で得られるXRDスペクトルを図17Bに示す。なお、GIXD法は、薄膜法またはSeemann-Bohlin法ともいう。以降、図17Bに示すGIXD測定で得られるXRDスペクトルを、単にXRDスペクトルと記す。なお、図17Bに示すCAAC-IGZO膜の組成は、In：Ga：Zn＝4：2：3〔原子数比〕近傍である。また、図17Bに示すCAAC-IGZO膜の厚さは、500nmである。

10

【0355】

図17Bでは、横軸は 2θ 〔deg.〕であり、縦軸は強度（Intensity）〔a.u.〕である。図17Bに示すように、CAAC-IGZO膜のXRDスペクトルでは、明確な結晶性を示すピークが検出される。具体的には、CAAC-IGZO膜のXRDスペクトルでは、 $2\theta = 31^\circ$ 近傍に、c軸配向を示すピークが検出される。なお、図17Bに示すように、 $2\theta = 31^\circ$ 近傍のピークは、ピーク強度が検出された角度を軸に左右非対称である。

【0356】

また、膜または基板の結晶構造は、極微電子線回折法（NBED：Nano Beam Electron Diffraction）によって観察される回折パターン（極微電子線回折パターンともいう）にて評価することができる。CAAC-IGZO膜の回折パターンを、図17Cに示す。図17Cは、電子線を基板に対して平行に入射するNBEDによって観察される回折パターンである。なお、図17Cに示すCAAC-IGZO膜の組成は、In：Ga：Zn＝4：2：3〔原子数比〕近傍である。また、極微電子線回折法では、プローブ径を1nmとして電子線回折が行われる。

20

【0357】

図17Cに示すように、CAAC-IGZO膜の回折パターンでは、c軸配向を示す複数のスポットが観察される。

【0358】

30

<<酸化物半導体の構造>>

なお、酸化物半導体は、結晶構造に着目した場合、図17Aとは異なる分類となる場合がある。例えば、酸化物半導体は、単結晶酸化物半導体と、それ以外の非単結晶酸化物半導体と、に分けられる。非単結晶酸化物半導体としては、例えば、上述のCAAC-OS、及びnc-OSがある。また、非単結晶酸化物半導体には、多結晶酸化物半導体、擬似非晶質酸化物半導体（a-like OS：amorphous-like oxide semiconductor）、非晶質酸化物半導体、などが含まれる。

【0359】

ここで、上述のCAAC-OS、nc-OS、及びa-like OSの詳細について、説明を行う。

40

【0360】

[CAAC-OS]

CAAC-OSは、複数の結晶領域を有し、当該複数の結晶領域はc軸が特定の方向に配向している酸化物半導体である。なお、特定の方向とは、CAAC-OS膜の厚さ方向、CAAC-OS膜の被形成面の法線方向、またはCAAC-OS膜の表面の法線方向である。また、結晶領域とは、原子配列に周期性を有する領域である。なお、原子配列を格子配列とみなすと、結晶領域とは、格子配列の揃った領域でもある。さらに、CAAC-OSは、a-b面方向において複数の結晶領域が連結する領域を有し、当該領域は歪みを有する場合がある。なお、歪みとは、複数の結晶領域が連結する領域において、格子配列の揃った領域と、別の格子配列の揃った領域と、の間に格子配列の向きが変化している箇所

50

を指す。つまり、C A A C - O S は、c 軸配向し、a - b 面方向には明らかな配向をしていない酸化物半導体である。

【 0 3 6 1 】

なお、上記複数の結晶領域のそれぞれは、1 つまたは複数の微小な結晶（最大径が 1 0 n m 未満である結晶）で構成される。結晶領域が 1 つの微小な結晶で構成されている場合、当該結晶領域の最大径は 1 0 n m 未満となる。また、結晶領域が多数の微小な結晶で構成されている場合、当該結晶領域の大きさは、数十 n m 程度となる場合がある。

【 0 3 6 2 】

また、I n - M - Z n 酸化物（元素 M は、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、スズ、チタンなどから選ばれた一種、または複数種）において、C A A C - O S は、インジウム（I n）、及び酸素を有する層（以下、I n 層）と、元素 M、亜鉛（Z n）、及び酸素を有する層（以下、（M, Z n）層）とが積層した、層状の結晶構造（層状構造ともいう）を有する傾向がある。なお、インジウムと元素 M は、互いに置換可能である。よって、（M, Z n）層にはインジウムが含まれる場合がある。また、I n 層には元素 M が含まれる場合がある。なお、I n 層には Z n が含まれる場合もある。当該層状構造は、例えば、高分解能 T E M 像において、格子像として観察される。

10

【 0 3 6 3 】

C A A C - O S 膜に対し、例えば、X R D 装置を用いて構造解析を行うと、 2θ スキャンを用いた O u t - o f - p l a n e X R D 測定では、c 軸配向を示すピークが $2\theta = 31^\circ$ またはその近傍に検出される。なお、c 軸配向を示すピークの位置（ 2θ の値）は、C A A C - O S を構成する金属元素の種類、組成などにより変動する場合がある。

20

【 0 3 6 4 】

また、例えば、C A A C - O S 膜の電子線回折パターンにおいて、複数の輝点（スポット）が観測される。なお、あるスポットと別のスポットとは、試料を透過した入射電子線のスポット（ダイレクトスポットともいう）を対称中心として、点对称の位置に観測される。

【 0 3 6 5 】

上記特定の方向から結晶領域を観察した場合、当該結晶領域内の格子配列は、六方格子を基本とするが、単位格子は正六角形とは限らず、非正六角形である場合がある。また、上記歪みにおいて、五角形、七角形などの格子配列を有する場合がある。なお、C A A C - O S において、歪み近傍においても、明確な結晶粒界（グレインバウンダリー）を確認することはできない。即ち、格子配列の歪みによって、結晶粒界の形成が抑制されていることがわかる。これは、C A A C - O S が、a - b 面方向において酸素原子の配列が稠密でないことや、金属原子が置換することで原子間の結合距離が変化することなどによって、歪みを許容することができるためと考えられる。

30

【 0 3 6 6 】

なお、明確な結晶粒界が確認される結晶構造は、いわゆる多結晶（p o l y c r y s t a l l i n e）と呼ばれる。結晶粒界は、再結合中心となり、キャリアが捕獲されトランジスタのオン電流の低下、電界効果移動度の低下などを引き起こす可能性が高い。よって、明確な結晶粒界が確認されない C A A C - O S は、トランジスタの半導体層に好適な結晶構造を有する結晶性の酸化物の一つである。なお、C A A C - O S を構成するには、Z n を有する構成が好ましい。例えば、I n - Z n 酸化物、及び I n - G a - Z n 酸化物は、I n 酸化物よりも結晶粒界の発生を抑制できるため好適である。

40

【 0 3 6 7 】

C A A C - O S は、結晶性が高く、明確な結晶粒界が確認されない酸化物半導体である。よって、C A A C - O S は、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。また、酸化物半導体の結晶性は不純物の混入や欠陥の生成などによって低下する場合があるため、C A A C - O S は不純物や欠陥（酸素欠損など）の少ない酸化物半導体ともいえる。従って、C A A C - O S を有する酸化物半導体は、物理的性質が安定する。そのため、C A A C - O S を有する酸化物半導体は熱に強く、信頼性が高い。また、C A A C - O S は、製造工程における高い温度（所謂サーマルバジェット）に対しても安定である

50

。したがって、O S トランジスタに C A A C - O S を用いると、製造工程の自由度を広げることが可能となる。

【 0 3 6 8 】

[n c - O S]

n c - O S は、微小な領域（例えば、1 n m 以上 1 0 n m 以下の領域、特に 1 n m 以上 3 n m 以下の領域）において原子配列に周期性を有する。別言すると、n c - O S は、微小な結晶を有する。なお、当該微小な結晶の大きさは、例えば、1 n m 以上 1 0 n m 以下、特に 1 n m 以上 3 n m 以下であることから、当該微小な結晶をナノ結晶ともいう。また、n c - O S は、異なるナノ結晶間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、膜全体で配向性が見られない。したがって、n c - O S は、分析方法によっては、a - l i k e O S や非晶質酸化物半導体と区別が付かない場合がある。例えば、n c - O S 膜に対し、X R D 装置を用いて構造解析を行うと、 $\sqrt{2}$ スキャンを用いた O u t - o f - p l a n e X R D 測定では、結晶性を示すピークが検出されない。また、n c - O S 膜に対し、ナノ結晶よりも大きいプローブ径（例えば 5 0 n m 以上）の電子線を用いる電子線回折（制限視野電子線回折ともいう）を行うと、ハローパターンのような回折パターンが観測される。一方、n c - O S 膜に対し、ナノ結晶の大きさと近いナノ結晶より小さいプローブ径（例えば 1 n m 以上 3 0 n m 以下）の電子線を用いる電子線回折（ナノビーム電子線回折ともいう）を行うと、ダイレクトスポットを中心とするリング状の領域内に複数のスポットが観測される電子線回折パターンが取得される場合がある。

【 0 3 6 9 】

[a - l i k e O S]

a - l i k e O S は、n c - O S と非晶質酸化物半導体との間の構造を有する酸化物半導体である。a - l i k e O S は、鬆又は低密度領域を有する。即ち、a - l i k e O S は、n c - O S 及び C A A C - O S と比べて、結晶性が低い。また、a - l i k e O S は、n c - O S 及び C A A C - O S と比べて、膜中の水素濃度が高い。

【 0 3 7 0 】

< < 酸化物半導体の構成 > >

次に、上述の C A C - O S の詳細について、説明を行う。なお、C A C - O S は材料構成に関する。

【 0 3 7 1 】

[C A C - O S]

C A C - O S とは、例えば、金属酸化物を構成する元素が、0 . 5 n m 以上 1 0 n m 以下、好ましくは、1 n m 以上 3 n m 以下、またはその近傍のサイズで偏在した材料の一構成である。なお、以下では、金属酸化物において、一つまたは複数の金属元素が偏在し、該金属元素を有する領域が、0 . 5 n m 以上 1 0 n m 以下、好ましくは、1 n m 以上 3 n m 以下、またはその近傍のサイズで混合した状態をモザイク状、またはパッチ状ともいう。

【 0 3 7 2 】

さらに、C A C - O S とは、第 1 の領域と、第 2 の領域と、に材料が分離することでモザイク状となり、当該第 1 の領域が、膜中に分布した構成（以下、クラウド状ともいう）である。つまり、C A C - O S は、当該第 1 の領域と、当該第 2 の領域とが、混合している構成を有する複合金属酸化物である。

【 0 3 7 3 】

ここで、I n - G a - Z n 酸化物における C A C - O S を構成する金属元素に対する I n 、G a 、および Z n の原子数比のそれぞれを、[I n] 、[G a] 、および [Z n] と表記する。例えば、I n - G a - Z n 酸化物における C A C - O S において、第 1 の領域は、[I n] が、C A C - O S 膜の組成における [I n] よりも大きい領域である。また、第 2 の領域は、[G a] が、C A C - O S 膜の組成における [G a] よりも大きい領域である。または、例えば、第 1 の領域は、[I n] が、第 2 の領域における [I n] よりも大きく、且つ、[G a] が、第 2 の領域における [G a] よりも小さい領域である。また、第 2 の領域は、[G a] が、第 1 の領域における [G a] よりも大きく、且つ、[I n]

」が、第1の領域における[In]よりも小さい領域である。

【0374】

具体的には、上記第1の領域は、インジウム酸化物、インジウム亜鉛酸化物などが主成分である領域である。また、上記第2の領域は、ガリウム酸化物、ガリウム亜鉛酸化物などが主成分である領域である。つまり、上記第1の領域を、Inを主成分とする領域と言い換えることができる。また、上記第2の領域を、Gaを主成分とする領域と言い換えることができる。

【0375】

なお、上記第1の領域と、上記第2の領域とは、明確な境界が観察できない場合がある。

【0376】

例えば、In-Ga-Zn酸化物におけるCAC-OSでは、エネルギー分散型X線分光法(EDX: Energy Dispersive X-ray spectroscopy)を用いて取得したEDXマッピングにより、Inを主成分とする領域(第1の領域)と、Gaを主成分とする領域(第2の領域)とが、偏在し、混合している構造を有することが確認できる。

【0377】

CAC-OSをトランジスタに用いる場合、第1の領域に起因する導電性と、第2の領域に起因する絶縁性とが、相補的に作用することにより、スイッチングさせる機能(On/Offさせる機能)をCAC-OSに付与することができる。つまり、CAC-OSとは、材料の一部では導電性の機能と、材料の一部では絶縁性の機能とを有し、材料の全体では半導体としての機能を有する。導電性の機能と絶縁性の機能とを分離させることで、双方の機能を最大限に高めることができる。よって、CAC-OSをトランジスタに用いることで、高いオン電流(I_{on})、高い電界効果移動度(μ)、および良好なスイッチング動作を実現することができる。

【0378】

酸化物半導体は、多様な構造をとり、それぞれが異なる特性を有する。本発明の一態様の酸化物半導体は、非晶質酸化物半導体、多結晶酸化物半導体、a-like OS、CAC-OS、nc-OS、CAAC-OSのうち、二種以上を有していてもよい。

【0379】

<酸化物半導体を有するトランジスタ>

続いて、上記酸化物半導体をトランジスタに用いる場合について説明する。

【0380】

上記酸化物半導体をトランジスタに用いることで、高い電界効果移動度のトランジスタを実現することができる。また、信頼性の高いトランジスタを実現することができる。

【0381】

トランジスタには、キャリア濃度の低い酸化物半導体を用いることが好ましい。例えば、酸化物半導体のキャリア濃度は $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 以下、さらに好ましくは $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ 以下、より好ましくは $1 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ 以下、さらに好ましくは $1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 未満であり、 $1 \times 10^{-9} \text{ cm}^{-3}$ 以上である。なお、酸化物半導体膜のキャリア濃度を低くする場合においては、酸化物半導体膜中の不純物濃度を低くし、欠陥準位密度を低くすればよい。本明細書等において、不純物濃度が低く、欠陥準位密度の低いことを高純度真性又は実質的に高純度真性と言う。なお、キャリア濃度の低い酸化物半導体を、高純度真性又は実質的に高純度真性な酸化物半導体と呼ぶ場合がある。

【0382】

また、高純度真性又は実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、欠陥準位密度が低い場合、トラップ準位密度も低くなる場合がある。

【0383】

また、酸化物半導体のトラップ準位に捕獲された電荷は、消失するまでに要する時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、トラップ準位密度の高い

10

20

30

40

50

酸化物半導体にチャネル形成領域が形成されるトランジスタは、電気特性が不安定となる場合がある。

【0384】

従って、トランジスタの電気特性を安定にするためには、酸化物半導体中の不純物濃度を低減することが有効である。また、酸化物半導体中の不純物濃度を低減するためには、近接する膜中の不純物濃度も低減することが好ましい。不純物としては、水素、窒素、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄、ニッケル、シリコン等がある。

【0385】

<不純物>

ここで、酸化物半導体中における各不純物の影響について説明する。

10

【0386】

酸化物半導体において、第14族元素の一つであるシリコンや炭素が含まれると、酸化物半導体において欠陥準位が形成される。このため、酸化物半導体におけるシリコンや炭素の濃度と、酸化物半導体との界面近傍のシリコンや炭素の濃度（二次イオン質量分析法（SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry）により得られる濃度）を、 $2 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $2 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下とする。

【0387】

また、酸化物半導体にアルカリ金属又はアルカリ土類金属が含まれると、欠陥準位を形成し、キャリアを生成する場合がある。従って、アルカリ金属又はアルカリ土類金属が含まれている酸化物半導体を用いたトランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。このため、SIMSにより得られる酸化物半導体中のアルカリ金属又はアルカリ土類金属の濃度を、 $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $2 \times 10^{16} \text{ atoms/cm}^3$ 以下にする。

20

【0388】

また、酸化物半導体において、窒素が含まれると、キャリアである電子が生じ、キャリア濃度が増加し、n型化しやすい。この結果、窒素が含まれている酸化物半導体を半導体を用いたトランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。または、酸化物半導体において、窒素が含まれると、トラップ準位が形成される場合がある。この結果、トランジスタの電気特性が不安定となる場合がある。このため、SIMSにより得られる酸化物半導体中の窒素濃度を、 $5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 未満、好ましくは $5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、より好ましくは $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、さらに好ましくは $5 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下にする。

30

【0389】

また、酸化物半導体に含まれる水素は、金属原子と結合する酸素と反応して水になるため、酸素欠損を形成する場合がある。該酸素欠損に水素が入ることで、キャリアである電子が生成される場合がある。また、水素の一部が金属原子と結合する酸素と結合して、キャリアである電子を生成することがある。従って、水素が含まれている酸化物半導体を用いたトランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。このため、酸化物半導体中の水素はできる限り低減されていることが好ましい。具体的には、酸化物半導体において、SIMSにより得られる水素濃度を、 $1 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ 未満、好ましくは $1 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 未満、より好ましくは $5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 未満、さらに好ましくは $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 未満にする。

40

【0390】

不純物が十分に低減された酸化物半導体をトランジスタのチャネル形成領域に用いることで、安定した電気特性を付与することができる。

【0391】

なお、本実施の形態に示す構成、構造、方法などは、他の実施の形態などに示す構成、構造、方法などと適宜組み合わせる用いることができる。

【0392】

50

(実施の形態４)

本実施の形態では、上述した半導体装置の応用例について説明する。

【０３９３】

〔半導体ウエハ、チップ〕

図１８Ａは、ダイシング処理が行なわれる前の基板７１１の上面図を示している。基板７１１としては、例えば、半導体基板（半導体ウエハ、ともいう）を用いることができる。基板７１１上には、複数の回路領域７１２が設けられている。回路領域７１２には、本発明の一形態に係わる半導体装置や、ＣＰＵ、ＲＦタグ、またはイメージセンサなどを設けることができる。

【０３９４】

複数の回路領域７１２は、それぞれが分離領域７１３に囲まれている。分離領域７１３と重なる位置に分離線（ダイシングライン、ともいう）７１４が設定される。分離線７１４に沿って基板７１１を切断することで、回路領域７１２を含むチップ７１５を基板７１１から切り出すことができる。図１８Ｂにチップ７１５の拡大図を示す。

【０３９５】

また、分離領域７１３に導電層や半導体層を設けてもよい。分離領域７１３に導電層や半導体層を設けることで、ダイシング工程時に生じうるＥＳＤを緩和し、ダイシング工程の歩留まり低下を防ぐことができる。また、一般にダイシング工程は、基板の冷却、削りくずの除去、帯電防止などを目的として、炭酸ガスなどを溶解させて比抵抗を下げた純水を切削部に流しながら行なわれる。分離領域７１３に導電層や半導体層を設けることで、当該純水の使用量を削減することができる。よって、半導体装置の生産コストを低減することができる。また、半導体装置の生産性を高めることができる。

【０３９６】

分離領域７１３に設ける半導体層としては、バンドギャップが２．５ｅＶ以上４．２ｅＶ以下、好ましくは２．７ｅＶ以上３．５ｅＶ以下の材料を用いることが好ましい。このような材料を用いると、蓄積された電荷をゆっくりと放電することができるため、ＥＳＤによる電荷の急激な移動が抑えられ、静電破壊を生じにくくすることができる。

【０３９７】

〔電子部品〕

チップ７１５を電子部品に適用する例について、図１９Ａおよび図１９Ｂを用いて説明する。なお、電子部品は、半導体パッケージ、またはＩＣ用パッケージともいう。電子部品は、端子取り出し方向や、端子の形状に応じて、複数の規格や名称が存在する。

【０３９８】

電子部品は、組み立て工程（後工程）において、上記実施の形態に示した半導体装置と該半導体装置以外の部品が組み合わされて完成する。

【０３９９】

図１９Ａに示すフローチャートを用いて、後工程について説明する。前工程において上記実施の形態に示した半導体装置を有する素子基板が完成した後、該素子基板の裏面（半導体装置などが形成されていない面）を研削する「裏面研削工程」を行なう（ステップＳ７２１）。研削により素子基板を薄くすることで、素子基板の反りなどを低減し、電子部品の小型化を図ることができる。

【０４００】

次に、素子基板を複数のチップ（チップ７１５）に分離する「ダイシング工程」を行う（ステップＳ７２２）。そして、分離したチップを個々ピックアップしてリードフレーム上に接合する「ダイボンディング工程」を行う（ステップＳ７２３）。ダイボンディング工程におけるチップとリードフレームとの接合は、樹脂による接合や、テープによる接合など、適宜製品に応じて適した方法を選択する。なお、リードフレームに代えてインターポザ基板上にチップを接合してもよい。

【０４０１】

次いで、リードフレームのリードとチップ上の電極とを、金属の細線（ワイヤー）で電気

10

20

30

40

50

的に接続する「ワイヤーボンディング工程」を行う（ステップＳ７２４）。金属の細線には、銀線や金線を用いることができる。また、ワイヤーボンディングは、ボールボンディングや、ウェッジボンディングを用いることができる。

【０４０２】

ワイヤーボンディングされたチップは、エポキシ樹脂などで封止される「封止工程（モールド工程）」が施される（ステップＳ７２５）。封止工程を行うことで電子部品の内部が樹脂で充填され、チップに内蔵される回路部やチップとリードを接続するワイヤーを機械的な外力から保護することができ、また水分や埃による特性の劣化（信頼性の低下）を低減することができる。

【０４０３】

次いで、リードフレームのリードをめっき処理する「リードめっき工程」を行なう（ステップＳ７２６）。めっき処理によりリードの錆を防止し、後にプリント基板に実装する際のはんだ付けをより確実に行うことができる。次いで、リードを切断および成形加工する「成形工程」を行なう（ステップＳ７２７）。

【０４０４】

次いで、パッケージの表面に印字処理（マーキング）を施す「マーキング工程」を行なう（ステップＳ７２８）。そして外観形状の良否や動作不良の有無などを調べる「検査工程」（ステップＳ７２９）を経て、電子部品が完成する。

【０４０５】

また、完成した電子部品の斜視模式図を図１９Ｂに示す。図１９Ｂでは、電子部品の一例として、ＱＦＰ（Ｑｕａｄ Ｆｌａｔ Ｐａｃｋａｇｅ）の斜視模式図を示している。図１９Ｂに示す電子部品７５０は、リード７５５および半導体装置７５３を示している。半導体装置７５３としては、上記実施の形態に示した半導体装置などを用いることができる。

【０４０６】

図１９Ｂに示す電子部品７５０は、例えばプリント基板７５２に実装される。このような電子部品７５０が複数組み合わせられて、それぞれがプリント基板７５２上で電氣的に接続されることで電子部品が実装された基板（実装基板７５４）が完成する。完成した実装基板７５４は、電子機器などに用いられる。

【０４０７】

〔電子機器〕

次に、本発明の一形態に係わる半導体装置１００または上記電子部品を備えた電子機器の例について、図２０Ａ、図２０Ｂ、図２１Ａ、および図２１Ｂを用いて説明を行う。

【０４０８】

図２０Ａは、カメラの例である。カメラ１８２０は、筐体１８２１、表示部１８２２、操作ボタン１８２３、シャッターボタン１８２４等を有する。また、カメラ１８２０には、着脱可能なレンズ１８２６が取り付けられている。

【０４０９】

ここではカメラ１８２０として、レンズ１８２６を筐体１８２１から取り外して交換することが可能な構成としたが、レンズ１８２６と筐体１８２１が一体となってもよい。

【０４１０】

カメラ１８２０は、シャッターボタン１８２４を押すことにより、静止画、または動画を撮像することができる。また、表示部１８２２はタッチセンサとしての機能を有し、表示部１８２２をタッチすることにより撮像することも可能である。

【０４１１】

なお、カメラ１８２０は、ストロボ装置や、ビューファインダーなどを別途装着することができる。または、これらが筐体１８２１に組み込まれていてもよい。

【０４１２】

図２０Ｂは、表示部１８２２を拡大した図である。表示部１８２２には、カメラ１８２０が撮像した静止画、動画、または、カメラ１８２０がレンズ１８２６を通して現在撮像している画像等を表示することができる。

10

20

30

40

50

【0413】

図20Bに示す表示部1822には、うさぎ1828と、女性1829が表示されている。カメラ1820に搭載されている半導体装置100は、画像認識を行い、うさぎ1828と女性1829の周りに認識した物体を区別する枠を表示し（図中、点線で枠を表示）、物体が何であるかを説明する表示を行うことができる（図中、それぞれ、「Rabbit」、「Woman」と表示）。

【0414】

図21Aは、情報端末の例である。情報端末1840は、表示部1841等を有する。表示部1841には、タッチセンサが配置されており、表示部1841は入力部としての機能も備えている。

【0415】

情報端末1840に搭載されている半導体装置100は、表示部1841に入力された文字を認識し、認識結果を表示することができる。図21Aは、使用者が指でアルファベットの「a」を入力し、半導体装置100が入力された文字を認識し、表示部1841の左上に認識結果を表示する例を示している。なお、表示部1841における文字の入力は、指だけでなく、スタイラス等を用いて行うこともできる。

【0416】

図21Bは、ロボットの例である。ロボット1860は、演算装置1870、照度センサ1861、マイクロフォン1862、上部カメラ1863、スピーカ1864、ディスプレイ1865、下部カメラ1866、障害物センサ1867、および移動機構1868等を備える。演算装置1870には、半導体装置100が搭載されている。

【0417】

マイクロフォン1862は、使用者の話し声および環境音等を検知する機能を有する。また、スピーカ1864は、音声を発する機能を有する。ロボット1860は、マイクロフォン1862およびスピーカ1864を用いて、使用者とコミュニケーションをとることが可能である。

【0418】

ディスプレイ1865は、種々の情報を表示する機能を有する。ロボット1860は、使用者の希望する情報をディスプレイ1865に表示することが可能である。ディスプレイ1865は、タッチセンサを搭載していてもよい。また、ディスプレイ1865は取り外しのできる情報端末等であっても良く、ロボット1860の定位置に設置することで、充電およびデータの受け渡しを可能とすることができる。

【0419】

上部カメラ1863および下部カメラ1866は、ロボット1860の周囲を撮像する機能を有する。また、障害物センサ1867は、移動機構1868を用いてロボット1860が移動する際、進行方向における障害物の有無を検知することができる。

【0420】

演算装置1870に搭載された半導体装置100は、上部カメラ1863および下部カメラ1866が撮像した画像を解析し、壁、家具、段差、または落下物などの障害物の有無を判断することができる。

【0421】

また、演算装置1870に搭載された半導体装置100は、上部カメラ1863および下部カメラ1866が撮像した画像から、ロボット1860の使用者を認識し、ロボット1860の使用者の方向へ移動することができる。または、ロボット1860の使用者が移動するにしたがって、使用者についていくことができる。

【0422】

図20A、図21A、および図21Bに示す電子機器には、上記実施の形態で説明した半導体装置100を搭載することで、効率的に画像認識を行うことができる。

【0423】

なお、本実施の形態は、本明細書に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせる

10

20

30

40

50

ことができる。

【符号の説明】

【0424】

A：データ信号、B：データ信号、BL：配線、CX：配線、DA：配線、DB：配線、DX：配線、F：フィルタ、MAC：回路、MEM：回路、N1：ノード、P：画像データ、PC：配線、RD：配線、REF：配線、SUB：半導体基板、VD：配線、VDD：高電源電位、VS：配線、VSS：低電源電位、W：データ信号、WL：配線、WO：配線、WS：配線、WT：配線、X：データ信号、10：積和演算ユニット、11：メモリセル、12：プリチャージ回路、13：デコード回路、14：レジスタ回路、15：回路、16：乗算回路、17：加算回路、18：レジスタ回路、21：トランジスタ、22：トランジスタ、23：トランジスタ、24：容量、25：トランジスタ、41：インバータ、42：インバータ、43：インバータ、44：トランジスタ、45：トランジスタ、46：トランジスタ、47：トランジスタ、50：領域、100：半導体装置、101：層、102：層、111：ワード線ドライバ回路、112：ビット線ドライバ回路、113：積和演算ブロック、300：トランジスタ、311：基板、313：半導体領域、314a：低抵抗領域、314b：低抵抗領域、315：絶縁体、316：導電体、320：絶縁体、322：絶縁体、324：絶縁体、326：絶縁体、328：導電体、330：導電体、350：絶縁体、352：絶縁体、354：絶縁体、356：導電体、360：絶縁体、362：絶縁体、364：絶縁体、366：導電体、370：絶縁体、372：絶縁体、374：絶縁体、376：導電体、380：絶縁体、382：絶縁体、384：絶縁体、386：導電体、402：絶縁体、404：絶縁体、500：トランジスタ、503：導電体、503a：導電体、503b：導電体、505：導電体、505a：導電体、505b：導電体、510：絶縁体、510A：トランジスタ、510B：トランジスタ、510C：トランジスタ、510D：トランジスタ、510E：トランジスタ、510F：トランジスタ、510G：トランジスタ、511：絶縁体、512：絶縁体、514：絶縁体、516：絶縁体、518：導電体、520：絶縁体、521：絶縁体、522：絶縁体、524：絶縁体、530：酸化物、530a：酸化物、530b：酸化物、530c：酸化物、530c1：酸化物、530c2：酸化物、531：領域、531a：領域、531b：領域、540a：導電体、540b：導電体、542：導電体、542a：導電体、542b：導電体、543：領域、543a：領域、543b：領域、544：絶縁体、545：絶縁体、546：導電体、546a：導電体、546b：導電体、547：導電体、547a：導電体、547b：導電体、548：導電体、550：絶縁体、551：絶縁体、552：金属酸化物、560：導電体、560a：導電体、560b：導電体、570：絶縁体、571：絶縁体、573：絶縁体、574：絶縁体、575：絶縁体、576：絶縁体、576a：絶縁体、576b：絶縁体、580：絶縁体、581：絶縁体、582：絶縁体、584：絶縁体、586：絶縁体、600：容量素子、610：導電体、612：導電体、620：導電体、630：絶縁体、650：絶縁体、711：基板、712：回路領域、713：分離領域、714：分離線、715：チップ、750：電子部品、752：プリント基板、753：半導体装置、754：実装基板、755：リード、1820：カメラ、1821：筐体、1822：表示部、1823：操作ボタン、1824：シャッターボタン、1826：レンズ、1829：女性、1840：情報端末、1841：表示部、1860：ロボット、1861：照度センサ、1862：マイクロフォン、1863：上部カメラ、1864：スピーカ、1865：ディスプレイ、1866：下部カメラ、1867：障害物センサ、1868：移動機構、1870：演算装置

10

20

30

40

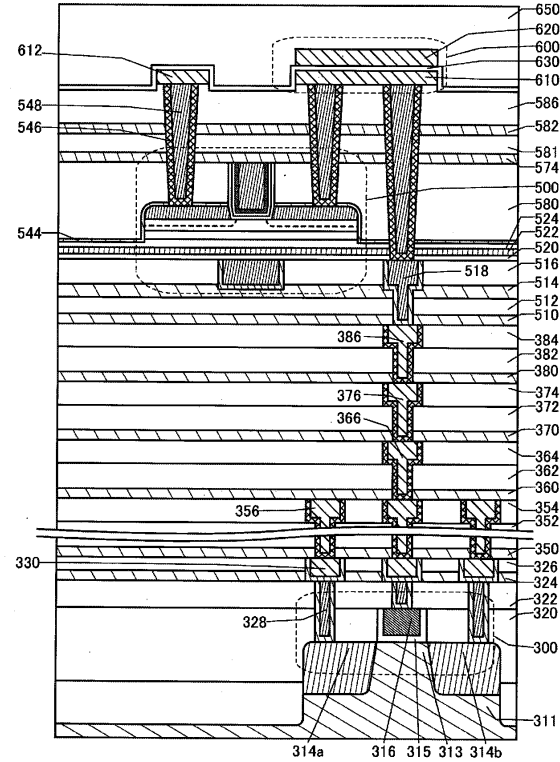
【 図 5 C 】

図5C

F(1,1)	F(1,2)	F(1,v-1)	F(1,v)
F(2,1)	F(2,2)		F(2,v-1)	F(2,v)
⋮			⋮	
F(u-1,1)	F(u-1,2)		F(u-1,v-1)	F(u-1,v)
F(u,1)	F(u,2)	F(u,v-1)	F(u,v)

【 図 6 】

図6

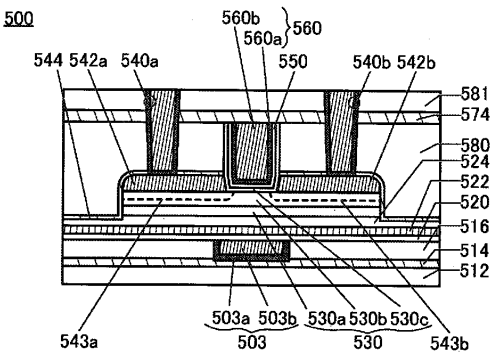


10

20

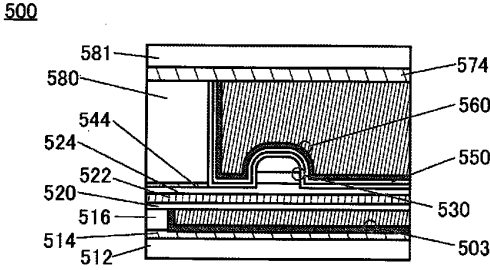
【 図 7 A 】

図7A



【 図 7 B 】

図7B



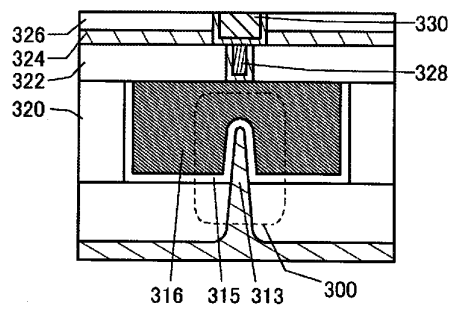
30

40

50

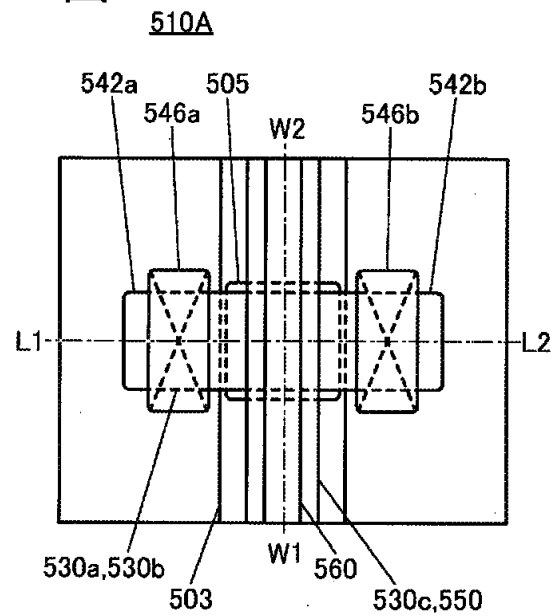
【図 7 C】

図7C



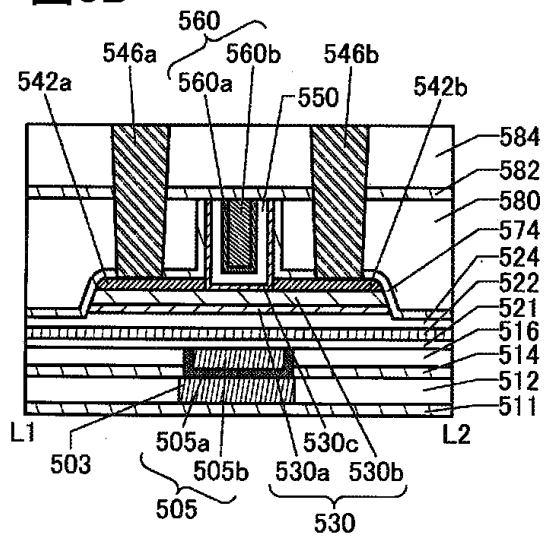
【図 8 A】

図8A



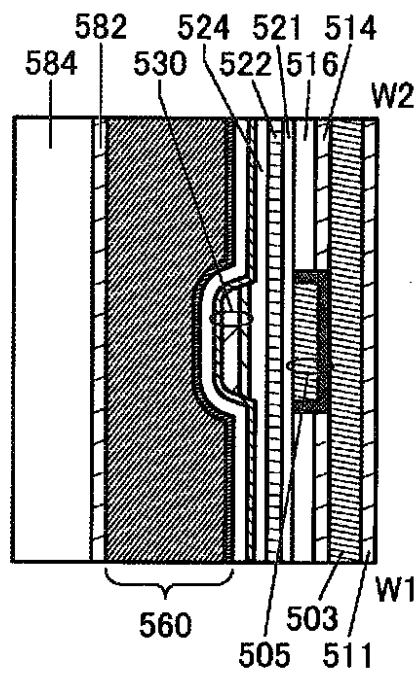
【図 8 B】

図8B



【図 8 C】

図8C



10

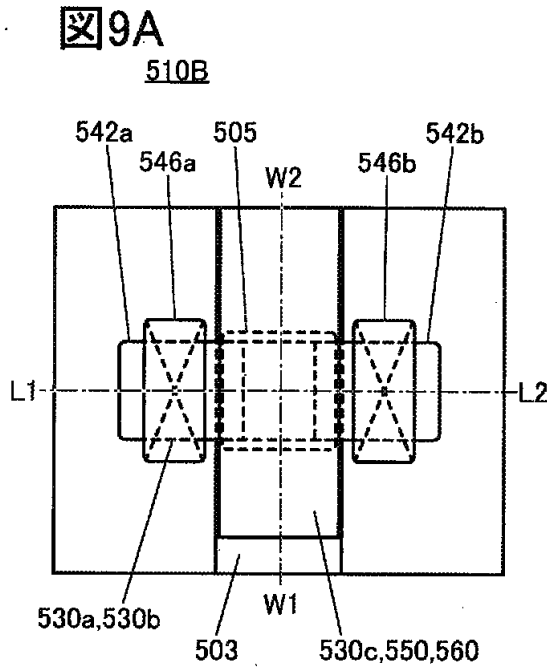
20

30

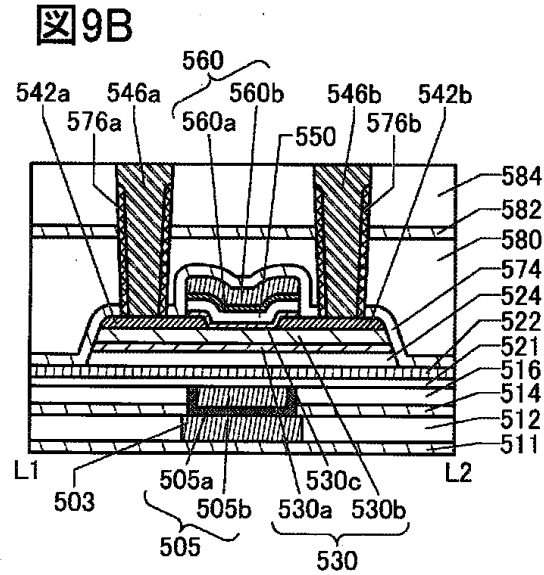
40

50

【図 9 A】



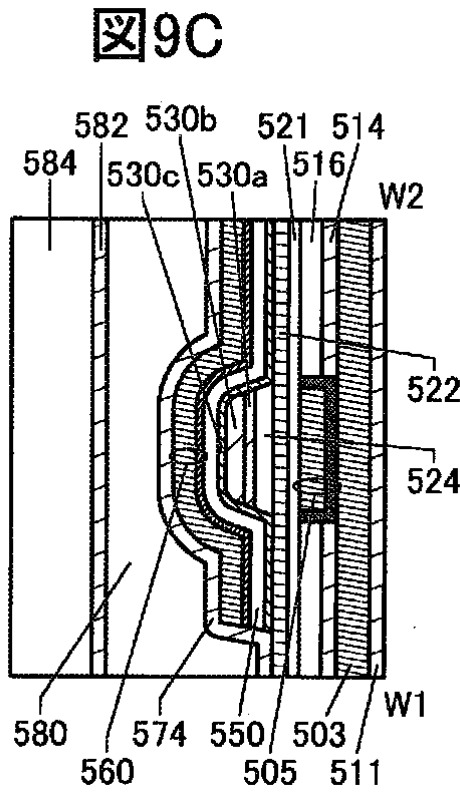
【図 9 B】



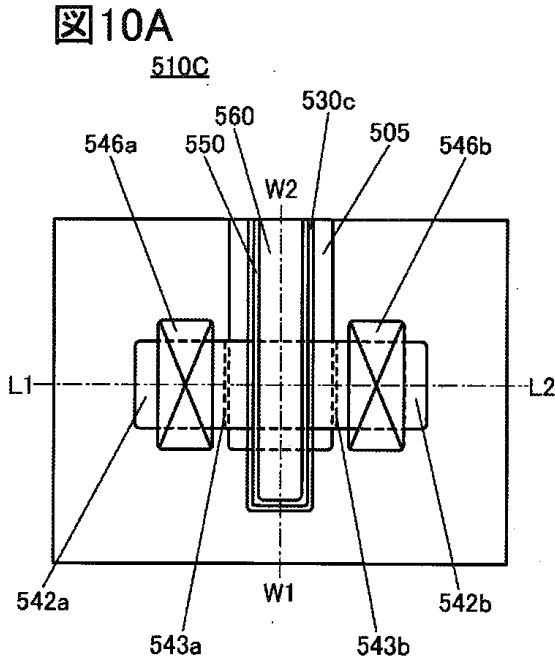
10

20

【図 9 C】



【図 10 A】

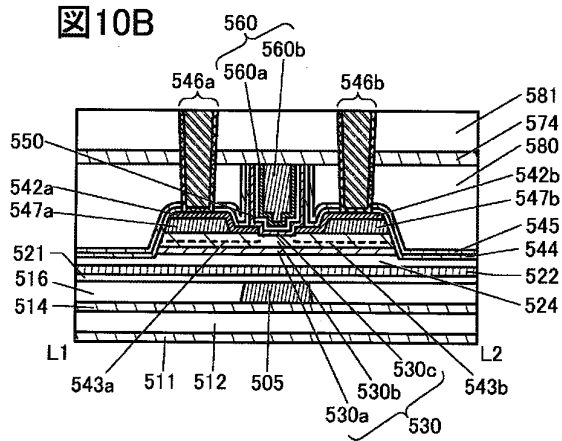


30

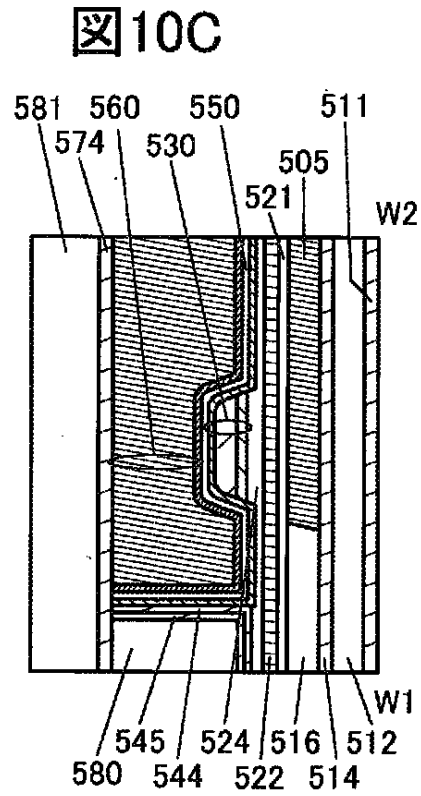
40

50

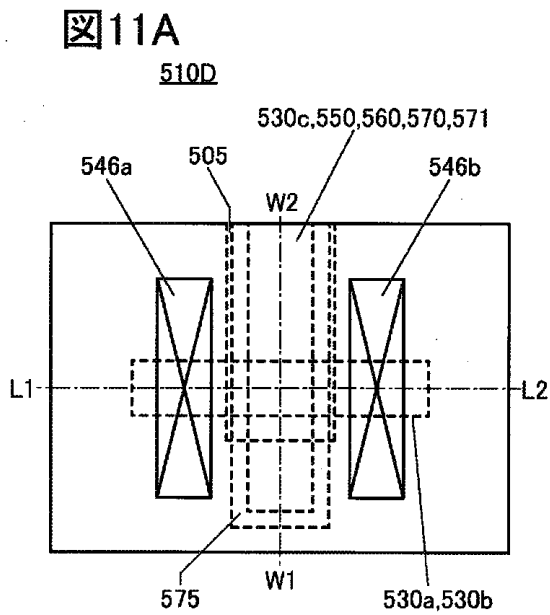
【図10B】



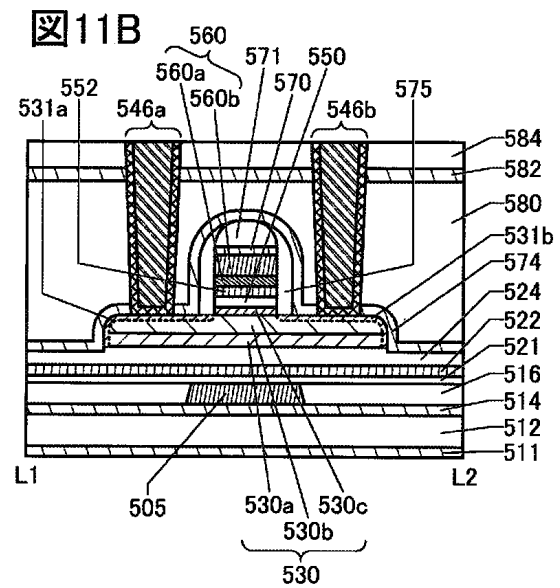
【図10C】



【図11A】



【図11B】



10

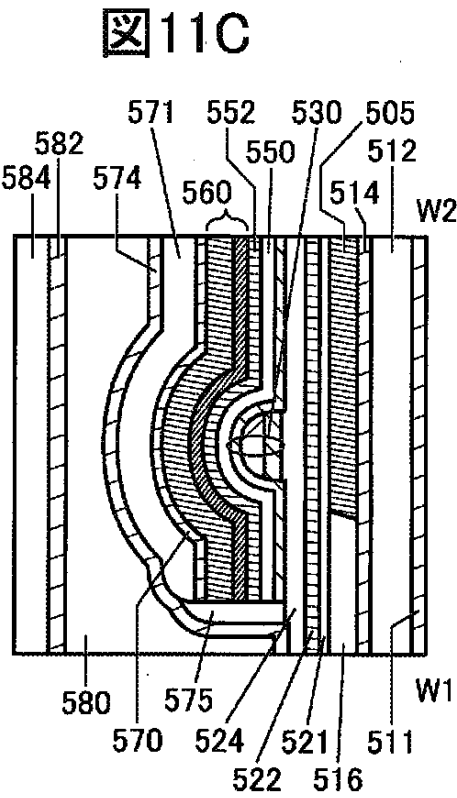
20

30

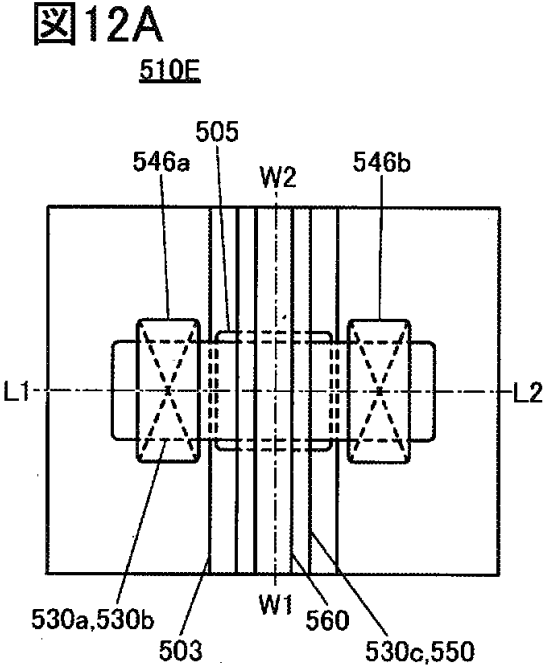
40

50

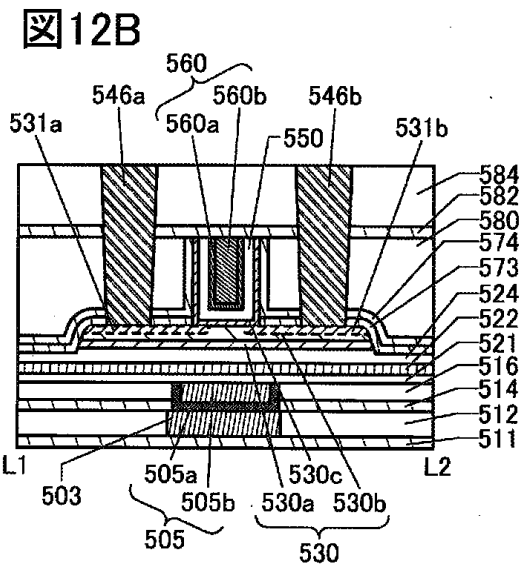
【図11C】



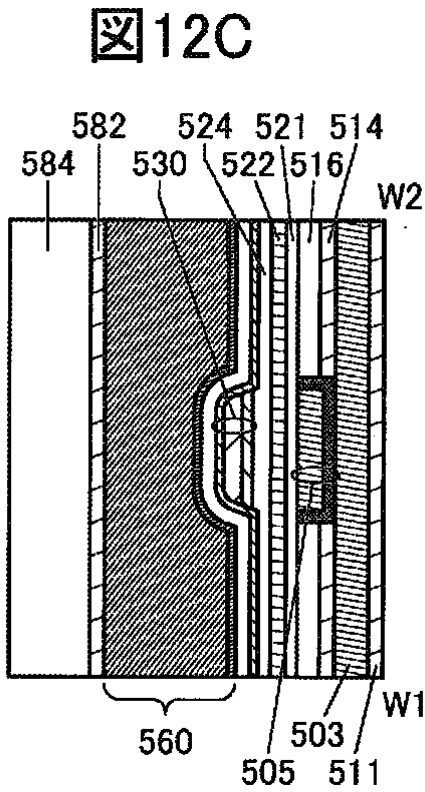
【図12A】



【図12B】



【図12C】



10

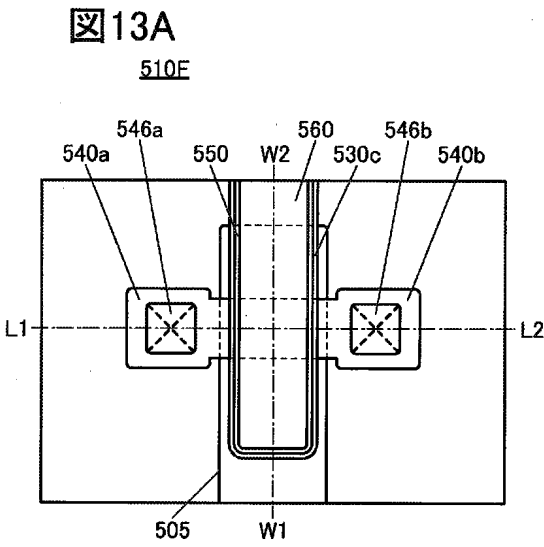
20

30

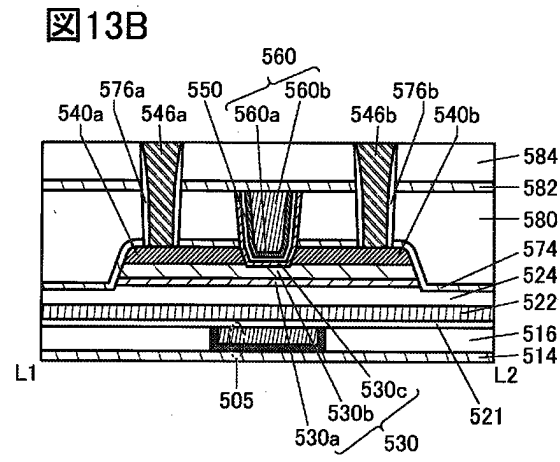
40

50

【図 1 3 A】

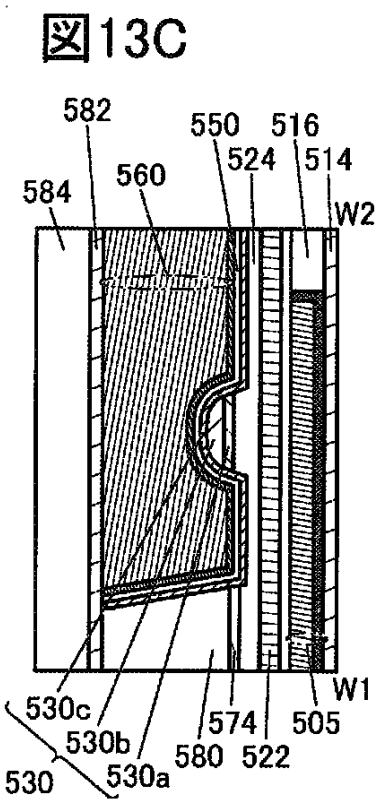


【図 1 3 B】

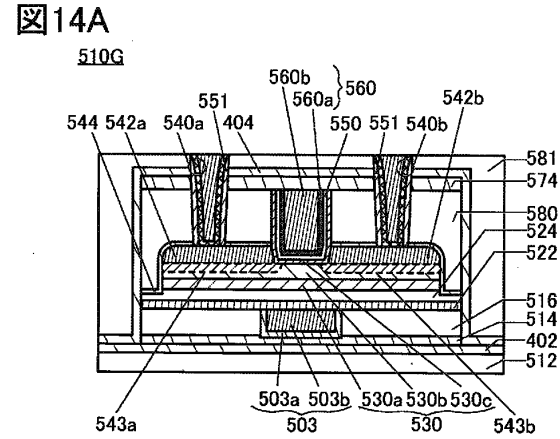


10

【図 1 3 C】



【図 1 4 A】



20

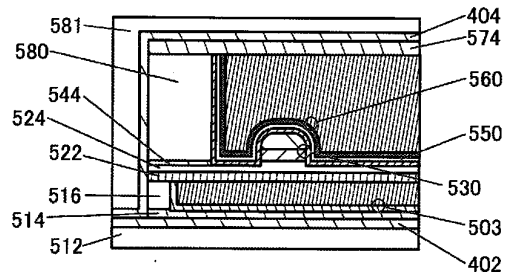
30

40

50

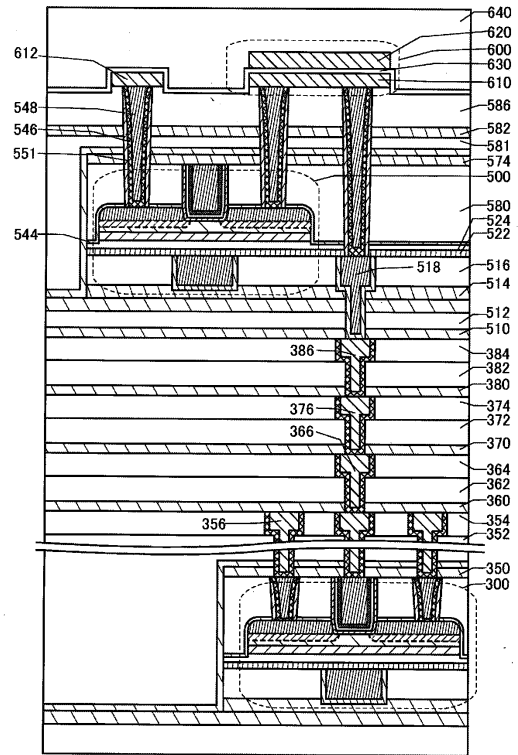
【図14B】

図14B



【図15】

図15

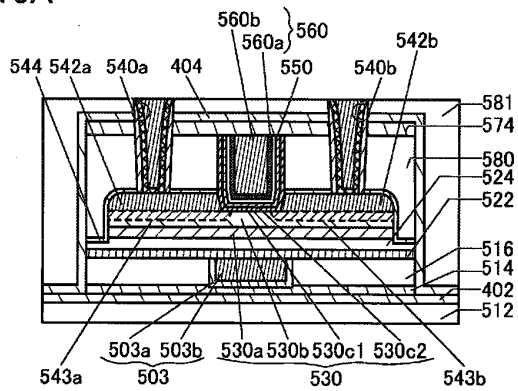


10

20

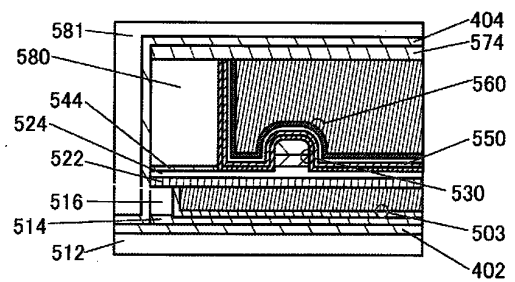
【図16A】

図16A



【図16B】

図16B



30

40

50

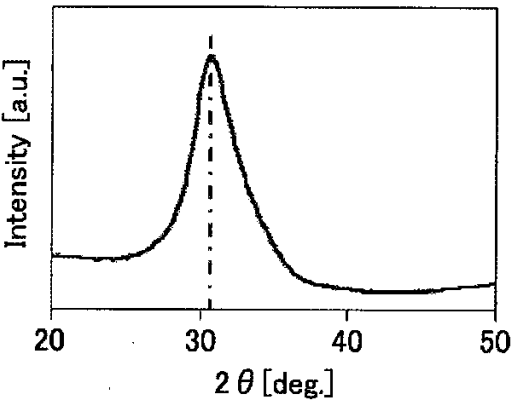
【図 17 A】

図17A

中間状態 新しい境界領域		
Amorphous (無定形)	Crystalline (結晶性)	Crystal (結晶)
•completely amorphous	•CAAC •nc •CAC	•single crystal •poly crystal

【図 17 B】

図17B



10

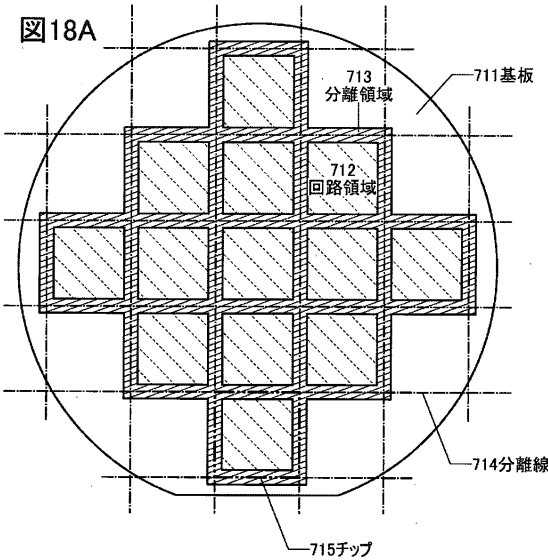
【図 17 C】

図17C



【図 18 A】

図18A



20

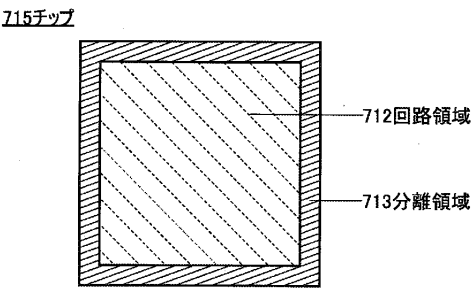
30

40

50

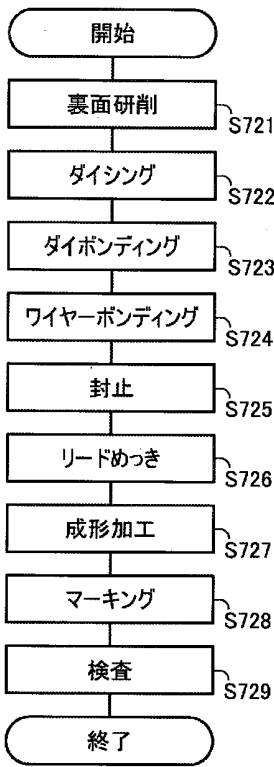
【図18B】

図18B



【図19A】

図19A

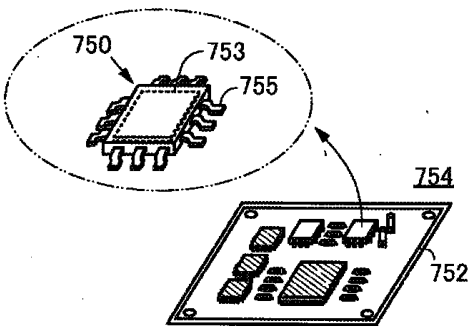


10

20

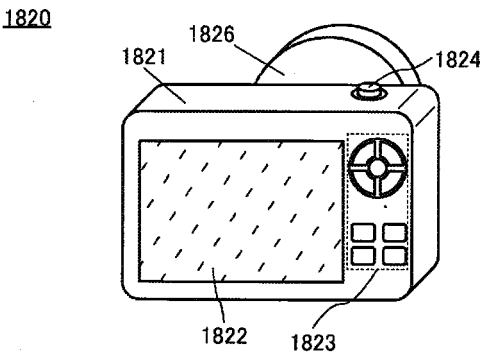
【図19B】

図19B



【図20A】

図20A



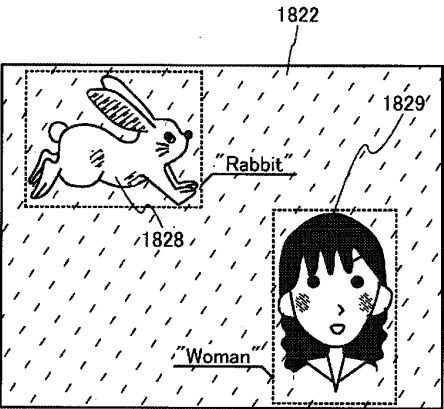
30

40

50

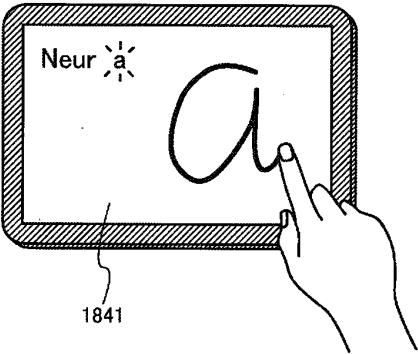
【図 20 B】

図20B



【図 21 A】

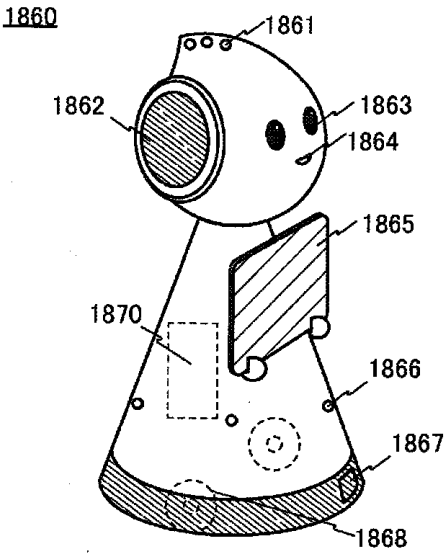
図21A
1840



10

【図 21 B】

図21B



20

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類	F I		
	H 1 0 D	86/40	1 0 1 B
	H 1 0 D	86/60	B

審査官 宮本 博司

- (56)参考文献 国際公開第 2 0 1 8 / 1 8 9 6 2 0 (W O , A 1)
特開 2 0 1 9 - 0 4 7 0 0 6 (J P , A)
特開平 1 1 - 0 8 8 1 4 2 (J P , A)
特開平 0 4 - 3 6 8 6 9 2 (J P , A)
特開 2 0 1 9 - 0 3 6 2 8 0 (J P , A)
特開 2 0 1 5 - 1 6 5 4 4 7 (J P , A)

- (58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)
H 1 0 B 1 2 / 0 0
H 1 0 B 4 1 / 7 0
H 1 0 D 8 6 / 4 0
H 1 0 D 8 6 / 6 0